修士論文

人工衛星搭載用 ガンマ線偏光検出器の開発

金沢大学大学院 自然科学研究科 数物科学専攻 Ⅲ コース 宇宙物理学研究室 博士前期課程

指導教官 村上 敏夫

青山 有加 学籍番号 0613011002

2008年1月31日

概要

ガンマ線バースト (Gamma-Ray Burst:GRB) は、非常に短い時間変動を伴う ガンマ線が、宇宙の遠方から数 10 msec-数 100 sec の短時間に突発的に飛来する 天体現象である。この現象は1日に約1回等方的に検出されており、1回の総エ ネルギーは 10⁵² erg にも達する。これは超新星爆発時における電磁波の総エネル ギーが 10⁴⁸ erg 程度であることと比べても桁違いに大きく、ビッグバンを除けば 宇宙で最大の爆発現象であると考えられている。

現在、GRB を記述する理論モデルとしては、相対論的火の玉モデル (Fireball Model) がある。このモデルでは、大質量星が崩壊してブラックホールを形成する 際に高速なジェットを形成し、ローレンツ因子にして $\gamma \sim 100$ のような相対論的 速度を持つ物質流が生成される。その後、物質流同士、または物質流と星間物質と の衝突によって作られた衝撃波中でフェルミ加速された電子が、衝突によって生成 された磁場に巻きつき、シンクロトロン放射で明るく輝くというものである。しか し、これは理論モデルであり、観測的には検証されていない。シンクロトロン放射 による電磁波は、磁場に対して垂直に偏光しているため、磁場が揃っていれば偏光 観測により Fireball Model が検証される可能性がある。また、短時間に生成され た、衝撃波に巻きつく磁場が存在し、逆コンプトン散乱によって放射されていると 考える場合でも、ジェットの軸に対する観測角度の非対称性によってランダムな磁 場中でも強い偏光が観測される可能性がある。我々の研究目的は、GRB の偏光観 測を行うことによって、GRB の磁場構造、放射機構を解明することである。

GRB の偏光観測を行う場合、ガンマ線は大気の影響で地上には届かないため、 宇宙空間での観測が必要になる。そこで、人工衛星に搭載するための偏光検出器の 開発を行う。我々が開発を行っている偏光検出器は2010年5月に打ち上げ予定の ソーラー電力セイル実証機に搭載されることが決定した。

昨年度試作した偏光検出器の軽量化と性能向上を目標とし、新しく偏光検出器の 設計、試作を行った。新しいモデルではGRBが50%偏光していれば、1年間に2 個のGRBに対して偏光観測が期待される。また、X線発生装置を使用した偏光測 定実験により、実際に正しく偏光検出を行うことができた。

衛星搭載モデルでは、打ち上げ時の振動に耐えられる検出器設計と、衛星が確実 に運用される6ヶ月間に偏光観測が可能な検出器の性能が求められる。ソーラー電 カセイル実証機搭載用のプリフライトモデルとして耐震化に主眼を置き、重量制限 の3.2 kg で検出器の再考を行った。GRB が40% 偏光していれば1年間に2個、 70% で4個の偏光観測が期待される検出器について示す。

目次

概要		i
第1章	はじめに	1
第2章	ガンマ線バースト	3
2.1	ガンマ線バースト	3
2.2	起源.....................................	3
2.3	時間変動と継続時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.4	スペクトル	4
2.5	残光.....................................	6
2.6	相対論的火の玉モデル (Fireball Model)	8
2.7	偏光....................................	9
	2.7.1 強磁場による偏光	10
	2.7.2 幾何学的な偏光	11
2.8	研究目的	13
第3章	偏光	15
3.1	偏光....................................	15
3.2	偏光基礎過程	15
	3.2.1 制動放射	15
		10
	3.2.2 シンクロトロン放射	16
	 3.2.2 シンクロトロン放射	16 19
	 3.2.2 シンクロトロン放射	16 19 22
	 3.2.2 シンクロトロン放射	16 19 22 22
	3.2.2 シンクロトロン放射	16 19 22 22 23
3.3	 3.2.2 シンクロトロン放射	16 19 22 22 23 23
3.3	3.2.2 シンクロトロン放射	 16 19 22 22 23 23 23
3.3	 3.2.2 シンクロトロン放射 3.2.3 コンプトン散乱 3.2.4 逆コンプトン散乱 3.2.5 光電効果 3.2.6 ブラッグ反射 デ宙における偏光光源 3.3.1 パルサー星雲型超新星残骸 (SNR) 3.3.2 活動銀河核 (AGN) 	 16 19 22 23 23 23 24
3.3	 3.2.2 シンクロトロン放射 3.2.3 コンプトン散乱 3.2.4 逆コンプトン散乱 3.2.5 光電効果 3.2.6 ブラッグ反射 デ宙における偏光光源 3.3.1 パルサー星雲型超新星残骸 (SNR) 3.3.2 活動銀河核 (AGN) 3.3.3 X線パルサー 	 16 16 19 22 23 23 23 24 24
3.3	 3.2.2 シンクロトロン放射 3.2.3 コンプトン散乱 3.2.4 逆コンプトン散乱 3.2.5 光電効果 3.2.6 ブラッグ反射 デ宙における偏光光源 3.3.1 パルサー星雲型超新星残骸 (SNR) 3.3.2 活動銀河核 (AGN) 3.3.3 X線パルサー 3.3.4 低質量 X線連星系 (LMXB) 降着円盤 	 16 19 22 23 23 23 24 24 25

3.4	過去の)偏光観測..................................			
3.5	偏光観測計画				
3.6	偏光検	出方法			
	3.6.1	反射型検出器			
	3.6.2	光電子追跡型検出器			
	3.6.3	散乱型検出器			
	3.6.4	GRB の偏光検出方法			
3.7	偏光検	出器の性能			
	3.7.1	モジュレーションファクタ M			
	3.7.2	検出効率 η			
	3.7.3	最小偏光度 (MDP)			
3.8	シンチ	レーション検出器			
	3.8.1	シンチレータ			
	3.8.2	光電子増倍管 (PMT)			
	3.8.3	応答関数.................................			
第4章	偏光検				
4.1	これま				
	4.1.1	旧偏光検出器モデル..............................			
	4.1.2	R1840-15 の検出限界エネルギー			
	4.1.3	CsI(Tl) のエネルギー分解能			
	4.1.4	X 線発生装置を使った偏光測定			
	4.1.5	課題			
4.2	検出器	モデルの見直し			
4.3	EGS S	シミュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
4.4	プラス	、チックシンチレータの形状評価.........................			
	4.4.1	平均自由行程			
	4.4.2	シミュレーションによる η			
	4.4.3	シミュレーションによる M			
	4.4.4	$M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$			
	4.4.5	集光効率と検出限界エネルギー			
	4.4.6	まとめ			
4.5	ライト	ガイドの効果			
	4.5.1	CsI(Tl) とライトガイド			
	4.5.2	セットアップ			
	4.5.3	結果			
	4.5.4	ライトガイドの必要性...........................			
4.6	回路基	板とケースの改良			
	4.6.1	表面実装部品を使用した回路基板.....................			
	4.6.2	アルミケース			

4.7	軽量化
4.8	VA-TA
	4.8.1 信号処理システム 55
4.9	コインシデンス
4.10	プラスチック用 PMT R1840-12s の検出限界エネルギー
	4.10.1 セットアップ 57
	4.10.2 結果
4.11	CsI(Tl) 用 PMT R7400p の検出限界エネルギー
	4.11.1 セットアップ 59
	4.11.2 結果
4.12	エネルギー 較正
	4.12.1 リニアリティ 61
	4.12.2 問題点と改善方法 61
4.13	GRB 検出可能性
	4.13.1 バックグランドの見積り 63
	4.13.2 MDP
~~	
第5章	偏光検出性能の評価 67
5.1	
	5.1.1 セットアップ 67
	$5.1.2$ 結果 \ldots 6%
-	
5.2	X線発生装置とビームライン 69 A 69
	5.2.1 X 線発生装直 69
	5.2.2 $E = \Delta 7 1 \mathcal{Y}$
	5.2.3 $X < 7 F \mu$
F 0	5.2.4 偏光度
5.3	
	5.3.1 セットアップ 73 た 2.2 4日
	b.3.2 結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F 4	0.3.3 [L牧
5.4	科の八別での偏九測定美験
	0.4.1 ビッドアツノ 75 5.4.9 社田
	0.4.2
	0.4.3 ンミュレーンヨノによる方祭 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第6章	小型衛星搭載用偏光検出器の設計検討 81
6.1	小型ソーラー電力セイル実証機81
6.2	GAP の概略
	6.2.1 検出器本体

v

	6.2.2 回路部	84
6.3	GAP の性能	85
	6.3.1 シミュレーションによる性能比較	85
	6.3.2 GRB の検出可能性	86
6.4	プラスチックシンチレータ用 PMT	86
	6.4.1 R1840-12sとR6041のカタログ性能	86
	6.4.2 検出限界エネルギー	88
6.5	信号処理	89
	6.5.1 信号処理システム	89
	6.5.2 トリガーレートの見積り	90
	6.5.3 VA-TA システムと NIM システムの性能比較	94
6.6	PMT とシンチレータの接着	95
	6.6.1 接着剤	95
	6.6.2 プラスチックの接着	96
	6.6.3 CsI(Tl)の接着	97
	6.6.4 まとめ	98
6.7	高圧電源	98
第7章	まとめと今後の課題	99
7.1	プラスチックシンチレータの改良について	99
7.2	軽量化について................................	99
7.3	$\operatorname{CsI}(\operatorname{Tl})$ シンチレータのエネルギー分解能 \ldots	100
7.4	斜め入射の補正..................................	100
7.5	鉛シールド	100
7.6	ソーラー電力セイル実証機搭載に向けて...............	101
/→☆╕ ヘ		100
		103
A.1		105
A.Z		105
付録 B	フェルミ加速	107
(낙석키)	左執五珪に接山思っ姓代	111
		111
C.1	シミュレーションによる快祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
付録 D	検出効率	113
D.1	質量吸収係数	113
D.2		114
_ • =		
付録 E	散乱位置検出型検出器による M	115
付録 F	Csl(Tl) のスペクトル補正	117

謝辞		121
F.2	補正した場合....................................	119
F.1	補正しない場合...................................	118

vii

第1章

はじめに

ガンマ線バースト (Gamma-Ray Burst : GRB) は、非常に短い時間変動を伴うガンマ線が、 宇宙の遠方から数 10 msec-数 100 sec の短時間に突発的に飛来する天体現象である。この現 象は1日に約1回等方的に検出されており、その総エネルギーは 10^{52} erg にも達する。これ は超新星爆発時における電磁波の総エネルギーが 10^{48} erg 程度であることと比べても桁違い に大きく、ビッグバンを除けば宇宙で最大の爆発現象であると考えられている。GRB は宇宙 の遠方、つまり初期宇宙で起きていること、エネルギーが非常に大きいことから遠方の観測が 可能で、初期宇宙の探索に用いることができる。すばる望遠鏡による 133 億年前 (z=6.3) の GRB の発見は、GRB を用いた初期宇宙の探査という新たな領域を作り上げた。

これまでの研究により、GRB は星の死とブラックホールの誕生に関わる重要な現象である ことが明らかになり、その研究は、超新星爆発、高エネルギー天文学、初代天体、ダークエネ ルギーなど様々なテーマにまたがる巨大な分野に成長している。

現在、GRB を記述する理論モデルとして、相対論的火の玉モデル (Fireball Model) がある。 このモデルでは、大質量星が崩壊してブラックホールを形成する際に物質をジェット状に放出 し、ローレンツ因子にして $\gamma \sim 100$ のような相対論的速度を持つ物質流が生成される。その 後、物質流同士、または物質流と星間物質との衝突によって衝撃波が作られ、衝撃波中でフェ ルミ加速された電子が、衝突によって圧縮された磁場に巻きつき、シンクロトロン放射で明る く輝くというものである。一般的に、シンクロトロン放射による電磁波は、磁場に対して垂直 に偏光しているため、磁場が揃っていれば偏光が観測される可能性がある。

また、シンクロトロン放射よりも高い偏光度が期待される放射機構として、逆コンプトン散 乱によるモデルがある。このモデルでは、短時間に生成されて衝撃波に巻きつく磁場が存在 し、ジェットの軸に対する観測角度の非対称性によって偏光が作られるモデルである。ランダ ムな磁場中でも強い偏光が得られる可能性がある。特に、ジェットの開き角が狭い GRB につ いて、ジェットの端付近で高い偏光度が観測される可能性がある。

偏光観測が期待される理論モデルとして、強磁場によるものと、幾何学的配置によるものが存在する。実際に偏光観測を行うことによって、GRBの磁場構造、放射機構を解明することができると考えられる。我々の研究目的は、偏光観測を行うことによって、GRBの磁場構造、放射機構を解明することである。

GRBの偏光観測を行う場合、ガンマ線は大気の影響で地上には届かないため、宇宙空間での観測が必要になる。そこで、人工衛星に搭載するための偏光検出器の開発を行う。我々が開発を行っている偏光検出器は2010年5月に打ち上げ予定のソーラー電力セイル実証機に搭載されることが決定した。

ソーラー電力セイルは、光子の運動量を利用した推進と、電気推進機関を組み合わせて 航行する宇宙船である。小型ソーラー電力セイル実証機は、2010 年 5 月に H2A によって Planet-C との相乗りで打ち上げられ、約 200 日をかけて金星に近づく予定である。世界初の 「深宇宙空間での直径 20 m のソーラー電力セイルの展開」、「電力セイル機能の実証」、「光子 セイルの航行実証」を行う、重量 300 kg の探査機である。

計画されているミッションは、「大型薄膜の展開・展張」、「電力セイルからの集電」、「光子 セイルによる加速実証」、「光子セイルによる航行技術の獲得」、「理学観測」の5項目であり、 GRBの偏光検出器 (GAmma-ray burst Polarimeter : GAP) は、理学観測機器として搭載さ れる予定である。

我々は昨年度、目標重量 1.5 kg の偏光検出器を試作し、実験室に設置した X 線発生装置の 偏光度を測定することができた。しかし、このモデルでは、1.5 kg という重量を達成できず、 軽量化が課題となった。

衛星搭載モデルでは打ち上げ時の振動に耐えられる検出器設計を行う必要があり、許された 3.2 kg の重量制限内で、ソーラー電力セイル実証機搭載用のプリフライトモデルとして耐震化 に主眼を置いた、検出器設計の再考を行う。また、この衛星が確実に運用されるのは6ヶ月間 であるため、6ヶ月間で1個以上のGRBに対して偏光検出が可能な性能が求められる。

第1章以降では、第2章でガンマ線バースト、第3章では偏光について述べる。第4章で は、はじめに旧検出器の性能と昨年度の実験結果と課題を示す。その後、旧検出器からの性能 向上と軽量化を目標とした偏光検出器の改良について示す。第5章では実際に作成した新しい 検出器を使った偏光検出性能の評価について示す。第6章ではソーラー電力セイル実証機に搭 載するためのプリフライトモデルの設計検討を行う。第7章では、まとめと今後の課題につい て述べる。

第2章

ガンマ線バースト

2.1 ガンマ線バースト

ガンマ線バースト (Gamma-Ray Burst: GRB) は、非常に短い時間変動を伴うガンマ線が、 宇宙の遠方から数 10 msec-数 100 sec の短時間に突発的に飛来する天体現象である。この現 象は1日に約1回等方的に検出されており、その総エネルギーは 10⁵² erg にも達する。これ は超新星爆発時における電磁波の総エネルギーが 10⁴⁸ erg 程度であることと比べても桁違い に大きく、ビッグバンを除けば宇宙で最大の爆発現象であると考えられている。

GRB は 1967 年にアメリカの核実験監視衛星 Vela によって偶然発見された。当初は原因不 明であったため、軍事機密として扱われ発表されなかった。しかし、3 年間で 16 例もの現象 が、地球からではなく宇宙から検出されたこともあり、1973 年には GRB として公式に発表 された。その後の観測から GRB は宇宙の遠方、つまり初期宇宙で発生していること、等方的 な爆発ではなくジェット状に放出されていることなどが分かってきた。また、GRB の理論モ デルとして Fireball Model が提唱され、支持を得ている [1]。

2.2 起源

1991 年に打ち上げられた CGRO (Compton Gamma-Ray Observatory) 衛星には BATSE (Burst And Transient Source Experiment) と呼ばれる検出器が 8 台搭載されてい る。BATSE は NaI シンチレータを光電子増倍管 (Photo Multiplier Tube : PMT) で読み出 す検出器で、50-2000 keV に感度を持ち、8 台で全天の約 50% を覆う視野を確保し、9 年間 で 2704 個の GRB を観測した。その結果、GRB の発生方向は図 2.1 に示すように等方的で あることが分かった。もし、GRB が銀河系を起源とする現象であるなら、銀河面や銀河中心 の方向に偏った分布になるはずであるので、この結果は GRB の起源が宇宙の非常に遠方もし くは銀河系八ローにあることを示唆している。実際に、この後の残光観測により、GRB は遠 方宇宙の銀河内で起こっていることが示された [1]。



2704 BATSE Gamma-Ray Bursts

図 2.1 点は BATSE によって検出された全 2704 個の GRB 分布を示している。GRB が 我々の銀河で起こっている現象ならば、銀河面に集中した分布になるはずであるが、検出さ れた GRB は全天に等方的に分布している。つまり GRB は銀河系ハローか、遠方宇宙を起 源とするものであることが分かる。

2.3 時間変動と継続時間

GRB(プロンプト放射)のライトカーブ (フラックスの時間変動)を図 2.2 に示す。早い立ち 上がりと緩やかな立ち下がりは共通して見られるが、継続時間も時間変動も多種多様であるこ とが分かる。

GRB の継続時間と発生数の関係を図 2.3 に示す。BATSE の観測では、継続時間を T_{90} で 定義する。これは、GRB の 50–300 keV の光子について、全カウントの 90% が集まる時間で ある。継続時間に対する GRB の発生数は 2 sec を境に 2 つの分布があることが分かる。継続 時間が 2 sec より短いものはショートバースト、2 sec より長いものはロングバーストと呼ば れている [1]。

2.4 スペクトル

GRB のエネルギースペクトルは BATSE の観測から、式 2.1 のような折れ曲がったベキ関 数で表される [2]。

$$N(\nu) = N_0 \times (h\nu)^{\alpha} \exp\left(\frac{-h\nu}{E_0}\right) , \quad h\nu < (\alpha - \beta)E_0$$
(2.1)

$$= N_0 \times \{(\alpha - \beta)E_0\}^{(\alpha - \beta)}(h\nu)^\beta \exp(\beta - \alpha) , \quad h\nu > (\alpha - \beta)E_0 \qquad (2.2)$$



図 2.2 GRB ライトカーブの例。横軸に時間、縦軸に GRB のフラックスを取っている。 様々な時間変動、継続時間の GRB が存在する。共通して見られるのは早い立ち上がりと、 緩やかな立ち下がりである。



図 2.3 GRB の継続時間と発生数の関係。GRB は継続時間によって 2 つの種類に分けられる。継続時間が 2 sec より短いものはショートバースト、2 sec より長いものはロングバーストと呼ばれている。



図 2.4 GRB990123 のエネルギースペクトル。非熱的放射の特徴であるベキ関数で説明で きるため、GRB の放射機構はシンクロトロン放射であると考えられる。

ここで E_0 はブレイクエネルギー、 α (β) は低エネルギー (高エネルギー) のエネルギー光子指数である。熱平衡にある物体からの放射はマクスウェル分布 $\propto \exp(-h\nu/kT)$ に従う黒体放射となるが、GRB のスペクトルは式 2.1 で示されるように、ベキ関数の形をしている。つまり、GRB はシンクロトロン放射のような非熱的な放射であると考えられる。観測から、式 2.1 の係数は $\alpha \sim -1$ 、 $\beta \sim -2$ であること分かっている。特に β はどの GRB でもよく揃っている [1]。

2.5 残光

1973 年に打ち上げられた BeppoSAX 衛星は、どこで発生するか分からない GRB を、Wide Field Camera (WFC: 広視野カメラ) により数分角の精度で決め、GRB970228 に対しては、 発生から 8 時間後と 3.5 日後に X 線望遠鏡 (MECS、LECS) による観測を行った。それまで GRB は、発生後数十秒間だけ明るく輝く現象と考えられていたが、BeppoSAX は図 2.5 に示 すように GRB 発生後数日に渡って X 線で減光しながら輝き続ける X 線残光が存在すること を発見した。さらに、この GRB の X 線残光は可視光でも対応天体が観測され、地上の大型可 視光望遠鏡でも残光が観測された。

残光の発見以前は、継続時間が短いために GRB の研究は難しいものであった。しかし、残 光の発見により得られるデータが飛躍的に増え、GRB の発生機構の解明に大きな役割を果た した。



図 2.5 BeppoSAX 衛星により観測された GRB970228 の X 線残光。左は GRB 発生 8 時間後、右は 3.5 日後の観測である。時間とともに減光していることが分かる。



図 2.6 Keck-2 望遠鏡により観測された GRB970508 の可視光スペクトル。赤方偏移した マグネシウムと鉄の吸収線が 2 組見える。この結果から GRB の発生源が宇宙論的遠方で あることが分かった。

残光の発見により、GRB の発生場所を特定できるようになった。地上の Keck-2 望遠鏡に よる GRB970508 の可視残光の観測では、図 2.6 に示すように赤方偏移したマグネシウムと鉄 の吸収線が検出され、その赤方偏移からこの GRB が宇宙の始まりから約 7 億光年の距離に あることが分かった。これにより GRB の起源が宇宙論的遠方であることが示され、遠方宇宙 起源か銀河系八ロー起源かという論争に決着がつけられた。その後、距離が特定された全ての GRB は、我々の銀河系外で起こっていることが分かっている。また、いくつかの GRB では 母銀河が観測され、GRB は宇宙論的遠方の銀河内で起こっていることが分かっている [1]。

2.6 相対論的火の玉モデル (Fireball Model)



図 2.7 Fireball Model の概念図。 $\gamma \sim 100$ の相対論的 shell 同士の衝突により内部衝撃波 を作り、衝撃波によってフェルミ加速された電子が、衝突によって圧縮された磁場に巻き ついてシンクロトロン放射を起こし、GRB を発生する。その後合体したことにより速度が $\gamma \sim 10$ 程度に遅くなった shell が、星間物質 (ISM) をかき集めることで外部衝撃波を作り、 同じくシンクロトロン放射で残光現象 (afterglow) を発生している。

短い時間変動を伴う GRB(プロンプト放射) とそれに続いて減光する残光現象の過程を記述 する理論モデルとして、相対論的火の玉モデル (Fireball Model) がある。これはローレンツ 因子にして $\gamma \gg 1$ のような相対論的な速度を持つ物質流がつくり出す衝撃波によって、一連 の過程を説明するものである。

GRB の時間変動はとても短く、ミリ秒程度の GRB も観測されている。一般に発生源は、 $c\Delta t$ のスケールよりも小さいと考えるのが普通だが、これをそのまま当てはめると 300 km の領域に 10^{52} erg のガンマ線光子を押し込める必要がある。GRB のスペクトルでは MeV 以上の光子も観測されているが、コンパクトな領域に大量のガンマ線が閉じ込められると $\gamma\gamma \rightarrow e^+e^-$ の対生成反応でガンマ線は抜けられなくなってしまう。つまり、観測される GRB の非熱的放射を作ることはできなくなる。この問題をコンパクトネス問題と言う。ここで相対 論的衝撃波を仮定すると、放射された光子の放射源は相対論的速度で運動しているため、観 測される時間変動は相対論の効果で短く見えていることになる。放射源の大きさについても、 ローレンツ収縮によって見かけ上は小さな領域であるが、実際は大きくても構わないことになる。さらに、ガンマ線光子は青方偏移の効果で高いエネルギーに見えていることを考慮すれ ば、コンパクトネス問題は解決される。

図 2.7 に Fireball Model の概念図を示す。大質量星が崩壊してブラックホールを形成する 際に、相対論的速度のジェットを形成する。その中を伝搬する物質 (shell) 同士が衝突して内 部衝撃波を作り、衝撃波によってフェルミ加速された電子が、衝突により圧縮された磁場に巻 きつきシンクロトロン放射で輝くのが GRB(プロンプト放射) である。続いて1つに合体した shell が星間物質 (ISM) をかき集めて外部衝撃波を作り、同様にシンクロトロン放射で輝くの が残光現象であると解釈されている [3]。

2.7 偏光



図 2.8 RHESSI に搭載されているスペクトロメーター。9 個のゲルマニウム検出器から成 り、0.003-17 MeV のエネルギー範囲に感度を持っている。GRB021206 の偏光観測では 80 ± 20 [%] の偏光を検出したが、検出器の配置が幾何学的に対称ではなく、得られたデー タが衛星の回転周期と同期していることなどから、有意な観測ではないと考えられている。

Fireball Model では、相対論的衝撃波の衝突によって加速された電子が、衝突によって圧縮 された磁場に巻きつき、シンクロトロン放射で明るく輝くと考えられている。GRB の偏光を 観測することができれば、ライトカーブからは得られない GRB の磁場構造や放射機構の解明 につながるはずである。

これまでに、太陽観測衛星である RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) によって GRB の偏光観測が行われている。RHESSI に搭載されているゲル マニウム検出器 9 個から成るスペクトロメーターを図 2.8 に示す。GRB021206 のプロンプト 放射について、光子散乱幾何学の解析によって、0.15-2 MeV のエネルギー範囲で 80 ± 20 [%] という強い偏光が検出された。しかし、RHESSI は太陽観測衛星であるために検出器の配置が 幾何学的に対称ではなく、得られたデータが衛星の回転周期と同期していることなどから、別



図 2.9 磁場と偏光。重力崩壊した天体から放出された物質ジェット中の強磁場でジャイロ 運動をしている電子は偏光した γ 線を放射する。(a) は GRB に対する観測者の視線がほ ぼジェットの円錐の中心軸であり、磁場が揃っている場合であり、強い偏光が観測される。 (b) はジェットの円錐の端に沿って視線であり、もし磁場がランダムな方向を向いていたと しても、(a) と同程度の偏光度が得られる [5]。

の解析によって強く批判された。そのため、この観測は GRB の偏光度に対する上限値を決めたに過ぎない [4]。GRB の偏光を検出するためには、幾何学的対称性を持つ形状で、同期イベントを処理できる回路系を持つ、偏光検出に特化した検出器が求められる。

RHESSI により検出された GRB021206 の 80 ± 20 [%] という偏光の上限値について、その ような強い偏光が得られるモデルの理論的解釈がなされている。代表的なモデルについて以下 に示す。

2.7.1 強磁場による偏光

放射源からもたらされる、揃った強磁場の存在による偏光モデルである。このモデルの概念 図を図 2.9(a) に示す。我々の観測では、GRB からのガンマ線が衝撃波のどこで生成されたか ということは分からない。つまり、観測される放射は衝撃波中のいろいろな領域で放出された 放射が重ね合わされたものである。衝撃波中の場所により偏光方向が違う場合には、お互いに 打ち消し合って無偏光が観測されることになる。しかし、衝撃波中のどこでも偏光方向が同じ であれば、強い偏光が観測される。シンクロトロン放射では、ガンマ線生成領域での磁場がど こでも同じ方向に揃っていれば、偏光が観測されることになる。実際、我々に身近な超新星残 骸の衝撃波内では磁場が良く揃っているため、電波での高い偏光が観測されている。

ガンマ線フラックスは基本的に変化するため、ガンマ線生成領域でそのような強い、一定に 揃った磁場は生成されないと考えられる。放射源に起源を持つ強磁場がジェットによって運ば れた可能性が考えられている [5]。

2.7.2 幾何学的な偏光

短時間に生成され衝撃波に巻きつく磁場が存在し、ジェットの軸に対する観測角度による非 対称性で偏光をつくり出すモデルである。このモデルの概念図を図 2.9(b) に示す。GRB に対 する観測者の視線がジェットの端に近い場合、ランダムな磁場中でも強い偏光が観測される可 能性がある。この場合、視線よりジェットの中心方向からの放射のみを観測することになるた め、偏光情報が打ち消し合うことはない。ジェットの開き角が狭い GRB では、この幾何学的 配置が起こりやすく、偏光が期待される [5]。

幾何学的な配置による偏光は、強磁場による偏光の場合にも当てはまる。幾何学的配置に よってさらに強い偏光をつくり出すことができるものとして、逆コンプトン散乱による放射理 論がある。逆コンプトン散乱による放射メカニズムを以下に示す。

コンプトンドラッグ

ー様な光子場を相対論的な速度のイオン化したプラズマが移動すると、光子は相対論的な電子によって逆コンプトン散乱される。電子のローレンツファクターを Γ とすると、散乱によって光子のエネルギーは ~ Γ^2 倍に増加され、開き角 ~ $1/\Gamma$ 内に放射される。放射された高エネルギー光子はプラズマ流の運動エネルギーを使って生成される。この放射メカニズムをコンプトンドラッグ (バルクコンプトン) と呼ぶ。

ー様な光子場中を相対論的速度で運動する1電子に対して、観測角度の関数としての偏光を 図 2.11 に示す。電子の静止系において、電子の速度ベクトルに対して 90°方向で観測した場 合に最も強く偏光が検出されることが分かる。電子の静止系では、入射光子がコンプトン散乱 すると考えることができる。コンプトン散乱 (トムソン散乱)による散乱光子は、散乱角度 θ に依存して強く偏光していることが知られている。散乱角度による偏光度は、

$$\Pi = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta} \tag{2.3}$$

となる。式 2.3 から、 $\theta = 90^{\circ}$ のとき $\Pi = 1$ となり、最大の偏光度が得られる。



図 2.10 逆コンプトン散乱



図 2.11 一様な光子場を相対論的な速度で 動く電子による放射の偏光。 θ'_{obs} [rad] は電 子の静止系での視線角度である。ローレンツ ファクターが大きい電子による放射は強く偏 光している [6]。



図 2.12 視線角度の関数としての偏光。最も 強く偏光が観測できるのはジェットの端より 少し外側であり、開き角が狭いジェットの方 が高い偏光度が期待される [6]。

また図 2.11 から、電子のローレンツファクターが大きい場合の放射は強く偏光しているこ とが分かる。これは、相対論的な効果によって非等方的な放射場を観測することになるためで ある。つまり、電子の静止系では、光子の入射方向がほぼ一方向に揃い、散乱光子の電場が揃 うためである [6]。

コンプトンドラッグによる Fireball Model からの偏光

電子の静止系では $\theta = 90^{\circ}$ 方向で強く偏光している。観測者系で見ると、相対論的ビーミン グの効果によって、電子の速度ベクトルに対してハーフアングル $\sim 1/\Gamma$ の円錐内に放射され ることになる。つまり、電子の速度ベクトルに対して $\sim 1/\Gamma$ の方向から観測する場合に最も 強い偏光が得られる。

相対論的速度で放射状に拡大するジェットの開き角を θ_{jet} 、観測者の視線角度を θ_{obs} とする。シンクロトロン放射モデルのように、コンプトンドラッグによって観測される偏光は、電子のローレンツファクター Γ に対するジェットの開き角 θ_{jet} とジェットの軸からの観測者の 視線角度 θ_{obs} に依存する。図 2.12 に、視線角度の関数として、いくつかのジェット幾何学に ついての偏光を示す。負の偏光度は、ジェットの軸と視線を含む平面の偏光成分に相当するも のであり、正の偏光度はその面に垂直な偏光成分に相当するものである。

最も強く偏光が観測できるのはジェットの端より少し外側 $(\sim \theta_{\rm jet} + 1/\Gamma)$ である。また、開き角が狭いジェットの方が高い偏光度を期待できる。これは、観測者の幾何学的配置によって、電子の静止系で 90° 方向に散乱された光子の割合が多くなるからである。ただし、最大偏

光度が得られる観測者の配置では、放射強度が非常に弱くなるため、実際の観測では弱い偏光 として検出される可能性がある。

Fireball Model でジェットの開き角が狭ければ、コンプトンドラッグによって高い偏光度を 得ることができる。シンクロトロン放射の場合に観測される偏光は、非相対論的な場合に得ら れる最大の偏光 (~ 75%) よりも小さくなる。しかし、コンプトンドラッグの場合に観測され る最大の偏光は、電子の静止系で 100% である [6]。



図 2.13 コンプトンドラッグの幾何学的配置。ジェットの軸方向から観測した場合は配置 が対称になるため、無偏光となる。最も強く偏光が観測できるのはジェットの端より少し外 側である。

2.8 研究目的

最近の観測により、Fireball Model では説明できないフラックスの時間変化を伴う GRB や、フレアを持つ GRB が見つかっている。GRB の偏光観測を行い、偏光度を決定すること ができれば、ライトカーブからは得られない磁場構造や放射機構を解明することができると考 えられる。しかし、これまで GRB についての有意な偏光観測は行われていない。ガンマ線は 大気の影響で地上には届かないため、検出器を人工衛星に搭載し、宇宙空間での観測を行う必 要がある。

現在開発を行っている偏光検出器は、2010年5月打ち上げ予定のソーラー電力セイル実証 機に搭載されることが決まっている。我々の研究目的は、偏光検出に特化した検出器を人工衛 星に搭載し、偏光観測によってGRBの磁場機構、放射機構を明らかにすることである。

第3章

偏光

3.1 偏光

光は電磁波なので進行方向に垂直に電場ベクトルと磁場ベクトルを持っている。このベクト ルが一定の方向に偏った光を偏光という。偏光には電場ベクトルの向きが時間によらず一定な 直線偏光と、電場ベクトルが時間変化し進行方向に垂直な平面内で円や楕円軌道を描く円偏 光、楕円偏光がある。また、電場ベクトルが時間変化するがその方向が時間によらずランダム な場合を無偏光という。式 3.1 に直線偏光における偏光度 Ⅱ を示す。

$$\Pi = \frac{P_{\parallel} - P_{\perp}}{P_{\parallel} + P_{\perp}} \tag{3.1}$$

 P_{\parallel} は電場ベクトルに平行な光子数、 P_{\perp} は電場ベクトルに垂直な光子数である。 $\Pi = 1$ のとき完全偏光、 $\Pi = 0$ のとき無偏光である。

3.2 偏光基礎過程

3.2.1 制動放射

高速で動く電子が物質に衝突すると物質中の原子核の電場によってクーロン力を受ける。こ のとき電子がクーロン力で進路を曲げられ加速度を受け、電磁波が放射される。これを制動放 射という。電子の進行方向、クーロン力による加速度ベクトルがランダムな熱的放射では、放 射される電磁波は無偏光で観測される。一方、電子ビームなどの場合は一定方向から電子を飛 ばし物質と衝突させるため、電子が受ける加速度ベクトルは比較的揃っており、直線偏光し た X 線が観測される。本論文で使用する X 線発生装置は制動放射を利用しており、加速電圧 100 kV の場合に 100 keV で約 20% 程度の偏光度であることが分かっている [3]。



図 3.1 制動放射の概念図。放射される電磁波の電場ベクトルは、電子が受ける加速度ベクトルと放射される X 線との平面内にある。

3.2.2 シンクロトロン放射

相対論的速度で動く荷電粒子が磁場中を運動するとき、荷電粒子はローレンツカF = -evBにより加速度を受け進路を曲げられる。このとき粒子は軌道の接線方向に電磁波を放射する。 これがシンクロトロン放射である。

まずシンクロトロン放射の放射パワーを求める。質量 m、電荷 q の荷電粒子が相対論的速度 v で一様な磁場中を動いているときの運動方程式は、

$$\frac{d}{dt}(\gamma mv) = \frac{q}{c}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$
(3.2)

となり、式 3.2 について粒子の速度 v を磁場に平行な成分 v_{\parallel} と垂直な成分 v_{\perp} に分けると、

$$\frac{d\boldsymbol{v}_{\parallel}}{dt} = 0 , \qquad \frac{d\boldsymbol{v}_{\perp}}{dt} = \frac{q}{\gamma mc} \boldsymbol{v}_{\perp} \times \boldsymbol{B}$$
(3.3)

となる。また、エネルギー保存則は

$$\frac{d}{dt}\gamma mc^2 = q\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{E} = 0 \tag{3.4}$$

となり、 $\gamma = -$ 定、または |v| = -定である。式 3.3 から $v_{\parallel} = -$ 定であるので、 $|v_{\perp}| = -$ 定である。つまり、粒子はジャイロ運動を行い、この周波数 ω_B は以下のように書ける。

$$\omega_B = \frac{qB}{\gamma mc} \tag{3.5}$$

ここで、相対論的な粒子からの放射のパワーは、

$$P = \frac{2q^2}{3c^3}\gamma^4 (a_{\perp}^2 + \gamma^2 a_{\parallel}^2)$$
(3.6)

と書ける。いま、それぞれの加速度成分は $a_{\parallel} = 0$ 、 $a_{\perp} = \omega_B v_{\perp}$ であるので、式 3.5、式 3.6 から、放射のパワーは

$$P = \frac{2q^2}{3c^3}\gamma^4 \frac{q^2 B^2}{\gamma^2 m^2 c^2} v_{\perp}^2 = \frac{2}{3}r_0^2 c\beta_{\perp}^2 \gamma^2 B^2$$
(3.7)

となる。 r_0 は古典電子半径、 $v = c\beta$ である。磁場と粒子の速度ベクトルの間のピッチ角 α について速度 β の平均をとると、

$$\langle \beta_{\perp}^2 \rangle = \frac{\beta^2}{4\pi} \int \sin^2 \alpha \, d\Omega = \frac{2\beta^2}{3} \tag{3.8}$$

であるので、式 3.7 は

$$P = \left(\frac{2}{3}\right)^2 r_0^2 c\beta^2 \gamma^2 B^2 \tag{3.9}$$

となる。これにより、シンクロトロン放射の放射パワーは粒子のローレンツ因子の二乗、磁場 の二乗に比例していることがわかる。



図 3.2 粒子のジャイロ運動を上から見た図。相対論的粒子からの放射は相対論的ビーミン グにより接線方向を中心に半角 $1/\gamma$ の方向に絞られるため、1 の点から 2 の点の間で放射 される光子だけが観測者に届く。

荷電粒子のジャイロ周波数は式 3.5 で求めたが、次に、観測される典型的な周波数を求める。 図 3.2 は粒子のジャイロ運動を上から見た図である。相対論的な速度で運動する粒子からの放射はビーミング効果 (付録??) により角度幅 $1/\gamma$ の円錐内に放射される。このため、観測できる放射は 1 の点から 2 の点の間に放射されたものである。1 から 2 までの距離を Δs とすると $\Delta s = a \Delta \theta$ である。 $|\Delta v| = v \Delta \theta$ 、 $\Delta s = v \Delta t$ と式 3.2 から、

$$\gamma m v^2 \frac{\Delta \theta}{\Delta s} = \frac{q}{c} v B \sin \alpha \tag{3.10}$$

$$a = \frac{\gamma m v c}{q B \sin \alpha} = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha} \tag{3.11}$$

ここで幾何学的に、 $1/\gamma = \triangle \theta/2$ より $\triangle s = 2a/\gamma$ となるので、

$$\Delta s \approx \frac{2v}{\gamma \omega_B \sin \alpha} \tag{3.12}$$

1、2の点での放射の時刻を t_1 、 t_2 とすると、 $\triangle s = v(t_2 - t_1)$ と書けるので、実際に粒子が放射を行う時間は次のようになる。

$$t_2 - t_1 = \frac{2}{\gamma \omega_B \sin \alpha} \tag{3.13}$$

1の点から観測者までの距離を R として 1、2の点からの放射が観測される時刻 t_1^A 、 t_2^A は、

$$t_1^A = \frac{R}{c} \tag{3.14}$$

$$t_2^A = (t_2 - t_1) + \frac{R + (t_2 - t_1)v}{c}$$
(3.15)

となり、実際に放射が観測される時間は、

$$t_2^A - t_1^A = \frac{2}{\gamma \omega_B \sin \alpha} \left(1 - \frac{v}{c} \right) \tag{3.16}$$

となる。いま、 $\gamma \gg 1$ であるので、 $1 - v/c \approx 1/(2\gamma^2)$ と近似できて、式 3.16 は、

$$t_2^A - t_1^A \approx \frac{1}{\gamma^3 \omega_B \sin \alpha} \approx \frac{1}{\gamma^2} (t_2 - t_1)$$
(3.17)

となり、放射が観測される時間は実際に放射するのにかかった時間よりも $1/\gamma^2$ 倍だけ短く観測される。このときに観測される典型的な周波数は以下のようになる。

$$\omega_c \equiv \frac{3}{2} \gamma^3 \omega_B \sin \alpha \tag{3.18}$$

次にシンクロトロン放射の偏光度を求める。図 3.3 の原点は時刻 t' = 0 での粒子の位置であ り、a は軌道曲線の半径である。粒子は時刻 t' = 0 で x 軸に沿った速度ベクトル v を持って いる。 ϵ_{\perp} は xy 平面で y 軸に沿った単位ベクトルであり、 $\epsilon_{\parallel} = n \times \epsilon_{\perp}$ である。 ϵ_{\perp} 、 ϵ_{\parallel} 方向 の単位周波数あたりの放射パワーは次のように表される。

$$P_{\perp}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{4\pi mc^2} [F(x) + G(x)]$$
(3.19)

$$P_{\parallel}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{4\pi mc^2} [F(x) - G(x)]$$
(3.20)

ここで、 $x \equiv \omega/\omega_c$ としてベッセル関数 $K_{\alpha}(\eta)$ を使って、

$$F(x) \equiv x \int_{x}^{\infty} K_{\frac{5}{3}}(\xi) d\xi , \quad G(x) \equiv x K_{\frac{2}{3}}(x)$$



図 3.3 シンクロトロン放射の偏光のための図。時刻 t' = 0 で x 軸に沿った速度 v をもつ 粒子が、半径 a の曲線軌道を動くとする。

と定義した。式 3.1 と式 3.19、3.20 から、単一エネルギー γ に対する偏光度は、

$$\Pi(\omega) = \frac{P_{\perp}(\omega) - P_{\parallel}(\omega)}{P_{\perp}(\omega) + P_{\parallel}(\omega)} = \frac{G(x)}{F(x)}$$
(3.21)

となる。相対論的電子のエネルギー分布は、

$$N(\gamma)d\gamma = C\gamma^{-p}d\gamma \quad (\gamma_1 < \gamma < \gamma_2) \tag{3.22}$$

と書けるので、相対論的電子からのシンクロトロン放射による偏光度は以下のようになる [7]。

$$\Pi = \frac{\int G(x)\gamma^{-p} d\gamma}{\int F(x)\gamma^{-p} d\gamma} = \frac{\int G(x)x^{(p-3)/2}}{\int F(x)x^{(p-3)/2}} = \frac{p+1}{p+\frac{7}{3}}$$

$$\gamma \propto x^{-1/2} , \qquad \Gamma(q+1) = q\Gamma(q)$$
(3.23)

GRB の最大偏光度を考える。2.6 章で述べたように GRB の理論モデルである Fireball Model では、衝撃波内部でフェルミ加速された電子がシンクロトロン放射すると考えられて いる。フェルミ加速された電子のエネルギー分布では式 3.22 において p = 2 であるので、式 3.23 に代入すると、 $\Pi = 70$ % である。これは磁場が完全に揃っている場合の見積りであり、 期待される最大の偏光度である。

3.2.3 コンプトン散乱

コンプトン散乱は入射光子と吸収物質中の1個の電子との間で起こる相互作用である。図 3.4 に示すように、入射光子が原点で電子と衝突して進路を曲げられ、光子はエネルギーの一 部を電子(反跳電子)に与える。この相互作用をコンプトン散乱と言い、入射光子の偏光方向 によって図3.6のような散乱の異方性が見られる。3.6.3項に示す散乱型検出器では、この散



図 3.4 コンプトン散乱の模式図。x 軸方向の電場ベクトルを持って z 軸の負の方向から入 射した光子が、原点で静止している電子と衝突する場合を考える。

乱異方性を検出することで偏光を検出している。

エネルギーと運動量の保存則の連立方程式を解くことによってエネルギー伝達と散乱角の 関係式を導く。入射光子の振動数を ν 、電場ベクトルをx軸方向とし、散乱光子の振動数を ν' 、衝突後に電子が得たエネルギーを E_e 、運動量を p_e 、入射光子に対する光子の散乱角を θ 、 $\phi(\theta: 極角、\phi: 方位角)、衝突後の電子の放出角を<math>\theta_e$ 、 $\phi_e(\theta_e: 極角、\phi_e: 方位角)$ とすると、 エネルギーと運動量の保存則はそれぞれ、

$$h\nu = E_e + h\nu' \tag{3.24}$$

$$\frac{h\nu}{c} = p_e \cos\theta_e + \frac{h\nu'}{c} \cos\theta \tag{3.25}$$

$$p_e \sin \theta_e \cos \phi_e + \frac{h\nu'}{c} \sin \theta \cos \phi = 0$$
(3.26)

$$p_e \sin \theta_e \sin \phi_e + \frac{h\nu'}{c} \sin \theta \sin \phi = 0 \qquad (3.27)$$

となる。相対論での p_e と E_e の関係 $(p_ec)^2 = E_e(E_e + 2m_ec^2)$ を使うと、式 3.24~3.27 から 散乱光子、反跳電子のエネルギーは、

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$
(3.28)

$$E_e = h(\nu - \nu') = m_e c^2 \frac{2\nu^2 \cos^2 \theta_e}{(h\nu + m_e c^2)^2 - (h\nu)^2 \cos^2 \theta_e}$$
(3.29)

となる。入射光子のエネルギーが電子の静止エネルギーに対して十分小さいときは非相対論的 に扱われる。この散乱はトムソン散乱と呼ばれ、散乱光子のエネルギーは入射光子のエネル ギーとほとんど変わらない弾性散乱である。 電子を自由電子とした場合のコンプトン散乱の散乱角度分布について示す。入射光子に対する光子の散乱角を θ 、 ϕ 、立体角を $d\Omega$ 、微分断面積を $d\sigma$ 、古典電子半径を r_0 とすると、クライン-仁科の式から、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \frac{E'^2}{E^2} \left(\frac{E}{E'} + \frac{E'}{E} - 2\sin^2\theta\cos^2\phi\right)$$
(3.30)

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}$$
$$E = h\nu , \quad E' = h\nu' , \quad r_0 = \frac{e}{m_e c^2}$$

となる。入射光子のエネルギーのみで書くと、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_0^2 \frac{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi}{1 + \gamma (1 - \cos \theta)^2} \left[1 + \frac{\gamma^2 (1 - \cos \theta)^2}{2(1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi) \{1 + \gamma (1 - \cos \theta)\}} \right]$$
(3.31)
$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2}$$

となる。入射光子のエネルギーが電子の静止エネルギーに比べて十分小さい場合は γ が小さくなり、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_0^2 (1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi) , \quad E \ll m_e c^2$$
(3.32)

のトムソン散乱の角度分布となる。



図 3.5 極角 θ についての微分断面積の角度分布。 入射光子のエネルギーが高くなると、前方散乱が 支配的になっていくことが分かる。

図 3.6 $\theta = 90^{\circ}$ のときの方位角 ϕ についての角度分布。入射光子の電場ベクトルと垂直な方向に散乱されやすいことが分かる。

図 3.5 に無偏光の場合の入射光子のエネルギーごとの θ についての微分断面積の角度分布を示す。トムソン散乱の場合、 $1 \text{keV}(\pi)$ の分布を見ると、 θ については $\theta = 0,180^{\circ}$ である z 軸

で最大となり、 $\theta = 90,270^{\circ}$ である x 軸に対して対称な分布となる。入射光子のエネルギーが高くなるにつれて γ は大きくなり、トムソン散乱からのずれが大きくなる。つまり、 $\gamma > 1$ の相対論的領域では前方散乱が支配的になることがわかる。また、図 3.6 に $\theta = 90^{\circ}$ の場合の ϕ についての角度分布を示す。コンプトン散乱では入射光子の電場ベクトル方向 (x 軸) と垂直な方向に散乱されやすいことが分かる。

コンプトン散乱の散乱断面積 σ は式 3.31 を $d\Omega$ で積分して、

$$\sigma = \frac{3}{8\gamma} \sigma_0 \left[\left\{ 1 - \frac{2(\gamma+1)}{\gamma^2} \right\} \log(2\gamma+1) + \frac{1}{2} + \frac{4}{\gamma} - \frac{1}{2(2\gamma+1)^2} \right]$$
(3.33)
$$\sigma_0 = \frac{8\pi r_0^2}{3} = 6.65 \times 10^{-25} \ [\text{cm}^2] \ , \qquad \gamma = \frac{E}{m_e c^2}$$

となる。 σ_0 はトムソン散乱断面積である。トムソン散乱の散乱過程は古典的に、入射光子の電場により電荷が電気双極子的に振動することで双極子放射を行い、入射光子と同じエネルギーを持つ電磁波を放射するというものであり、低エネルギーのコンプトン散乱では σ_0 となる。

ここまでは自由電子による散乱を扱ってきたが、実際の物質中で行われるのは原子に束縛された電子による散乱である。しかし、入射光子のエネルギーが十分に大きい場合には電子の束縛エネルギーの効果は相対的に小さい。よって、束縛エネルギーによる効果を無視すると、一原子あたりのコンプトン散乱の散乱断面積 σ_{atom} は原子内の電子の総数である原子番号 Z によって次のように書ける [1]。

$$\sigma_{atom} = Z\sigma \tag{3.34}$$

3.2.4 逆コンプトン散乱

観測者系において電子のエネルギーが電子の静止エネルギーよりも十分大きい場合、逆コン プトン散乱が起こる。この過程は、電子の静止系にローレンツ変換した場合の状況で2つに分 けることができる。電子の静止系で光子のエネルギーが電子の静止エネルギーよりも十分小さ い場合はトムソン散乱が起こり、光子のエネルギーが電子の静止エネルギーよりも大きい場合 はコンプトン散乱が起こる。トムソン散乱が起こる場合、観測者系では電子から光子にエネル ギーが与えられ、光子のエネルギーは γ^2 倍にブーストされる。一方、コンプトン散乱が起こ る場合には、光子は電子にエネルギーを与えてしまうため、 γ^2 になることはない。

3.2.5 光電効果

光電効果とは、入射光子が吸収物質の原子核に束縛された電子にエネルギーを与え、入射 光子自身は消滅する相互作用である。このとき、光子は束縛エネルギーが最も大きい K 殻電 子と相互作用する確率が高い。入射光子のエネルギーを $h\nu$ 、吸収物質の電子殻の結合エネル ギーを E_b とすると、 $h\nu - E_b$ の運動エネルギーをもった光電子が電子殻から放出される。こ の結果電子殻にできる空孔は、その電子殻の結合エネルギーが特性 X 線、またはオージェ電 子の形で放出されることによる、電子の再配列によって埋められる。つまり、光電効果が起こ ると、入射光子の大半のエネルギーを持った光電子1個と、その光電子がもともと束縛されて いた電子殻の結合エネルギーを吸収した1個、または1個以上の低エネルギー電子が放出され る。検出器外への飛散が起こらない場合には、放出された電子の運動エネルギーの和は入射光 子のエネルギーに等しいはずなので、X線のエネルギーを測定する目的では光電効果は理想的 な過程である[8]。

また、光電効果の際の光電子の放出方向は、入射光子の偏光方向に依存する異方性がある。 入射光子と光電子のなす角を θ 、入射光子の電場ベクトルと光電子の放出方向のなす角を ϕ 、 光電子の速度を $v(=c\beta)$ として放出角度分布は、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{\sin^2 \theta \cos 2\phi}{\left(1 - \beta \cos \theta\right)^4} \tag{3.35}$$

と表され、光電子は入射光子の偏光方向に放出されやすい[10]。

3.2.6 ブラッグ反射

ブラッグ反射は結晶による X 線の回折現象の一種である。回折の条件 (ブラッグ条件) は、

$$2d\sin\theta_B = n\lambda\tag{3.36}$$

であり、d は結晶の格子定数、 θ_B は光子の結晶への入射角、 λ は光子の波長、n は正の整数で ある。反射率は電場ベクトルの方向に依存する。入射光子の電場ベクトルの結晶面に平行なも のを σ 偏光成分、結晶面に垂直なものを π 偏光成分として、それぞれの成分の反射率を R_{σ} 、 R_{π} とする。完全結晶では、 $R_{\sigma} = 1$ 、 $R_{\pi} = \cos 2\theta_B$ となる。また、グラファイトのようなモ ザイク結晶では $R_{\sigma} = 1$ 、 $R_{\pi} = \cos^2 2\theta_B$ となり、 $\theta_B = 45^\circ$ で入射したときは σ 偏光成分の みが反射されることになる [3]。

3.3 宇宙における偏光光源

3.3.1 パルサー星雲型超新星残骸 (SNR)

超新星爆発によって周囲にまき散らされた星の残骸が超新星残骸 (Supernova Remnant:SNR)であり、パルサー星雲型とシェル型がある。パルサー星雲型 SNR は中心に 中性子星があり、その周囲を電波からガンマ線まで全ての波長領域で明るく輝く星雲が取り巻 いている。放射機構は、中心の中性子星とともに高速回転する磁場によってまわりの電子が相 対論的速度まで加速され、周囲の星雲の磁場との相互作用によるシンクロトロン放射であると 考えられている。3.2.2 節に示したようにシンクロトロン放射では磁場が揃っていれば偏光が 期待できる。実際、パルサー星雲型 SNR のかに星雲では X 線、可視光で偏光が観測されてい る。一方、シェル型 SNR からの放射の大部分は、衝撃波によりかき集められた星間物質や超 新星残骸そのものが高温に加熱されることによる熱的放射であると考えられている [3]。 3.3.2 活動銀河核 (AGN)

大質量ブラックホールを含む銀河の中心領域で、活動性を示すものを活動銀河核 (Active Galactic Nucleus : AGN) という。AGN は電波からガンマ線まですべての波長領域で明るく 輝いている。その放射機構として、降着円盤からの熱的放射とジェットからのシンクロトロン 放射などの非熱的放射を統一的に理解するモデルが考えられている。降着円盤での散乱による 幾何学的偏光や、シンクロトロン放射による偏光が期待される。ジェットが観測者の方向を向 いている AGN は特にブレーザーと呼ばれ、可視光や電波の領域で強い偏光が観測されている [1]。

3.3.3 X線パルサー

規則正しい周期性を持って X 線のパルスを放射している天体を X 線パルサーという。X 線 パルサーの多くは中性子星と大質量星がその重心の周りをお互いに回転している近接連星系で ある。大質量星からのガスが磁力線に沿って中性子星に流れ込み、磁極に集まり降着柱を形成 する。このとき莫大な重力エネルギーが解放され、シンクロトロン放射によって X 線が放射 されている。

図 3.7 に示すように、降着柱の形状によりペンシルビームモデルとファンビームモデルの 2 種類が考えられている。ペンシルビームモデルは降着率が低い場合で降着柱の高さが比較的低 く、主に降着柱上面から放射される。このため、観測者はパルサーの磁極を正面から見ている ことになり、磁場の向きは等方的になるため偏光は期待できない。一方、ファンビームモデル は降着率が高い場合であり、降着柱の側面から放射される。このとき観測者から見ると磁場の 向きはよく揃っているので、放射は強く偏光していることになる。つまり、パルス位相ごとの 偏光観測によりパルサーの磁場構造を知ることができると考えられる [3][9]。



3.3.4 低質量 X 線連星系 (LMXB) 降着円盤

降着円盤とは、連星系をつくる比較的コンパクトだが重い天体が、強い重力によって伴星か らガスを奪うことによってつくられるガス雲である。X線星の多くは中性子星との連星であ ると考えられており、中心の星が中性子星の場合は、伴星の質量によって大質量連星系と低質 量連星系に分けられる。連星系は公転しているため引き寄せられたガスは角運動量を持ってい る。このため、すぐには中性子星の表面には落ち込まず、円盤状になりながら公転軌道に流れ 込む。低質量連星系はその形成過程が原因となり、磁場が弱く、円盤は中性子星表面付近まで 達し、中性子星表面の広い範囲に渡るガスの降着に伴って硬X線が放射される。また、円盤 内から熱制動放射によって軟X線が放射される。これらのX線は無偏光であるが、円盤内か らのX線がガスとトムソン散乱を起こし、円盤に平行に放射された場合に偏光が観測される。 つまり、円盤に対して真横から観測した場合は強い偏光が観測され、真上から観測した場合は 無偏光となる。偏光観測によって降着円盤の傾きを推定することができる [3][9]。



図 3.8 降着円盤からの偏光

3.3.5 ブラックホール候補天体 (BHC)

太陽質量の3倍以上の中性子星が自らの重力を支えきれずに重力崩壊した結果形成される、 光さえ外に出られないような天体をブラックホールという。ブラックホールの近くに大質量星 があると降着円盤が形成される。降着円盤のブラックホールに近い部分は温度が高いために硬 X線が放射され、遠い部分からは軟X線が放射される。

降着円盤から放射される X 線は、円盤内でトムソン散乱されながら放出され、LMXB の場 合と同様に円盤に対して真横から観測した場合は偏光が観測される。またブラックホールが回 転しているカーブラックホールの場合には、周りの空間を引きずるように歪めているため、降 着円盤から放出される X 線の偏光ベクトルも回転する。とくに、ブラックホールのより近傍 から放射される硬 X 線は歪んだ空間を通過する期間が長いため、偏光ベクトルの回転も著し い。つまり、エネルギーごとに X 線の偏光方向を観測すると、エネルギーと共に変化する X 線の偏光ベクトルを観測できるだろう [3]。

3.4 過去の偏光観測

現在までに観測された X 線による偏光天体を表 3.1 に示す。偏光観測を行った衛星は ArielV、OSO-8、RHESSI の 3 つである。ArielV は定常天体の偏光観測を行ったが偏光度の 上限値を決めたに過ぎない。OSO-8 はかに星雲、Sco X-1、Cyg X-1、Cyg X-2、Cyg X-3 の 5 つの天体について実際に偏光度を決める観測を行った。GRB については、RHESSI により 偶然観測された、80±20 [%] という非常に高い偏光度が報告されている。しかし、RHESSI は 太陽観測衛星であり、検出器の幾何学的配置が軸対称ではなく、得られたデータが衛星の回転 周期と同期していることなどから有意な観測ではないと考えられている。

表 3.1 過去の X 線による偏光観測結果

「<80」は偏光度の上限値が80%であることを意味する。太陽観測衛星 RHESSI は GRB 観 測で80±20%の高い偏光度を観測したが、データの振幅が衛星の回転周期と同期しているこ となどから有意な観測ではないと考えられている。

天体	種類	OSO-8	OSO-8	ArielV
		@2.6 keV $[\%]$	@5.2 keV [%]	@2.6 keV $[\%]$
Crab Nebula	SNR	$19.2{\pm}1.0$	19.2 ± 2.8	-
Sco X-1	LMXB	$0.39 {\pm} 0.20$	1.3 ± 0.40	<7.7
A0620-00	BHC	-	-	<2
Cyg X-1	BHC	$2.44{\pm}1.07$	5.3 ± 2.5	-
Cyg X-2	LMXB	$1.00 {\pm} 0.88$	$3.1{\pm}2.2$	-
Cyg X-3		10.2 ± 7.4	-	-
Per Cluster	銀河団	<12.6	-	-
Cen X-3	パルサー	<18.2	$<\!\!27$	-
Her X-1	パルサー	$<\!\!62.1$	-	-
GX339-4	BHC	<10.4	-	-
GX349+2	LMXB	< 9.2	<22.0	-
NGC6624	LXMB	$<\!\!4.7$	<10.8	-
Ser X-1	LMXB	<17.9	<64.8	-
4U1636-53	LMXB	<15.3	<60.1	-
Cas A	SNR	<26.4	-	-
天体	種類	RHESSI [%]		
GRB021206	GRB	80±20 ?	_	_
GRB030329	GRB	<80	-	-
3.5 偏光観測計画

偏光観測を行うことによって、超新星残骸やパルサーの磁場構造、ブラックホール周辺の降 着円盤の構造、活動銀河核中心の物質分布、GRBの放射機構や磁場機構を明らかにすること ができると考えられる。現在進行中の偏光観測計画の一部を紹介する。

^r PHENEX (Polarimetry for High ENErgy X-rays) J

山形大学、大阪大学、理化学研究所が行っている気球実験である。かに星雲からの偏光を 100 keV 程度の硬 X 線で観測する気球実験を行っている。既に何度か気球実験を行っている が、まだ偏光は検出できていない。

^r PoGO (Polarized Gamma-ray Observer) J

アメリカ、日本、スウェーデン、フランスが参加している硬 X 線偏光検出器であり、PoGO Lite は 2009 年に気球によるかにパルサーの偏光観測を行う予定である。

^rGAP (GAmma-ray burst Polarimeter) J

金沢大学、山形大学、理化学研究所が開発を行っている GRB 偏光検出器で、2010 年に打ち 上げ予定のソーラー電力セイル実証機に搭載されることが決まっている。衛星に搭載される偏 光検出器としては、最も早く実現する予定である。

'POET」

アメリカ、NASA/GSFC が計画している GRB 偏光観測衛星である。

^r Polaris _J

日本の小型衛星計画であり、X 線望遠鏡 + 検出器で定常 X 線源を測定するものである。 GRB 偏光計を搭載することを提案している。

3.6 偏光検出方法

反射型検出器、光電子追跡型検出器、散乱型検出器の3種類の偏光検出方法を示し、GRB の偏光検出に適した検出方法について述べる。

3.6.1 反射型検出器

反射型検出器は、ブラッグ反射の反射特性を用いて偏光を検出する。図 3.9 に示すように、 結晶と検出器を 45°をなすように配置し、そのままセットで回転させることによって、入射 X線のσ偏光成分のみを検出することで反射光強度の角度分布を得ることができる。これに よって、入射光子の偏光度を測定する。しかし、検出できる光子は式 3.36 のブラッグ条件を 満たす単色光のみであり、入射光子のσ成分のみを検出するため検出効率が悪い[10]。



図 3.9 反射型検出器の模式図。結晶と検出器を 45°をなすように配置し、セットで回転させることによって強度分布を測定し、偏光度を得る。

3.6.2 光電子追跡型検出器

光電子追跡型検出器は、光電効果によって放出される光電子の異方性を用いて偏光を検出す る。光子が光電効果を起こすと、光電子は入射光子の電場ベクトル方向に放出されやすい。放 出された光電子がガス、または半導体を電離して多数の電子(電子雲)を作るため、この広がっ た電子雲の形状を検出することで、光電子の放出方向が分かり、偏光度を得ることができる。 検出器はガス比例計数管や半導体検出器(X線CCD)を用いる[10]。

3.6.3 散乱型検出器

散乱型検出器は、コンプトン散乱の散乱異方性を用いて偏光を検出する。3.2.3 節で示した ように、コンプトン散乱による散乱光は、入射光子の電場ベクトルと垂直な方向に散乱されや すい。散乱体の周りに検出器を配置し、散乱光強度の角度分布を測定することによって偏光度 を測定する。コンプトン散乱の単位立体角あたりの散乱角度分布は極角をθ、方位角をφとす



図 3.10 光電子追跡型検出器の模式図 (X 線 CCD)。1 枚目のパネルで光電効果を起こし、 放出された光電子を 2 枚目のパネルで受けて光電子の放出方向を検出する。



図 3.11 100 keV 入射における $\theta = 0, 30, 45, 60, 90^{\circ}$ での方位角 ϕ 方向の散乱角度分布。 90° で最も振幅が強く観測される。

ると、式 3.31 から、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_0^2 \frac{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi}{1 + \gamma (1 - \cos \theta)^2} \left[1 + \frac{\gamma^2 (1 - \cos \theta)^2}{2(1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi) \{1 + \gamma (1 - \cos \theta)\}} \right]$$
(3.37)
$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2}$$

である。例として、 $\theta = 90^{\circ}$ とする立体角要素 $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ を用いると、

$$\frac{d\sigma}{d\theta d\phi} = r_0^2 \frac{\sin^2 \phi}{1+\gamma} \left\{ 1 + \frac{\gamma^2}{2\sin^2 \phi(1+\gamma)} \right\}$$
(3.38)

となり、 ϕ 方向の散乱角度分布は $\sin^2 \phi$ のサインカーブを描く。また、 γ を変えても反射型検 出器のように検出効率が0にはならないので、連続光を扱うことができる。図 3.11 に入射光 子のエネルギー *E* を 100 keV としたときの $\theta = 0, 30, 45, 60, 90^{\circ}$ での散乱角度分布を示す。 $\theta = 90^{\circ}$ 方向で最も強く偏光が観測されることが分かる [1]。

3.6.4 GRB の偏光検出方法

3 つの偏光検出方法の特徴を表 3.2 に示す。GRB の継続時間は短く連続光を放射する。また、GRB の光子は、平均的エネルギー 100 keV 付近を中心に、主なエネルギー帯は数 10-数 100 keV である。まず、反射型検出器は単色光しか扱うことができず、検出効率が悪い。継続時間が短く、連続光を放射している GRB の偏光観測には向かない。また、光電子追跡型検出器は検出効率が高く、連続光を扱うことができるが、光電子の飛跡を追跡することができるエネルギー範囲が数 10 keV 程度であり、GRB の偏光観測には不利である。

図 3.12 は入射光子のエネルギーと原子番号 Z によってガンマ線の主な相互作用である光電 効果、コンプトン散乱、電子対生成のどれが支配的であるかを示したものである。GRB の主 なエネルギー帯である数 10-数 100 keV では、Z が 10 程度の軽元素に対してはコンプトン散 乱が支配的であり、Z が 50 以上の重元素に対しては光電効果が支配的であることが分かる。 つまり、GRB の偏光観測においては軽元素の散乱体と重元素の吸収体で構成された散乱型検 出器が適している [1]。

3.7 偏光検出器の性能

偏光検出器の性能を示すパラメータとして、モジュレーションファクタ *M* と検出効率 η、 がある。以下では散乱型検出器についてこれらを説明する。

3.7.1 モジュレーションファクタM

式 3.37 より、 ϕ 方向の散乱角度分布は $\sin^2 \phi$ のサインカーブを描く。これをモジュレー ションカーブといい、強度の最大値を N_{\max} 、最小値を N_{\min} とすると、

モジュレーション =
$$rac{N_{ ext{max}} - N_{ ext{min}}}{N_{ ext{max}} + N_{ ext{min}}} = rac{\sin \sigma \, ext{max}}{$$
強度分布の平均 (3.39)

表 3.2 代表的な偏光検出方法の利点と欠点

GRB の観測には連続光を扱えること、偏光検出感度(モジュレーションファクタ)が高いこと、エネルギー範囲等からコンプトン散乱を使った散乱型検出器が適していると言える。

	反射型検出器	散乱型検出器	光電子追跡型検出器
検出方法	ブラッグ反射	コンプトン散乱	光電効果
扱う光 [単色 or 連続]	単色光	連続光	連続光
検出効率	低い	中程度	高い
モジュレーションファクタ	高い	高い	低い
エネルギー範囲	\sim 数 keV	数 $10 \sim$ 数 100 keV	\sim 数 10 keV



図 3.12 入射エネルギーと原子番号 Z による主な光子と物質の相互作用。50-300 keV の 範囲では軽元素ではコンプトン散乱、重元素では光電効果が支配的である。

と定義する。モジュレーションファクタ M は検出器に 100 %偏光が入射するときのモジュ レーションであり、0 から 1 までの値をとる。M はそれぞれの検出器で決まった値をとり、 その検出器の偏光に対する感度を表すものである。図 3.13 に散乱型検出器の θ による M の 変化を示す。これは図 3.11 で得られたモジュレーションカーブからそれぞれの極角 θ での Mを見積り、プロットしたものである。M は $\theta = 90^\circ$ で最大となり、偏光に対する感度が最も 高いことが分かる。また、入射光子の偏光度を П は、実際に観測されるモジュレーションを M'とすると、検出器のモジュレーションファクタ M を用いて次式で表される [1]。

$$\Pi = \frac{M'}{M} \tag{3.40}$$



図 3.13 100 keV の入射光子に対する M の θ 依存性。90° で最も高いモジュレーション ファクタが得られる。

3.7.2 検出効率 n

検出効率 η とは、検出器に入射する光子のうち散乱体で散乱され吸収体で検出される光子の 割合である。η が小さいと光子数の統計誤差が大きくなり、モジュレーションカーブが見えな くなってしまうため、モジュレーションファクタ *M* とともに η も大きい検出器が望まれる。

図 3.14 には M、 η をそれぞれ最大にした場合の検出器の模式図を示す。M を大きくすれば、散乱光が見込む吸収体が小さくなるため η が小さくなってしまう。 η を大きくすれば θ 方向に積分範囲を広げることになり、M が小さくなってしまう [1]。

3.7.3 最小偏光度 (MDP)

最小偏光度 (Minimum Detectable Polarization : MDP) とは、観測対象の明るさ、観測時 間、バックグランドレベル、検出器の性能 (M, η) を総合的に評価したもので、ある条件下に おける検出可能な最小の偏光度のことである。MDP が小さいほど優れた偏光検出器であるこ とを意味する。 3σ の有意度で

$$MDP = \frac{3\sqrt{2}}{\eta SFM} \sqrt{\frac{\eta FS + B}{T}}$$
(3.41)



(a) *M* を最大にした検出器の断面図
(b) η を最大にした検出器の断面図
図 3.14 極端な検出器デザインの例。η を最大にするデザインと *M* を最大にするデザイン
は全く逆になる。



図 3.15 トムソン散乱の場合における M,η の θ 方向の積分範囲依存性。 $\theta = 0^{\circ}$ の場合は 図 3.14 の (b) に、 $\theta = 90^{\circ}$ の場合は (a) に対応する。検出器の性能は $\theta = 40^{\circ}$ の時に最大 となり、 $\theta = 90^{\circ}$ でも 0.5 程度を示す。

 $S: 有効面積 [cm²] \eta: 検出効率$ F: 観測対象の明るさ [photon cm⁻² s⁻¹] M: モジュレーションファクタB: バックグランド [photon s⁻¹] T: 観測時間 [s]

と表すことができる。バックグランド B が十分小さいとすると、式 3.41 は、

$$MDP = \frac{3\sqrt{2}}{M\sqrt{\eta S}}\sqrt{\frac{1}{FT}}$$
(3.42)

と書き直すことができる。F、T は検出器にはよらないので、検出器の性能を決めるのは $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ (*B* が支配的な場合は $M\eta S$) である。 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ が大きくなれば *MDP* は小さくな り、より偏光度の低い、より暗い観測対象を検出できることになる。

図 3.15 にトムソン散乱の場合における、 θ 方向の積分範囲による $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ と $M\eta$ の変化を示す。積分範囲は M が最も大きくなる 90° を中心としている。この図から、 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ は 90° を中心として ±40° 付近が最大となっているが、それ以上積分してもそれほど悪い値にはならない [1]。

3.8 シンチレーション検出器

放射線計測法のひとつに、シンチレータ中で発生するシンチレーション(蛍光)を光電子増 倍管(PMT)で検出する方法がある。放射線計測法の中では、検出効率、感度の点で最も優れ た方法のひとつである。

3.8.1 シンチレータ

シンチレータとは、入射した荷電粒子がシンチレータ中で相互作用を起こして失った運動エ ネルギーを、可視光のシンチレーションに転換して放出する物質のことである。シンチレー ションによる光子数は、シンチレータ中で荷電粒子が失った運動エネルギーに比例する。表 3.3 に主なシンチレータの特性を示す。

??節で示したように、GRB のエネルギー帯域 (数 10 keV~数 100 keV) で偏光を観測する ためには、軽元素の散乱体と重元素の吸収体を用いる。

散乱体はコンプトン散乱が支配的で、原子番号 Z が小さい物質が適している。単純な散乱 体としては Be や Li のような金属が用いられることもあるが、入射光子の散乱情報を得るた めに、プラスチックシンチレータ (Z=3.6)を用いる。プラスチックシンチレータは有機シン チレータであり、製作・成形加工が簡単であるため、大体積の固体シンチレータとして使いや すい。

また、吸収体は光電効果が支配的で、Z が大きい CsI(Tl) シンチレータ (Z=54) を用いる。 CsI(Tl) シンチレータは無機シンチレータである。放射線計測でよく使われる無機シンチレー タの NaI(Tl) と比較すると、単位長さあたりのガンマ線吸収がかなり大きいため、重量が問題 となる場合には有利である。また、潮解性が少なく、比較的剛性が高いため、衝撃や振動のあ る厳しい条件下でも使用できるという利点がある [8]。

	比重	蛍光波長	屈折率	減衰時間	蛍光効率
	$[g/cm^3]$	[nm]		$[\mu \mathrm{s}]$	[光子 $/MeV]$
NaI(Tl)	3.67	415	1.85	0.23	38000
CsI(Tl)	4.51	540	1.80	0.68~(64~%)	65000
				3.34~(36~%)	
BGO	7.13	480	2.15	0.30	8200
GSO	6.71	440	1.85	0.056~(90~%)	9000
				0.4~(10~%)	
プラスチック (NE102A)	1.03	423	1.58	0.002	10000

表 3.3 主なシンチレータの特性

3.8.2 光電子増倍管 (PMT)

光電子増倍管は、入射光を低エネルギーの電子に変換する光電陰極(光電面)、集束電極、電 子増倍部(ダイノード)、陽極で構成される真空管であり、高感度、高速応答の光センサーの一 種である。光が光電面に入射すると、光電面から真空中に光電子が放出され、その光電子は集 束電極によってダイノードに導かれる。光電子は電界で加速され、1段目のダイノードに入射 して二次電子を放出し、二次電子はさらに加速されて2段目のダイノードで新たな二次電子を 放出する。この過程を繰り返すことによって電子が増倍され、増倍された電子は出力信号とし て陽極に収集される。



図 3.16 光電子増倍管の構造

電圧分割回路 (ブリーダー回路)

PMT のダイノード間電圧は、抵抗を直列につないだ電圧分割回路 (ブリーダー回路) で印加 される。入射光がパルスの場合には、陽極電流が大きなピーク電流になる。このとき、ブリー ダー回路の電圧を一定に保ち、高いピーク電流値が得られるように、後段の抵抗に並列にコン デンサを入れる。また、安定した出力を得るために、ブリーダー回路には平均陽極電流の20 倍以上の電流を流す必要がある。

増倍率 (GAIN)

平均二次電子放出率が δ でn段のダイノードをもつ PMTの理想的な増倍率 (GAIN) は、 δ^n である。二次電子放出率 δ は、

$$\delta = A \cdot E^{\alpha} \tag{3.43}$$

と表せる。ここで、A は定数、E はダイノード間電圧、 α はダイノードの形や材質によって決まる値で、0.7~0.8 である。n 段のダイノードをもつ PMT の陽極–陰極間に電圧 V を印加した場合、ダイノード間電圧は E = V/n + 1 であり、式 3.43 から PMT の GAIN μ は次のように書ける。

$$\mu = \delta^n = \left\{ \frac{A}{(n+1)^{\alpha}} \right\}^n \cdot V^{\alpha n} = K \cdot V^{\alpha n} \quad (K = -\Xi)$$
(3.44)

陽極暗電流

PMT は完全な暗中にあるときでも微小な陽極暗電流を出力する。これに起因するノイズが PMT の検出能力に大きく関わるものである。陽極暗電流の原因として、熱電子放出、残留ガ スのイオン化、ガラスの発光、漏洩電流、電界放出が挙げられる。その中でもほとんどを占め るのは、光電面からの熱電子放出によるものである。光電面やダイノードの物質は仕事関数が 非常に低いため、室温でも熱電子を放出する。この熱電子がダイノードで増倍され、暗電流 (熱電子ノイズ)として出力される。熱電子放出は光電面の温度とともに指数関数的に上昇す るため、光電面を冷却して熱電子放出を減らすことで暗電流を低く抑えることができる。

PMT を最大定格電圧に近い電圧で動作させると電界放出が起こる。これは、強い電界に引かれて電極から電子が放出され、ノイズパルスが発生するものである。このため、PMT は最大定格電圧の 70 $\% \sim 80$ % で使用するべきである。

3.8.3 応答関数

スペクトル測定における検出器の応答を図 3.17 に示す。コンプトン散乱電子に対応する連 続エネルギーをコンプトン連続部、光電子に対応する狭いピークを光電ピークという。

入射光子がコンプトン散乱を起こすと、反跳電子と散乱光子が作られる。式 3.28 から、入 射光子のエネルギーを *hν*、散乱光子のエネルギーを *hν'* とすると、散乱角 *θ* について、

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$
(3.45)

となる。 $\theta \sim 0$ の前方散乱の場合、 $h\nu' \sim h\nu$ となるため、反跳電子のエネルギーはほぼゼロである。 $\theta = \pi$ の後方散乱の場合、反跳電子は入射方向へ飛び出し、電子に最大のエネルギー

が付与される。入射光子はあらゆる角度に散乱されるので、 $\theta = 0$ から $\theta = \pi$ の場合までの連続したエネルギーが得られる。 $\theta = \pi$ に相当する部分をコンプトンエッジという [8]。



図 3.17 スペクトル測定における検出器の応答

第4章

偏光検出器の改良

GRBの平均的なエネルギーである 100 keV 領域で偏光観測に適した検出器は、散乱型検出 器である。これまでに開発した旧検出器を用いて、実験室レベルの偏光検出には成功してい る。まずはじめに旧検出器モデルと、実験結果から得られた課題を示す。その後、旧検出器か らの性能向上と軽量化を目標とした偏光検出器の改良について、シミュレーション、実験結 果、重量の優位性を示す。

4.1 これまでの偏光検出器

昨年度試作した旧偏光検出器モデルの概形を示し、実験室で行った検出器に関連する基礎実 験の結果を示す。また、実験から得られた課題をまとめる。

4.1.1 旧偏光検出器モデル

旧偏光検出器モデルの概形図を図 4.1 に示す。プラスチックシンチレータは直径 100 mm の 12 角柱で、その周りを 12 枚の CsI(Tl) シンチレータ (50 mm×25.5 mm×3 mm) が囲ん でいる。プラスチックと CsI(Tl) の間は M が大きくなる効果があるため、5 mm の間隔が空 けてある。プラスチック用の PMT はダイノード 10 段、光電面 ϕ 46 mm の R1840-15 であ り、CsI(Tl) 用の PMT は光電面が ϕ 8 mm の R7400p である。

このモデルでは、シミュレーションに基づいた試作モデルを実際に作成すること、VA-TA を 用いて 13 系統同時の信号処理を行うこと、これらを使用した基礎実験を行い偏光検出器の妥 当性を示すことが目標であった。シンチレータの重量は良く考慮されていたが、検出器を収納 するアルミケースや信号処理回路に必要な重量はほとんど考慮されていない。重量を 1500 g 以下にすることを目標としていたが、このモデルの検出器全体の重量は 1814 g であった [3]。

4.1.2 R1840-15 の検出限界エネルギー

直径 100 mm で 12 角柱のプラスチックシンチレータをダイノード 10 段の R1840-15 で読 み出す場合、4.8 節に示す VA-TA を使った信号処理を行うと検出限界エネルギーが 12.0 keV である。100 keV の光子がコンプトン散乱を起こすと、プラスチックには 16.4 keV のエネル



図 4.1 旧偏光検出器モデル。プラスチックシンチレータは直径 100 mm の 12 角柱で、そ の周りを 12 枚の CsI(Tl) シンチレータが囲んでいる。プラスチック用の PMT はダイノー ド 10 段、光電面 ϕ 46 mm の R1840-15 であり、CsI(Tl) 用の PMT は光電面が ϕ 8 mm の R7400p である。

ギーを落とすため、実験室レベルの基礎実験を行う上では十分な性能である。しかし、実際に GRB の偏光観測を行う場合には検出限界エネルギーの改善が求められる [3]。

4.1.3 Csl(Tl) のエネルギー分解能

CsI(Tl)と R7400pの12系統で²⁴¹Am、⁵⁷Co、¹⁰⁹Cd、バックグランドのスペクトル測定 を行い、LD レベルとエネルギー分解能を評価した結果を表 4.1 に示す。それぞれの CsI(Tl) でエネルギー分解能がそれぞれ異なるため、偏光測定で得られる CsI(Tl)のスペクトルからエ ネルギーと偏光度の関係を正しく評価することができない。CsI(Tl)のエネルギー分解能を改 善し、12 枚の CsI(Tl)のエネルギー分解能を揃える補正を行うことが求められる [3]。

CsI(Tl)	LD レベル	エネルギー分解能	CsI(Tl)	LD レベル	エネルギー分解能
channel	$[\mathrm{keV}]$	@59.5 keV $[\%]$	channel	$[\mathrm{keV}]$	@59.5 keV [%]
1	2.8	51.9 ± 1.8	7	11.8	49.6 ± 1.4
2	4.6	47.5 ± 1.1	8	4.3	45.9 ± 1.4
3	8.0	$53.9{\pm}1.6$	9	11.7	48.3 ± 1.1
4	4.7	54.1 ± 1.8	10	4.1	54.4 ± 1.8
5	7.6	41.2 ± 1.5	11	6.6	54.4 ± 1.5
6	3.7	40.6 ± 0.8	12	12.5	52.7 ± 2.1

表 4.1 旧モデルの CsI(Tl)12 系統の LD レベルとエネルギー分解能@59.5keV

4.1.4 X線発生装置を使った偏光測定

5.2 節に示す X 線発生装置とビームラインを使った偏光測定について、検出器の正面から入射した場合と、斜め方向から入射した場合の測定結果を以下に示す。

正面入射

正面から入射した場合の偏光測定結果を図 4.2 に示す。測定結果から得られたモジュレー ションは $M' = 0.03899 \pm 0.00324$ である。シミュレーションから得られる 100% 偏光が入射 した場合の検出器のモジュレーションファクタ M は $M = 0.360 \pm 0.001$ であるので、この実 験から求められる X 線発生装置の偏光度は 9.32 ± 1.06 となる。X 線発生装置とビームライン を用いた場合の偏光度を平均すると $10.8 \pm 0.5\%$ であることが分かっているので、誤差の範囲 内で正しく測定できていると言える [3]。



図 4.2 旧モデルのモジュレーションカーブ。サインカーブをフィットして得られるモジュレーションは $M' = 0.03899 \pm 0.00324$ である。シミュレーションから得られる検出器の モジュレーションファクタ $M = 0.360 \pm 0.001$ を使って求められる偏光度は、 9.32 ± 1.06 である。

斜め入射

斜め方向から入射した場合の偏光測定結果を図 4.3 に示す。X 線発生装置の電場ベクトル面 に垂直な軸について検出器傾けて測定を行った。図 4.3 は正面入射の場合を 0° とし、5° ずつ 30° まで傾けた場合のモジュレーションカーブである。入射角度がきつくなるにつれて、本来 のモジュレーションよりも斜めの効果が支配的になることが分かる。この斜めの効果を補正 し、正しく偏光度を評価することが求められる。

この実験では、散乱体と吸収体の同期測定を行うコインシデンスモードと鉛シートによる 遮蔽で、CsI(Tl)に直接入射する光子を除外している。しかし、衛星搭載時には、複数の衛星 によってガンマ線が検出されるときに発生する時間差を用いて GRB の到来方向を決定する IPN (InterPlanetary Network)に参加することを考えている。このため、鉛を使った遮蔽を 行いたくない。そこで、鉛を含めたシールドの必要性を検討する必要がある [3]。



図 4.3 旧モデルの斜め入射モジュレーションカーブ。入射角度がきつくなるにつれて、本 来のモジュレーションよりも斜めの効果が支配的になる。

4.1.5 課題

これまでのモデルで行った基礎実験を通して明確になった課題を挙げる。検出器全体の重量 を 1500 g 以下にすること。プラスチックシンチレータと R1840-15 を VA-TA システムで信 号処理を行う場合の検出限界エネルギーを改善すること。CsI(Tl)12 系統のエネルギー分解能 を揃える補正を行うこと。斜め入射から得られるモジュレーションカーブの補正を行うこと。 鉛を含めたシールドの必要性を検討することが挙げられる。

4.2 検出器モデルの見直し



図 4.4 新しいモデル

新しい検出器モデルを図 4.4 に示す。プラスチックシンチレータは直径 130 mm、高さ 50 mm で、PMT の光電面の大きさの直径 46 mm に向かってテーパー加工を施した形状であ る。その周りを囲むように、12 枚の CsI(Tl) シンチレータ (高さ 50 mm× 幅 36 mm× 厚さ 3 mm) を配置している。プラスチックと CsI(Tl) の間は 5 mm の間隔を空けてある。プラス チックを読み出す PMT として R1840-12s、CsI(Tl) を読み出す PMT として R7400p を使用 する。

R1840-12s のブリーダー回路は表面実装部品を使用して設計した。また、CsI(Tl)12 枚それ ぞれを読み出す 12 個の R7400p は、表面実装部品を使用し、全てのブリーダーをドーナツ型 の基板に配置した設計になっている。

散乱型検出器で重要になるのは、プラスチックと R1840-12s での検出限界エネルギーである。検出限界エネルギーを改善することができれば、観測に利用できる光子数が増えるため、 偏光観測に有利になる。

4.3 EGS シミュレーション

EGS (Electron Gamma Shower) は任意の物質中での光子、電子、陽電子の輸送計算をモ ンテカルロ法によって行うコンピュータプログラムである。モンテカルロ法とは乱数を用いて 行う計算手法であり、EGS では物質中での放射線の動きを追跡するとき、光子や電子の反応 位置、反応の種類、反応後の粒子のエネルギーや方向などを乱数を用いて決定する。EGS で 扱う物理現象は、光電効果、コンプトン散乱、対生成、レイリー散乱、モラー散乱、制動放射、 バーバー散乱などである。EGS は放射線検出器シミュレーション、放射線診断、治療シミュ レーション、高エネルギー物理などの分野で幅広く使われている [1]。

4.4 プラスチックシンチレータの形状評価



図 4.5 4 種類のプラスチックシンチレータの形状。シンチレータの高さはいずれも 50 mm であり、テーパー加工は直径 46 mm に収束するように施されている。(a) は直径 130 mm のテーパーあり、(b) は直径 100 mm のテーパーあり、(c) は直径 100 mm のテーパーな し、(d) は直径 100 mm で高さ 25 mm にテーパーあり。

プラスチックシンチレータの形状を工夫することにより、重量を増やさずに有効面積 S を 大きくすること、中心付近からの光子を効率良く検出することでモジュレーションファクタ *M* を大きくすることができる。また、プラスチックシンチレータにテーパー加工を施すこと で PMT への集光効率を上げることができれば、検出限界エネルギーを改善することができる と考えられる。

ここでは、図 4.5 に示す 4 種類のプラスチックシンチレータを用意し、EGS シミュレーショ ンと実験を通して行った性能比較について示す。図 4.5 のプラスチックシンチレータの高さ は 4 種類とも 50 mm であり、テーパー加工が施された (a)、(b)、(d) については、読み出す PMT の光電面の大きさが直径 46 mm の円形であるため、直径 46 mm に収束するように設 計されている。(a) は直径 130 mm のテーパーあり、(b) は直径 100 mm のテーパーあり、(c) は直径 100 mm の円柱、(d) は直径 100 mm で高さ 25 mm の部分にテーパー加工が施された プラスチックシンチレータである。

4.4.1 平均自由行程

光子が物質に入射すると相互作用を行う。このとき、物質に対する光子の透過率は、入射放射線強度 I_0 、透過放射線強度 I、物質の密度 ρ [g cm⁻³]、質量吸収係数 σ [cm² g⁻¹]、厚さ l [cm] とすると、

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\rho\sigma l} \tag{4.1}$$

となる [8]。ここで、 $\tau = \rho \sigma l$ とすると、 $\tau = 1$ となる l が平均自由行程であり、光子が物質と相 互作用する平均的な距離である。入射光子のエネルギーが 100 keV の場合のプラスチックシン チレータの平均自由行程は、l = 6.07 [cm] である ($\rho = 1.03$ [g cm⁻³]、 $\sigma = 0.164$ [cm² g⁻¹])。

4.4.2 シミュレーションによる η

プラスチックシンチレータの形状による η の効果として、次のことが考えられる。プラス チックシンチレータの厚さが平均自由行程よりも薄いと、入射光子が相互作用を行わずにプラ スチックを抜けてしまい、 η が小さくなること。また、3.7.2 項で示したように、 η は入射光子 に対する散乱光子の極角 θ の積分範囲に依存するため、直径が大きなプラスチックでは η が小 さくなることが考えられる。

入射エネルギーごとの η を図 4.6 に示す。我々の検出器では、重量制限や性能から最適化を 行った結果、プラスチックの厚さが 50 mm になっている。図 4.6 から、テーパー加工を施し た部分は厚さが薄くなるため、厚さが薄い部分の面積が大きいモデルほど、 η が小さくなるこ とが分かる。また、他のモデルが直径 100 mm のところ、(a) のモデルは直径が 130 mm と大 きいことによって、 η が小さくなると考えられる (付録 C 参照)。

4.4.3 シミュレーションによる M

プラスチックシンチレータの形状による M の効果として、次のことが考えられる。3.7.1 項 で示したように、M は θ =90° で最大となるため、プラスチックの直径が大きいほうが M は 大きくなるはずである。一方で、直径が大きすぎると、1 回散乱した光子がプラスチックを抜 けるまでに自己吸収や多重散乱を起こすことで偏光情報が失われ、M が小さくなる可能性が ある。

入射エネルギーごとの *M* を図 4.7 に示す。(a) は直径が 130 mm と大きいため、(b)、(c)、 (d) の直径 100 mm の場合よりも *M* が大きくなると考えられる。(a)、(b)、(d) はテーパー加 工により、自己吸収や多重散乱の確率が低く抑えられ、*M* が大きくなると考えられる。ここ で、(a) と (b) の *M* はほとんど変わらない。これは、直径の大きい (a) で、散乱光子が自己吸 収や多重散乱を起こす確率が大きくなり、*M* が大きくなる効果が打ち消されているためであ ると考えられる (付録 C 参照)。



図 4.6 4 種類のプラスチックシンチレータの η。テーパー加工を施すことによって、入射光 子が相互作用する確率が小さくなり、η が小 さくなっていると考えられる。(a) では特に、 プラスチックの直径を大きくすることによっ て、CsI(Tl) での散乱光子の検出確率が小さ くなり、η が小さくなると考えられる。



図 4.7 4 種類のプラスチックシンチレータの *M*。直径が大きくなることによって *M* が大 きくなる効果が表れていると考えられる。ま た、テーパー加工を施すことによってプラス チック内での自己吸収や多重散乱の確率を低 く抑えられるために、*M* が大きくなると考え られる。

4.4.4 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$

3.7.3 項で示した MDP を用いて、総合的に偏光検出器の性能を評価するために $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ を導入する。図 4.8 にエネルギーごとの $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ を示す。(a) の直径 130 mm のモデルの $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ が最大となっている。(a) の η は小さいが、(b)、(c)、(d) の有効面積が S = 78.5 [cm²] であるのに対して、(a) は S = 133 [cm²] と約 1.7 倍大きい効果が最も効いていると考えられ る。また、 η 、S は 1/2 乗で作用するのに対して、M は 1 乗で作用するため、M が大きい効果も効いていると考えられる (付録 C 参照)。

4.4.5 集光効率と検出限界エネルギー

プラスチックシンチレータの検出限界エネルギー (LD レベル) は、散乱型検出器の性能を 決めるものであり、より低いエネルギーを検出することが求められる。集光効率が良くなる と、シンチレータ中で発生したシンチレーション光を効率良く PMT に導くことができるた め、PMT からの出力信号が大きくなる。シンチレータに入射した光子のエネルギーが同じで も、集光効率が良いと高いチャンネルに出力されることになる。また、LD レベルは PMT の 光電陰極から放出される熱電子に起因するランダムノイズレベルであり、集光効率が良くなれ ば相対的に LD レベルが改善されるはずである。

プラスチックの形状による、集光効率と検出限界エネルギーの変化を調べる。PMT とプラ スチックを使って測定した²⁴¹Am のスペクトルを図 4.9 に示す。(a)、(b)、(d) のテーパー モデルは、(c) の単純な円柱モデルよりも明らかに集光効率が良いことが分かる。直径が同じ



図 4.8 4 種類のプラスチックシンチレータの $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ 。M、 η 、S を総合的に評価すると、 (a) の直径 130 mm でテーパーつきのモデルが最適であると言える。(a) の η は小さいが、 (b)、(c)、(d) よりも有効面積が約 1.7 倍大きいこと、M が大きいことが効いていると考え られる。

100 mm で、異なるテーパー加工を施した (b) と (d) のモデルを比較すると、(b) のピーク チャンネルは (d) の約 1.05 倍であり、(b) のほうが多少集光効率が良いと言える。また、図 4.9 中に示すように、ピークチャンネルが高いモデルは、相対的に LD レベルが良いというこ とが分かった。

シンチレーション光はすべての方向に放出されるので、一部の光子は直接 PMT に入射する が、残りの光子は PMT に入射するまでにシンチレータの表面で数回反射される。しかし、反 射を繰り返せば光の損失が避けられず、PMT に入射する光子の割合が小さくなってしまう。 テーパー加工によって、シンチレータ表面で反射する光子を効率良く PMT に導くことができ ると考えられる。プラスチックにはテーパー加工を施したほうが有利であり、かつ、深いテー パー加工が有効であるという結果が得られた。

4.4.6 まとめ

プラスチックシンチレータの形状による性能の違いについて表 4.2 にまとめる。シミュレーションの結果について $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ を比較すると、(a) のモデルが最も有利であった。また、LD レベルと GAIN を比較した結果、プラスチックに大きくテーパー加工を施すことで集光効率



図 4.9 4 種類のプラスチックシンチレータの ²⁴¹Am のスペクトル。単純な円柱モデルよ り、テーパー加工を施したほうが集光効率が良くなることが分かる。また、厚さ 50 mm に 渡る深いテーパーのほうが、集光効率が良くなることが分かる。

が良くなることが分かった。4 種類のプラスチックシンチレータで最も有利な形状は、(a) の 直径 130 mm テーパーモデルであると言える。

表 4.2 プラスチックシンチレータの形状による性能

シミュレーションから得られた 100 keV における η 、M、 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ の値、実験から得られた LD レベル、GAIN を示す。GAIN は (a) の ²⁴¹Am のピークチャンネルを 1.00 としたときの ピークチャンネルの割合である。

	η	M	$M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$	LD レベル	GAIN
	$@100 \mathrm{keV}$	@100 keV	@100 keV	$[\mathrm{keV}]$	$@59.5 \mathrm{keV}$
(a) <i>ϕ</i> 130 mm テ ーパー	0.111	0.492	1.89	5.14	1.00
(b) <i>ϕ</i> 100 mm テーパー	0.148	0.499	1.70	4.80	1.02
(c) ϕ 100 mm 円柱	0.196	0.375	1.47	6.25	0.642
(d) <i>ϕ</i> 100 mm 半テーパー	0.175	0.425	1.58	5.33	0.973

4.5 ライトガイドの効果

4.4 節で述べたように、プラスチックシンチレータの形状は、単純な円柱型よりもテーパー 加工を施したもののほうが集光効率が良くなることが分かった。そこで、吸収体の CsI(Tl) シ ンチレータについても同様の効果があると考えられる。

CsI(Tl) は吸収体であるため、プラスチックを覆う面積を減らしてテーパー加工を施すと、 検出効率が下がってしまうため不利である。また、板状の CsI(Tl) を円形の光電面に収束する ように加工するにはコストがかかりすぎる。そこで、板状の CsI(Tl) を円形の光電面に収束す るようなライトガイドを作成し、その効果を検証する。

これまでに板状の CsI(Tl) について、PMT の接触面以外を反射率の高いテフロンテープで 覆った場合と、両側に 45°のテーパー加工を施した場合について GAIN 比較の実験を行って いる。²⁴¹Am 59.5 keV のピークチャンネルについて、後者が前者の 135% という結果が得ら れている。

4.5.1 Csl(Tl) とライトガイド

図 4.11 に示すように、CsI(Tl) 1 枚の大きさは 50 mm×36 mm×3 mm の板状で、有効光 電面 ϕ 8 mm の小型 PMT (R7400p) で読み出すため、集光効率が悪いことが予想される。そ こで、集光効率を良くするため、図 4.12 のように CsI(Tl) の底面 36 mm×3 mm を PMT の 光電面 ϕ 8 mm に収束させるライトガイドを作成する。CsI(Tl) とライトガイドの接合部分 は、CsI(Tl) の厚さが 3 mm と薄いため、ライトガイドに深さ 2 mm の溝を掘り、その溝に CsI(Tl) を埋め込む構造になっている。接合の際には、溝にシリコングリースを使用し、接合 部分に空気が入らないよう接着している。

ライトガイドを使用した場合と、使用しない場合について²⁴¹Am、¹⁰⁹Cd、バックグランド のスペクトル測定を行い、GAIN と LD レベルの変化を調べることで、ライトガイドの効果を 検証する。

4.5.2 **セットアップ**

ライトガイドを使用した場合のセットアップを図 4.10 に示す。CsI(Tl) とライトガイドを 接合し、その周り全体を反射率の高いテフロンテープで巻いた状態になっている。ライトガイ ドの下に R7400p が接着されている。ライトガイドを使用しない場合について、図 4.11 に示 す。CsI(Tl) はテフロンテープで巻いている。また、CsI(Tl) の底面で、PMT と接触していな い部分にも反射率の高いテフロンテープを巻き、光が逃げないようにしている。

4.5.3 結果

測定した 241 Am のスペクトルを図 4.13 に示す。ライトガイドありの場合、59.5 keV のピー クチャンネルは 1327 ch であり、LD レベルは 7.0 keV である。ライトガイドなしの場合、







図 4.10 ライトガイドを使用 した場合。CsI(Tl) とライト ガイドを接合し、ライトガイ ドと PMT の光電面を接着し た状態。CsI(Tl) とライトガ イド全体にテフロンテープを 巻いている。

図 4.11 ライトガイドを使用 しない場合。板状の CsI(Tl) と PMT の光電面を接着し た状態。CsI(Tl) の底面で PMT と接触していない部分 はテフロンテープを巻いて いる。

図 4.12 ライトガイドと CsI(Tl)の接合。ライトガイ ドに深さ 2 mmの溝を掘り、 その溝に CsI(Tl)を埋め込む 構造になっている。

ピークチャンネルは 1784 ch であり、LD レベルは 6.0 keV である。ライトガイドありの場合 のピークチャンネルは、ライトガイドなしの場合の約 74 % に落ちている。また、LD レベル も約 1 keV 悪くなっている。

4.5.4 ライトガイドの必要性

測定結果から、ライトガイドを使用することによって、集光効率が悪くなることが分かった。この原因として、以下の可能性が考えられる。まず、ライトガイドを使用したことによって、CsI(Tl)から PMT までの距離が長くなっているため、光子がライトガイドで自己吸収している可能性が考えられる。しかし、ライトガイドはプラスチックの平均自由行程よりもよりもかなり小さいため、この効果は少ないと考えられる。

次に、CsI(Tl) とライトガイドの屈折率の違いによる境界面での全反射が考えられる。シン チレーション光がシンチレータの表面に到達した場合、入射角 θ が臨界角 θ_c よりも大きけれ ば全反射が起こり、 θ が θ_c よりも小さいと一部は反射し、一部は透過する。臨界角 θ_c は、シ ンチレータの屈折率を n_0 、周囲の物質の屈折率を n_1 とすると、

$$\theta_{\rm c} = \sin^{-1} \frac{n_1}{n_0} \tag{4.2}$$

と表すことができる。今回作成したライトガイドの素材はプラスチックであり、一般的なプラ スチックの屈折率は約 1.6、CsI(Tl)の屈折率は 1.8 である。式 4.2 から臨界角は $\theta_c = 62.7^\circ$ となる。CsI(Tl)の方が屈折率が大きいため臨界角が小さくなり、境界面では全反射しやすく なってしまう。

原因究明は今後の課題であるが、いずれにしても、ライトガイドを使用する必要はないこと



図 4.13 ライトガイドがあるときとないときの ²⁴¹Am のスペクトル。ライトガイドあり の場合 (黒)、²⁴¹Am 59.5 keV のピークチャンネルは 1327 ch である。ライトガイドなし の場合 (赤)、ピークチャンネルは 1784 ch である。ライトガイドを使用することによって、 集光効率が悪くなっていることがわかる。

になる。また、ライトガイド1つの重さは 5.7 g であり、12 個では 68.4 g にもなる。衛星搭載の際には重量制限があるため、ライトガイドを使用する利点はないと考えられる。

4.6 回路基板とケースの改良

検出器の軽量化を行うため、回路基板とアルミケースの改良について述べる。

4.6.1 表面実装部品を使用した回路基板

これまでのモデルでは PMT のブリーダー回路は既製品を使用していた。また、高圧分岐回 路などの PMT 周辺の回路については、通常の電子部品を装着したプリント基板を作成してい た。このため、基板自体が大きくなり、部品も多いため、重量が重くなっていた。そこで、新 しいモデルでは基板の表面に部品を実装する設計に改良し、小型化、高密度化、軽量化が実現 している。

表面実装部品とはプリント基板の表面にはんだ付けのみによって実装することができるように製造された電子部品である。図 4.14 に示すように、今回使用した表面実装部品は、全て数 mm 単位の部品で、最も大きいもので 4.5 mm×2.0 mm×1.5 mm である。

新しいモデルの回路内で使用されている部品は全て表面実装部品である。設計したプリント基板を図 4.15 に示す。R7400p のブリーダー回路を含む高圧分岐回路、VA-TA 前の信号処理回路などをまとめた円盤状の回路基板には 12 個の R7400p が取り付けられている。中心のPMT が R1840-12s であり、ブリーダー回路基板は PMT の奥に取り付けられている。



図 4.14 通常の部品と表面実装部品



図 4.15 新しく設計したプリント基板と PMT

4.6.2 アルミケース

回路基板や PMT、シンチレータをシンプルに固定する設計にしたため、ケースに特殊な加 工を施さずに、アルミを 1 mm の厚さまで薄くすることができた。その結果、434 g の軽量化 に成功した。実際の衛星搭載時には、検出器の耐震化を行う必要があり、PMT やシンチレー タの固定を慎重に行うべきである。このモデルの固定方法では不十分である可能性があり、さ らなる工夫が必要であると考えられる。



図 4.16 検出器の外観

4.7 軽量化

衛星搭載時の重量制限を想定し、検出器全体で 1500 g のモデルを作成したい。これまでの モデルは、プラスチックシンチレータが直径 100 mm の 12 角柱で、その周りを囲むように 12 枚の CsI(Tl) シンチレータが配置されたモデルであった。これまでのモデルと新しく作成した モデルの重量比較を表 4.3 に示す。

これまでの ϕ 100 mm 12 角柱モデルの性能は、表 4.2 (c) の ϕ 100 mm 円柱モデルの性能に 近似する。プラスチックシンチレータの形状を変えたことによって、 ϕ 100 mm 12 角柱モデ ルから性能向上を行うことができたが、直径が 100 mm から 130 mm に大きくなったことに よって、プラスチックを囲む CsI(Tl) の重量が重くなってしまい、シンチレータの重量は 46 g 増加した。R1840 のブリーダー回路基板と円盤回路基板について、表面実装部品を使ったプリ ント基板を設計したことによって、合わせて 126 g の軽量化に成功した。アルミボックスは、 耐久性に問題がない程度に、最も薄い部分で 1 mm の厚さで設計し、434 g の軽量化を行っ た。検出器全体として 449 g の軽量化を行うことができ、1365 g で作成することができた。

表 4.3 重量比較

新しく作成した ϕ 130 mm テーパーモデルと、これまでの ϕ 100 mm 12 角柱モデルについて の重量比較を示す。プラスチックシンチレータの形状を変えたこと、高圧回路、読み出し回路 に表面実装部品を使ったこと、アルミボックスの改良によって、検出器全体として 499 g の軽 量化を行うことができた。

項目	<i>ϕ</i> 130 mm テ −パー [g]	<i>φ</i> 100 mm12 角柱 [g]
プラスチック	346	405
CsI(Tl)	312	207
R1840	107	126
R7400p	63.6	63.6
回路基板と部品	59.6	167
アルミボックス	411	845
ねじ・コネクタ等	66.0	
合計	1365	1814

4.8 VA-TA

偏光検出器からの信号処理には、クリアパルス製の 80154 型マルチアノード光電子増倍管 ヘッドアンプユニット、80057 型 PMT Data Processor (DP) を使用する。これは、ヘッドア ンプユニットに搭載された VA-TA と呼ばれるアナログ LSI を使用した信号処理システムで ある。



図 4.17 ヘッドアンプ内の概念図

4.8.1 信号処理システム

ヘッドアンプには VA-TA と呼ばれるアナログ LSI が搭載されている。VA チップは、電荷 増幅器 (CSA)、時定数 2 μ sec の波形整形増幅器 (Shaping Amp)、サンプルホールド、マル チプレクサから構成される。TA チップは、時定数 75 nsec のトリガー用高速波形整形増幅器 (Fast Shaping Amp)、ディスクミネータで構成される。

検出器からの信号は、CsI(Tl) 12 チャンネルとプラスチック 1 チャンネルの合計 13 チャン ネルである。全チャンネルの信号は VA チップに入力され、CSA で増幅されて Shaping Amp へと送られる。Shaping Amp からの出力はサンプルホールド回路に入力される。この一方 で、CSA の出力が分岐されて TA チップに入力される。TA チップに入力された信号は Fast Shaping Amp により整形され、ディスクリミネータに入力される。ディスクリミネータの出 力は OR 回路に入力され、Nずれかのチャンネルの信号がディスクリミネータで設定したエネ ルギー閾値を越えると、トリガー信号が出力される。このとき、トリガー信号に寄与するチャ ンネルは制御ソフト上で設定することができる。TA チップから DP にトリガー信号が出力さ れると、DP は VA チップにサンプルホールド ON の命令を行う。DP からの命令によって、 サンプルホールドされた各チャンネルの信号がマルチプレクサによって読み込まれる。読み込 まれたデータは DP に送られ、A/D 変換を行った後 PC に送られる [3]。

サンプルホールド

トリガーからサンプルホールドまでの時間は tHOLD よって設定することができる。しか し、現在のシステムでは 1.4-2.5 μsec 程度の調節しか行うことができないため、PMT からの 出力波形のピーク値をホールドしていないと考えられる。このため、VA-TA による信号処理 では、PMT の性能を十分引き出せない可能性がある [3]。

4.9 コインシデンス

プラスチックに入射してエネルギーを落とすものには、観測対象からのフラックス、バック グランドが考えられる。また、CsI(Tl)ではプラスチックからの散乱成分、観測対象からの直 接フラックス、バックグランドが考えられる。

プラスチックシンチレータでのコンプトン散乱イベントと、CsI(Tl) での光電効果イベントの同期 (コインシデンス) を取ることによって S/N 比が良くなり、偏光検出に有利になる。

観測対象のフラックスが強すぎると、プラスチックでの散乱イベントに同期して CsI(Tl) に 直接入射したイベントが、コインシデンスイベントとしてカウントされてしまう可能性が高く なる。X線発生装置とビームラインを用いた場合にはフラックスが強すぎるため、このような 疑似コインシデンスが起こりやすくなる。確実にコインシデンスを取るために、エネルギー範 囲を指定したコインシデンスを行う。

コインシデンス方法はトリガーを立てるチャンネルの選びかたによって2通り考えられる。 プラスチックでコンプトン散乱したイベントでトリガーを立て、CsI(Tl)のシグナルを読み込 むというものと、CsI(Tl) で検出されたイベントでトリガーを立て、プラスチックに同期した イベントがある場合はそのシグナルを読み込むというものである。

ここでは、プラスチックのイベントにトリガーを立てる方法について述べる。プラスチック とR1840-12sのシステムで⁵⁷Coを測定したときのスペクトルを図 4.18に示す。コインシデ ンスを取らずに測定したスペクトル(黒)では 122 keV に光電ピーク、40 keV 付近にコンプト ンエッジを確認することができる。赤のスペクトルは、以下に示すコインシデンスモードで測 定したものである。



図 4.18 プラスチックと R1840-12s で測定した ⁵⁷Co のスペクトル。コインシデンスを取らない場合のスペクトル (黒) と、コインシデンスを取った場合のスペクトル (赤)。

コンプトン散乱イベントのみを取り出すために、トリガーに寄与するエネルギー範囲を決める。 57 Coの放射の 85.6% を占める 122 keV が 90°方向にコンプトン散乱したときにプラス チックに落とすエネルギーは 23.5 keV である。偏光観測について言えば、3.6.3 節で示した ように $\theta = 90^\circ$ 方向で最も強く偏光が観測されるため、低エネルギー側は 23.5 keV 以下にし たい。図 4.18 のスペクトル (黒) から、ノイズによるトリガーを落とすため、20 keV とする。 高エネルギー側は光電効果によるトリガーを落とすために、スペクトル (黒) から 80 keV と する。

同時に、CsI(Tl) を使ったイベントセレクションを行う。CsI(Tl) では 20 keV 以上のエネ ルギーを扱うこととする。図 4.19 に示すように、疑似コインシデンスの可能性として、プラ スチックでのトリガーと同時に CsI(Tl) に直接入射する場合が考えられる。この場合、1 つの



図 4.19 コインシデンスイベントと CsI(Tl) への直接成分

トリガーに対して CsI(Tl) の 2 チャンネルにシグナルがあることになるため、このようなイベ ントを除外し、プラスチックと CsI(Tl) が 1 対 1 のイベントのみを扱う。

図 4.18 の赤のプロットはコインシデンスモードで測定した ⁵⁷Co のスペクトルである。コ インシデンスを取らずに測定したスペクトル(黒)で見えていた 40 keV のコンプトンエッジが ほとんど見えなくなっている。図 4.4 に示した検出器では、プラスチックの正面から入射して 180°方向に散乱した場合、CsI(Tl)での検出は幾何学的に困難である。つまり、プラスチック でのトリガーに対応する CsI(Tl)のシグナルがないため、このイベントは除外されることにな る。コンプトンエッジが消えたことはコインシデンスが取れている証拠であると言える。

4.10 プラスチック用 PMT R1840-12s の検出限界エネルギー

これまでの検出器ではダイノード 10 段の PMT (R1840-15) を使用していたが、十分な GAIN が得られず、LD レベルは 12.0 keV であった。100 keV の入射光子が 90° 方向にコン プトン散乱を起こすと、プラスチックには 16.37 keV のエネルギーを落とすため、実験室レベ ルでは十分な性能である。しかし、実際に GRB の偏光観測を行うためには LD レベル 7 keV を達成し、入射エネルギーにして 60 keV 程度の光子を偏光観測に利用することが理想である。 新しいモデルでは、プラスチックを読み出す PMT として、ダイノード 12 段の R1840-12s を使用する。ここで、直径 130 mm テーパー加工のプラスチックと R1840-12s についての性 能評価を行う。

4.10.1 セットアップ

図 4.20 に示すようなセットアップで、図 4.5 (a) のプラスチックシンチレータと R1840-12s で 241 Am、 109 Cd、バックグランドのスペクトル測定を行った。このとき信号処理には VA-TA

EC= 41.01 , EW= 15.41 , EN= 316.2



図 4.20 プラスチック ϕ 130 mm テーパーモデルと R1840-12s



図 4.21 プラスチック ϕ 130 mm テーパーモデルと R1840-12s の性能評価。このシステム での検出限界エネルギーは 10.2 keV である。これにより、77.5 keV 以上のエネルギーを 持った光子が観測対称となる。

を用いた。

4.10.2 結果

測定したスペクトルを図 4.21 に示す。LD レベルは 10.2 keV という結果が得られた。これ は、77.5 keV の入射光子が 90° 散乱したときに落とすエネルギーであり、偏光観測対象とな る光子のエネルギーは 77.5 keV 以上となる。

GRB の偏光観測を行うためには不十分である。この理由として信号処理に用いた VA-TA の問題が挙げられる。我々のシステムでは、VA-TA を使用して波高のピーク値を出力することが困難であり、PMT からの出力が VA-TA の処理によって低く出力されていると考えられる。

4.11 Csl(TI) 用 PMT R7400p の検出限界エネルギー

プラスチックシンチレータの周りを囲む 12 枚の CsI(Tl) シンチレータを読み出すのは光電 面 $\phi 8 \text{ mm}$ の R7400p である。CsI(Tl) で検出するのは、プラスチックでコンプトン散乱を起 こした散乱光子である。我々が目指す 60 keV の光子が 90° 方向に散乱した場合でも 50 keV を検出する性能があれば十分である。CsI(Tl) と R7400p 12 系統の性能評価を行う。

4.11.1 セットアップ

4.5.2 節で示した、図 4.11 のようにセットアップした 12 系統それぞれについて、²⁴¹Am、 ¹⁰⁹Cd、バックグランドのスペクトル測定を行う。このときの信号処理には、プラスチックの 場合と同様に VA-TA を用いる。

4.11.2 結果

測定した 12 系統の ²⁴¹Am のスペクトルを図 4.22、それぞれの LD レベルとエネルギー分 解能を表 4.4 に示す。CsI(Tl) 12 系統の LD レベルは全てが 10 keV 以下であり、GRB 観測 にも十分な性能であると言える。表 4.1 に示したように、以前のモデルのエネルギー分解能 は平均して 49.5 % であったが、新しいモデルでは平均で 35.1 % になっている。この原因と して、プラスチックの直径が 100 mm から 130 mm に大きくなったことで、その周りを囲む CsI(Tl) の幅が 25.5 mm から 36 mm に広くなったことが考えられる。エネルギー分解能が悪 くなると、CsI(Tl) で検出されたスペクトルを使って特定のエネルギー領域の偏光度を求める ことが難しくなる。つまり、これまでのモデルで課題となっていたエネルギー分解能を揃える 補正はさらに困難になったと言える。



図 4.22 CsI(Tl) と R7400p 12 系統の²⁴¹Am のスペクトル

表 4.4 CsI(Tl) 12 系統の LD レベルとエネルギー分解能@59.5 keV

CsI(Tl)	LD レベル	エネルギー分解能	CsI(Tl)	LD レベル	エネルギー分解能
channel	$[\mathrm{keV}]$	$@59.5 \mathrm{keV} \ [\%]$	channel	$[\mathrm{keV}]$	$@59.5 \mathrm{keV} \ [\%]$
1	9.87	$34.3{\pm}1.6$	7	8.87	$31.0{\pm}1.9$
2	1.62	$33.0{\pm}1.7$	8	8.35	$38.2 {\pm} 4.0$
3	4.75	$32.9{\pm}1.5$	9	3.85	40.9 ± 1.5
4	3.69	38.1 ± 2.0	10	4.81	$33.6{\pm}1.5$
5	2.26	44.2 ± 1.8	11	6.93	27.8 ± 1.3
6	2.53	34.3 ± 1.3	12	8.43	$32.4{\pm}1.2$

4.12 エネルギー較正

モジュレーションカーブを描くため、それぞれの CsI(Tl) で得られるスペクトルから散乱 光子強度を計算する。CsI(Tl) と R7400p の 12 系統はそれぞれ GAIN が異なるため、エネル ギー較正を行い、任意のエネルギー範囲で積分することによってモジュレーションカーブを 描く。

4.12.1 リニアリティ

エネルギー較正用の放射線源として、²⁴¹Am、¹⁰⁹Cd、⁵⁷Coのスペクトルを測定する。²⁴¹Am 59.5 keV、¹⁰⁹Cd 22.67 keV、⁵⁷Co 122 keV のピークについてガウスフィットを行い、得ら れるピークチャンネルから CsI(Tl) 12 系統のリニアリティを求める。エネルギー較正前後 の²⁴¹Am のスペクトル図 4.23、図 4.24 に示す。図 4.23 の横軸はチャンネル領域であり、図 4.24 の横軸はエネルギー領域である。チャンネル領域のスペクトルではピークがばらばらで あるが、エネルギー領域のスペクトルではある程度ピークが揃っていることがわかる。



4.12.2 問題点と改善方法

CsI(Tl) 12 系統のリニアリティを図 4.25 に示す。スペクトルのフィットから得られるピー クチャンネルをプロットすると、リニアリティの直線に乗らない場合がある。図 4.25 の 12ch では、プロットが直線上になく、とくに ⁵⁷Co 122 keV は大きくずれている。

この原因について次のことが考えられる。4.11節で示したように、CsI(Tl)のエネルギー分解能が低いため、スペクトルの最適なフィットがうまくできていない可能性が考えられる。また、CsI(Tl)の面積が大きくなったことによって、CsI(Tl)と放射線源の位置関係によってシンチレーション光の集まり方に違いが生まれ、GAINが微妙に変化している可能性が考えられる。さらに、放射線源の強度が強すぎると、シンチレーション光が重なること、PMT後の信



図 4.25 CsI(Tl) 12 系統のリニアリティ。それぞれ、横軸がエネルギー [keV] で縦軸が チャンネルである。
号処理回路においてパルスが互いに重畳することによってスペクトルが崩れ、分解能を悪くす る可能性がある。

エネルギー分解能を改善することは困難であるが、エネルギー較正のスペクトル測定を行う 場合に、CsI(Tl)と放射線源の距離をなるべく離し、CsI(Tl)の全面に一様に照射するような セットアップが必要であると考えられる。

4.13 GRB 検出可能性

新しい検出器の性能で観測が期待される GRB 数とその偏光度を見積もる。ここでは、 BATSE の 4B カタログの 1972 個の GRB の明るさ F と継続時間 T を利用し、一般的な CXB (Cosmic X-ray Background) スペクトル、宇宙線スペクトルからバックグランド B を 求め、MDP に対する年間観測可能な GRB 数を示す。

4.13.1 バックグランドの見積り

偏光観測を行う場合には、プラスチックで散乱して CsI(Tl) で吸収される、1 対1 のコイン シデンスイベントのみを検出する。我々の検出器では 50-300 keV のガンマ線を主な観測対象 としているため、それ以外のガンマ線を落とすための閾値を設定している。低エネルギー側の 閾値 (Lower Discriminator : LD) はプラスチックシンチレータの検出限界エネルギーで決ま る。また、高エネルギー側の閾値 (Upper Discriminator : UD) を設定することにより、バッ クグランドを落とすために使用することができる。非常に高エネルギーの粒子が検出器を突き 抜ける際に検出される信号は 300 keV よりも高いため、UD により区別することができる。

我々の検出器で主なバックグランドとなるのは、プラスチックで散乱して CsI(Tl) で吸収される、コインシデンスと UD で落とせないイベントである [1]。

CXB

宇宙空間には等方的な X 線の放射 (CXB) が存在する。 \sim 3–300 keV 領域のバックグ ランドは活動銀河核 (AGN) 起源、低エネルギーガンマ線領域 (\sim 300 keV<E<10 MeV) のバックグランドは 1a 型超新星起源であると考えられている。CXB の光子スペクトル N(E) [photon keV⁻¹ cm⁻² sec str] は以下のように書くことができる [11]。

$$N(E) = 7.877 E^{-1.29} \exp\left(-\frac{E}{41.13}\right) , \quad 3 - 60 \text{ keV}$$

$$(4.3)$$

$$= \left(\frac{0.0259}{60}\right) \left(\frac{E}{60}\right)^{-1} + \left(\frac{0.504}{60}\right) \left(\frac{E}{60}\right)^{-2.05} + \left(\frac{0.0288}{60}\right) \left(\frac{E}{60}\right)^{-2.05} , > 60 \text{ keV}$$
(4.4)

検出器前面の立体角 2π [str] から一様な放射が入射するとして、単位面積、単位時間あたり に入射する 10-300 keV の光子のうち、プラスチックで散乱され、CsI(Tl) で吸収される確率 を $\epsilon(E)$ 、極角を θ 、方位角を ϕ とすると、コインシデンスで落とせないバックグランド H は、

$$H = \int_{10}^{300} N(E)\epsilon(E) dE \int_0^{\pi} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \quad \text{[photon cm}^{-2} \text{ sec}^{-1]}$$
(4.5)

となる。このとき、プラスチックの検出限界エネルギーである 10 keV 以上の一様な放射の バックグランドを考慮するため、10-300 keV について計算を行う。

実効的なバックグランドは検出器の前面、背面、側面から入射し、コインシデンスで落とせ ないイベントである。検出器の前面、背面、側面に立体角 2π 方向から一様な放射が入射した 場合の検出効率のシミュレーション結果を使ってバックグランドを求める。

$$B = HS$$

= $H_{\rm f} \times 7^2 \pi + H_{\rm b} \times 7^2 \pi + H_{\rm s} \times 14.6\pi \times 5$
= 23.86 + 20.71 + 0.002548
= 45 [photon sec⁻¹]

宇宙線

宇宙空間には宇宙線 (Cosmic ray) と呼ばれる高エネルギーの放射線が存在する。そのほと んどが陽子であり、若干のヘリウム原子核を含む。宇宙線は起源により、太陽宇宙線と銀河宇 宙線に分類される。太陽宇宙線は太陽表面の爆発により生成され、11 年周期の太陽活動の活 発な時期に合わせて多くなる。銀河宇宙線は銀河系内に起源を持ち、超新星残骸の衝撃波加速 によって非常に高エネルギーの粒子が生成されると考えられている。

これらの粒子は平均数 100 MeV と高エネルギーであるため、検出器全体を突き抜ける。こ れらの高エネルギー粒子が検出器に作る信号は非常に大きいため、UD により落とすことがで きると考えられる。UD で落とせない少数の宇宙線のうち、プラスチックと CsI(Tl) 2 箇所以 上で検出されたイベントはコインシデンスによって落とすことができる [1]。

4.13.2 MDP

MDPはある条件下 (検出器の性能、観測対象の明るさ、観測時間、バックグランド) で偏光 観測を行ったときに観測可能な最小の偏光度である。式 3.41 から、3 σ での MDP は、

$$MDP = \frac{3\sqrt{2}}{\eta SFM} \sqrt{\frac{\eta FS + B}{T}}$$
(4.6)

 $S: 有効面積 [cm²] \eta: 検出効率$ F: 観測対象の明るさ [photon cm⁻² s⁻¹] M: モジュレーションファクタB: バックグランド [photon s⁻¹] T: 観測時間 [s]

となる。バックグランドは CXB のスペクトルから計算した値を使用し、GRB のフラックス



図 4.26 ある MDP で年間観測可能な GRB 数。黒は検出器の見込む全視野 $(\pm 90^{\circ})$ につ いて、赤は視野を $\pm 30^{\circ}$ に限定した場合である。実際に有意な観測を行うことができる視 野は $\pm 30^{\circ}$ 程度であり、GRB が 50% 偏光していれば、1 年間に観測が期待される GRB は約 2 個である。

と継続時間は BATSE の 4B カタログの 1972 個の GRB データを使用する。我々の検出器が 偏光観測を行うことができる視野は中心から片側 30° 程度の領域であるので、有効立体角は、

$$\int_{0}^{2\pi} d\phi \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta \, d\theta = \frac{\pi}{4} \, [\text{str}] \tag{4.7}$$

となる。また、BATSE は全天の 48.3% を 9 年間観測していたので、ある MDP に対して 1 年間に視野内で起こる GRB 数は、以下のようになる。

ある MDP での GRB 数 =
$$\frac{\frac{\pi}{4}}{4\pi \times 0.483 \times 9}$$
 [個 year⁻¹] (4.8)

新しい検出器で年間観測可能な GRB 数を MDP ごとにプロットしたものを図 4.26 に示す。 MDP の値が1に近づくということは、偏光度が非常に高い GRB を期待することになり、暗 い GRB でも偏光観測を行うことができるようになるため、観測可能な GRB 数が増える。逆 に MDP が小さくなると偏光観測を行うことができるのは明るい GRB に限られ、観測可能な GRB 数は減ってしまう。黒のプロットは検出器の見込む全視野 $(\pm 90^{\circ})$ について観測可能な GRB 数であり、赤のプロットは視野を $\pm 30^{\circ}$ に限定した場合である。実際に有意な観測を行 うことができる視野は $\pm 30^{\circ}$ 程度であり、GRB が 50% 偏光していれば 1 年間で観測が期待さ れる GRB は約 2 個である。

第5章

偏光検出性能の評価

新しい検出器で無偏光、偏光を測定したときの実験状況と結果を示し、以前のモデルでの実 験結果と比較する。さらに、宇宙空間で偏光を検出する場合に想定される斜めからの入射につ いての実験を行い、シミュレーションによる補正について考察する。

5.1 無偏光測定実験

無偏光放射線源である⁵⁷Coの偏光測定を行う。無偏光な放射には散乱強度分布がないため、測定結果からモジュレーションカーブは、フラットになるはずである。偏光光源を使った 測定の準備として無偏光光源の測定を行い、偏光検出器の重要な要素である幾何学的対称性を 調べる。

5.1.1 **セットアップ**

幾何学的対称性を調べるためには、検出器に入射する放射が一様な平行光線である必要があ る。平行光線にするために⁵⁷Coを検出器から離し、一様な入射にするために⁵⁷Coと検出器 の中心を合わせて配置する。プラスチックのみに入射させるため、CsI(Tl)は4 mmの鉛で 覆っている。セットアップの様子を図5.1に示す。また、散乱イベントのみを取り出すために コインシデンスモードで測定を行い、測定時間は2000 secである。長時間測定によるバック グランドの影響を取り去るため、同じセットアップでバックグランドの測定を行った。

5.1.2 結果

測定から得られた CsI(Tl) のスペクトルを 20-600 keV のエネルギー範囲で積分し、散乱角 度による強度分布を計算する。横軸を散乱角度、縦軸を強度として、プロットしたモジュレー ションカーブを図 5.2 に示す。このモジュレーションカーブは最大で ±0.802% の揺らぎがあ る。ここで、得られたデータについて y = a のコンスタントフィットを行うと、 $\chi^2_{\nu} = 0.717$ (自 由度 12) となった。この結果から、モジュレーションカーブは約 70% の確率でコンスタント であると言える。つまり、偏光検出器は幾何学的対称性があると考えられる。



図 5.1 無偏光測定実験のセットアップ。一様な平行光線を入射するため、⁵⁷Coを検出器から離し、中心を合わせて配置している。また、プラスチックのみに入射するため、CsI(Tl)を4 mmの鉛で覆っている。



5.1.3 比較

以前のモデルで行った 57 Co の測定では、モジュレーションカーブは最大で $\pm 0.895\%$ の揺らぎがあり、今回と同様にコンスタントフィットを行った結果、 $\chi^2_{\nu} = 1.36$ (自由度 11) という結果が得られている。

無偏光の測定では、検出器の対称性と放射線源の配置が大きく影響する。仮りに、放射線源 によるモジュレーションカーブの揺らぎを無視すれば、実験結果から、新しいモデルのほうが 幾何学的対称性を持った検出器であると言える。実際、新しいモデルでは、プラスチックに大 きくテーパー加工が施されているため、プラスチックと CsI(Tl) 12 枚の距離の違いによる幾 何学的対称性の崩れは以前のモデルよりも小さいと考えられる。

5.2 X線発生装置とビームライン



図 5.3 X 線発生装置とビームライン。手前に X 線発生装置があり、5 m のビームライン を通って奥に検出器のマウント部分がある。ビームラインの内部は鉛が巻かれており、安全 に実験を行うことができる。

5.2.1 X線発生装置

フィラメントに電流を流し、そこで放出された熱電子を高電圧で加速し、ターゲットに衝突 させる。ターゲットに衝突すると電子は減速し、制動放射によって X 線を放射する。一定方 向から電子を飛ばしてターゲットと衝突させる制動放射では、電子が受ける加速度ベクトルと X 線の進行方向がなす面に直線偏光した連続 X 線が放射される。 今回の実験に使用した X 線発生装置は、東芝製のミニフォーカス X 線発生装置 EXM-101A5B である。電子の加速電圧に相当する管電圧は 1 kV ごとに 40–100 kV 範囲で設定す ることができる。電子ビームの強度に相当する管電流はフィラメントの電流制御によって行わ れており、100–500 μ A、10–50 μ A、1–5 μ A の範囲で設定することができる。X 線の照射範 囲はハーフアングル 7.5°の円錐である。

5.2.2 ビームライン

X 線発生装置を使った偏光測定において、照射範囲がハーフアングル 7.5°の円錐状である こと、X 線発生強度が非常に強いことが問題となっていた。そこで、強度を落とした平行光線 をつくり出すため、実験室に 5 m のビームラインを作成した。

ビームラインの真空管は内径 20.3 cm、全長 500 cm である。検出器マウント部分に届く X 線は、ハーフアングル 1.15°の円錐内に照射されたものであり、ほぼ平行光線で入射している といえる。

ハーフアングル 7.5°の立体角を 1 とすると、ハーフアングル 1.15°の立体角は 2.4×10^{-2} である。また、 20° C、760 torr の空気中で、100 keVの X 線が 5 m 進むと、10%の X 線が散乱されることが分かっている。X 線発生装置の放射がハーフアングル 7.5°の円錐内に一様であると仮定すると、ビームラインによって、X 線発生強度を 2.1×10^{-3} 倍に落とすことができることになる [3]。

5.2.3 スペクトル

非常に分解能が良い CdTe 検出器で測定した X 線発生装置のスペクトルを図 5.4 に示す。 また、X 線発生装置の強度を落とすために厚さ 2 mm の Sn 板と Cu 板を挿入した場合のスペ クトルを図 5.5 に示す。

ビームラインによって検出器マウント部分の X 線強度を落とすことができたが、それでも 強度が強く実験が困難であった。そのため、X 線発生装置の照射窓に厚さ 2 mm の Sn 板と Cu 板を取り付けて、低エネルギー側の成分を落としている [3]。以後、X 線発生装置の偏光測 定は Sn 板と Cu 板を取り付けた、図 5.5 のスペクトルについて行うこととする。

5.2.4 偏光度

X 線発生装置とビームラインを用いた場合に検出器マウント部分で得られる偏光度につい て示す。検出器マウント部分のビームラインの中心に、散乱体として $2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ のプ ラスチックシンチレータを置き、中心から 5 cmの円周上に吸収体として $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ の CsI(Tl) シンチレータを置く。中心から <math>5 cmの円周上を 0° から 360° まで 30° 刻みで CsI(Tl)を回転させ、その角度ごとにスペクトルを測定する。このとき X 線発生装置の加速電 圧は 100 kV に設定している。

エネルギー帯ごとの角度によるスペクトル強度分布から得られたモジュレーションカーブを 図 5.7 に示す。このモジュレーションカーブをフィットすることで、振幅と強度分布の平均が



図 5.4 CdTe 検出器で測定した加速電圧 100 kV の X 線発生装置のスペクトル。制 動放射による連続成分と光電ピークが見ら れる。

Xray spectrum 100keV Sn+Cu

104

Counts

図 5.5 厚さ 2 mm の Sn 板と Cu 板を通過 した後の X 線発生装置のスペクトル。低エネ ルギー側の成分が落ちていることが分かる。

得られ、式 3.39 からこのときのモジュレーションを計算することができる。それぞれのエネ ルギー帯でのモジュレーションを図 5.8 に示す。このシステムで、プラスチックに 100% 偏光 が入射した場合のモジュレーションファクタ M をシミュレーションから計算し、式 3.40 から 偏光度を計算することができる。それぞれのエネルギー帯での偏光度を図 5.9 に示す。



図 5.6 X 線発生装置モジュレーション測定のセットアップ。プラスチックと CsI(Tl) は 回転板に固定されている。回転板を 30° ずつ回転させながら X 線発生装置のスペクトルを 測定する。



図 5.7 エネルギー帯ごとのモジュレーショ ンカーブ。角度ごとに CsI(Tl) で得られたス ペクトルをそれぞれのエネルギー帯で積分す ることによって散乱強度分布を得る。



図 5.8 実験から得られるモジュレーション。 図 5.7 のモジュレーションカーブから得られ る振幅と強度分布の平均を使って、式 3.39 か ら計算できる。



図 5.9 X 線発生装置とビームラインを用いた場合の偏光度。シミュレーションから得られるこのシステムのモジュレーションファクタ M と実験から得られるモジュレーション M'を使って、式 3.40 から計算できる。

5.3 正面入射の偏光測定実験

X線発生装置とビームラインを用いた偏光測定を行う。測定によるモジュレーションから求められる偏光度が、X線発生装置の偏光度を正しく見積もっているかを検討する。

5.3.1 セットアップ

ビームラインで作られた平行光線が検出器の真正面から入射するように、検出器の正面が ビームラインのフランジ面と平行になるように配置する。X線発生装置の強度が非常に強い ため、コインシデンスを取っていても疑似コインシデンスの確率が高くなってしまう。そこ で、図 5.10 のようにプラスチックシンチレータ以外の検出器部分を4 mm の鉛で覆い、プラ スチックの全面だけに一様に光子が入射する状況を作り、コインシデンスイベントのみを取り 出す。



図 5.11 検出器マウント部分

図 5.10 偏光測定実験のセットアップ。検出器の正面 がビームラインのフランジ面と平行になるように配置 する。プラスチック以外の部分は 4 mm の鉛で覆う。

5.3.2 結果

図 5.7 に、測定から得られた CsI(Tl) のスペクトルを 20-200 keV のエネルギー範囲で積分 し、横軸に散乱角度、縦軸に強度をとったモジュレーションカーブを示す。モジュレーション カーブをフィットすることによって得られた平均・振幅から、測定によるモジュレーション *M*' は、式 3.39 により、

モジュレーション
$$M' = \frac{N_{\text{max}} - N_{\text{min}}}{N_{\text{max}} + N_{\text{min}}} = \frac{\sin \mathcal{O}_{\text{K}} \mathrm{i} \mathrm{k} \mathrm{i}}{\mathrm{i} \mathrm{g} \mathrm{c} \mathrm{c} \mathrm{f} \mathrm{a} \mathrm{o} \mathrm{f} \mathrm{a} \mathrm{i}} = 0.0449 \pm 0.0038 \qquad (5.1)$$

となる。シミュレーションから得られる 100% 偏光が入射した場合の検出器のモジュレーショ ンファクタ M は、 $M = 0.447 \pm 0.038$ であるので、X 線発生装置の偏光度は式 3.40 から、

$$\Pi = \frac{M'}{M} = 10.05 \pm 1.21\% \tag{5.2}$$

となる。図 5.9 から、X 線発生装置とビームラインを用いた場合の偏光度を平均すると、 10.8±0.5% であるので、誤差の範囲内で正しく測定できていると言える。



Modulation Curve of Polarization X-ray

5.3.3 比較

同じ偏光度を測定した場合、モジュレーションファクタが大きい検出器では、大きなモジュ レーションが検出されることになる。

4.1 節で示したように、これまでのモデルは、直径 100 mm の 12 角柱のプラスチックシン チレータの周りに CsI(Tl) を配置したモデルであり、20-200 keV のモジュレーションファク タは $M_{\text{old}} = 0.360 \pm 0.001$ である。以前のモデルで X 線発生装置とビームラインの偏光度を 測定した場合、モジュレーションは $M'_{\text{old}} = 0.0390 \pm 0.0032$ という結果が得られている。

新しいモデルのほうがシミュレーションによるモジュレーションファクタが大きく、実際の実験からもモジュレーションが大きく検出されたことにより、確かに性能が向上したと言える。

5.4 斜め入射での偏光測定実験

GRB は宇宙のあらゆる方向で発生する。検出器を衛星に搭載し、宇宙空間での観測を想定 した場合、GRB は常に正面から入射してくるとは限らない。そこで、X 線発生装置とビーム ラインを使用して検出器の斜め方向から入射した場合について、測定を行う。

5.4.1 セットアップ

図 5.13 に示すように、正面入射の偏光測定実験の場合を $\theta = 0^\circ$ として、 $\theta = 30^\circ$ まで 5° ず つ傾けた場合について測定を行う。



図 5.13 斜め入射の偏光測定実験のセットアップ。正面入射の偏光測定実験の場合を $\theta = 0^{\circ}$ として、 $\theta = 30^{\circ}$ まで 5° ずつ傾けて測定を行う。

5.4.2 結果

図 5.14 に、測定から得られた CsI(Tl) のスペクトルを 20-200 keV のエネルギー範囲で積 分し、横軸に散乱角度、縦軸に強度をとったモジュレーションカーブを示す。斜めの角度がき つくなるにつれて、斜め入射の効果が大きくなり、モジュレーションカーブの形が崩れている ことが分かる。



5.4.3 シミュレーションによる考察

実験と同じように、 $\theta = 0^{\circ}-30^{\circ}$ まで 5° ずつ傾けた場合のシミュレーションから得られるモ ジュレーションカーブを図 5.15 に示す。このシミュレーションでは、完全なコインシデンス イベントのみを扱っている。光子は 90° 方向の CsI(Tl) に向かって入射しているが、 θ が大き くなるにつれて 90° 方向のカウントが少なくなり、270° 方向のカウントが多くなっている。

図 5.16 に正面入射の場合と斜め入射の場合に入射光子が見込むプラスチックの厚さの違い を示す。斜め入射では、プラスチックにテーパー加工を施しているため、90° 寄りに入射する 場合と 270° 寄りに入射する場合では入射光子が見込むプラスチックの厚さが異なる。このた め、90° 寄りに入射する光子はプラスチックで相互作用を起こさずに抜けてしまう確率が高く なる。シミュレーションでは、直接成分はコインシデンスイベントとしてカウントされないた め、図 5.15 では斜めの角度が大きくなるにつれて 90° 寄りの CsI(Tl) のカウントが少なくな ると考えられる。一方、270° 寄りに入射した光子が見込むプラスチックは厚くなるため、相 互作用を起こす確率が高くなる。270° 寄りの CsI(Tl) で検出される散乱イベントが増え、斜 めの角度が大きくなるにつれてカウントが多くなると考えられる。



図 5.16 正面入射と斜め入射。正面入射の場合、入射光子が見込むプラスチックの厚さは、 中心に対して点対称である。斜め入射の場合、90°寄りに入射する場合と 270°寄りに入射 する場合で、入射光子が見込むプラスチックの厚さが異なる。

90° 寄りの Csl(Tl) について

図 5.17 に、 $\theta = 30^{\circ}$ 入射について、完全なコインシデンスイベントのみを扱ったモジュレー ションカーブ(赤)と、アンチコインシデンスイベントを含めて CsI(Tl) に入射した全光子に よるモジュレーションカーブ(黒)を示す。90°方向の CsI(Tl) に入射する光子のうち、プラス チックでエネルギーを落とさずに CsI(Tl) に入射する光子が約 87% を占めている。これによ り、実験では偽のコインシデンスイベントをカウントしてしまう可能性が高いと考えられる。

90° 寄りの CsI(Tl) では、コインシデンスイベントとアンチコインシデンスイベントがある 割合で混ざっていると考えることによって、図 5.14 の実験で得られたモジュレーションカー ブを再現することができそうである。



図 5.17 $\theta = 30^{\circ}$ 入射のコインシデンスイベントのモジュレーションカーブとアンチコイ ンシデンスイベントのモジュレーションカーブ

270° 寄りの Csl(Tl) について

実験で得られたモジュレーションカーブでは、 θ が大きくなるにつれて、270°寄りの CsI(Tl) のカウントが上がっている。検出器マウント部分の内側は、安全性を確保するために全体が鉛 で覆われている。斜め入射実験では、検出器の前面と側面を鉛でシールドしていたが、、背面 には鉛を使用しなかった。図 5.18 に示すように、270°寄りの CsI(Tl) には、検出器後部の鉛 で散乱した光子が検出器の背面から入射した可能性が考えられる。

 $\theta = 30^{\circ}$ について、鉛で散乱した光子が検出器の背面から入射した場合のモジュレーション カーブを図 5.19 に示す。270° 寄りの CsI(Tl) のカウントが高くなっている。しかし、アンチ コインシデンスイベントと比較するとレートが少なく、偽のコインシデンスイベントとしてカ ウントされる確率は低いと考えられる。



図 5.18 270° 寄りの CsI(Tl) に入射する可能性

実験モジュレーションの再現

アンチコインシデンスイベントと検出器背面からの入射の効果によって、実験で得られるモ ジュレーションカーブを再現するためには、背面入射がアンチコインシデンスの 20 倍以上の 確率で起こり、偽のコインシデンスイベントが 20% 以上を占める必要がある。仮りに、この 効果を考慮したときに得られるモジュレーションカーブを図 5.20 に示す。

 90° で最大となり、 270° で少しカウントが高くなるような、図 5.14 の実験のモジュレーションカーブ ($\theta = 30^{\circ}$) と同様の傾向が見られる。しかし、アンチコインシデンスイベントと背面入射の確率の仮定に無理がある。実験を完全に再現することはできなかった。旧モデルからの課題となっていた、斜めの効果は補正できていない。



図 5.19 $\theta = 30^{\circ}$ 入射の場合に、鉛の散乱光が検出器背面から入射した場合のモジュレーションカーブ



図 5.20 $\theta = 30^{\circ}$ 入射の場合に、アンチコインシデンスイベントと背面入射の効果を考慮して補正したモジュレーションカーブ

第6章

小型衛星搭載用偏光検出器の設計 検討

我々が開発を行っている偏光検出器は 2010 年 5 月に打ち上げ予定のソーラー電力セイル 実証機に搭載されることが決定した。そこで衛星搭載用のプリフライトモデルの設計検討を 行う。

これまでは、重量 1.5 kg 以下で偏光検出性能を向上させることを目標に検出器の設計を 行ってきた。衛星搭載モデルではさらに、打ち上げ時の振動に耐えられる検出器設計であるこ とが求められる。検出器の耐震化を行うために、設計を再考する必要がある。また、衛星が確 実に運用される 6 ヶ月間に偏光検出が可能な性能が求められる。偏光検出器に許された重量は 3.2 kg であり、この範囲内での改良について検討する。

6.1 小型ソーラー電力セイル実証機

ソーラー電力セイルは、光子の運動量を利用した推進と、電気推進機関を組み合わせて航行 する宇宙船である。小型ソーラー電力セイル実証機は、2010年5月にH2AによってPlanet-C との相乗りで打ち上げられ、図 6.1 のような軌道をたどりながら約 200日をかけて金星に近づ く予定である。世界初の「深宇宙空間での直径 20 mのソーラー電力セイルを展開」、「電力セ イル機能の実証」、「光子セイルの航行実証」を行う、重量 300 kg の探査機である。

計画されているミッションは、「大型薄膜の展開・展張」、「電力セイルからの集電」、「光子 セイルによる加速実証」、「光子セイルによる航行技術の獲得」、「理学観測」の5項目である。 GRBの偏光検出器 (GAmma-ray burst Polarimeter : GAP) は、理学観測機器として搭載さ れる予定である。

GAP はソーラー電力セイル実証機の下部パネルに取り付けられる予定である。ソーラーセ イルが基本的に太陽方向を向いていることから、GAP は太陽と反対方向を向くことになる。 また、衛星が打ち上げられる 2010 年 5 月頃には、太陽の活動が極大期を迎えることを考慮す る必要がある。

ソーラー電力セイル実証機は地球から非常に離れるため、通信回線は 16 bit s⁻¹ に細くなる。さらに、Planet-C とデータのダウンリンクが競合することを考慮すると、データは上空

でコンパクトにし、必要最小限にまとめる必要がある。また、打ち上げから約6ヶ月は取得 データをある程度地上に降ろすことができるが、それ以降のデータを地上に降ろすことができ るかどうかは保証されていない。



図 6.1 小型ソーラー電力セイル実証機の航行計画



図 6.2 小型ソーラー電力セイル実証機

ソーラー電力セイル搭載目的

ソーラー電力セイルに GAP を搭載する目的は、「GRB の偏光観測」、「IPN (InterPlanetary Network) への参加」、「カニ星雲の偏光観測」である。主な目的は GRB の偏光観測であるの で、データ取得が可能な 6 ヶ月間に、少なくとも 1 個の GRB について偏光観測が可能な検出 器性能が求められる。IPN とは、複数の衛星でガンマ線が検出される時間差を用いて、GRB の到来方向を決定する方法であり、GLAST 衛星や KONUS 衛星と協力して行う予定である。 航行計画から、約 6 ヶ月後にカニ星雲が視野に入ることが予想されるため、カニ星雲の偏光観測を行う予定である。

6.2 GAP の概略

図 6.3 に GAP の概略図を示す。GAP は大きく分けて検出器本体 (シンチレータと PMT) と回路部に分けることができる。全体は円筒形のケース入っており、円筒ケースの直径は 171.3 mm、高さは 210 mm 程度になる予定である。全重量は 3.2 kg 以下に抑える必要が ある。

6.2.1 検出器本体

12 角形のプラスチックシンチレータ (直径 140 mm× 高さ 70 mm) の周りを 12 枚の CsI(Tl) シンチレータ (厚さ 5 mm× 高さ 70mm× 幅 37 mm) で囲んだ、散乱型検出器であ る。プラスチックと CsI(Tl) はシュリンクチューブを使用して一体化する。また、エネルギー 較正用として、CsI(Tl) の上部に弱い放射線源 (Am) を搭載する予定である。

プラスチックを読み出す PMT は、管長が短い R6041(浜松ホトニクス) であり、光電面 がスーパーバイアルカリ (SBA) のものを使用する予定である。CsI(Tl) を読み出す PMT は R7400p-06(浜松ホトニクス) を使用する。R7400p-06 はガラス面がフラットであるため、 CsI(Tl) との接着が良い。どちらの PMT も +HV を印加して使用する。R6041 用の HV モ ジュール 1 台と R7400p-06 (12 本) 用の HV モジュール 1 台を使用する。HV モジュール (明 星電気) の重さは 1 台 70 g、大きさは 7.13 cm×6.12 cm×1.70 cm 程度である。

PMT とシンチレータの接着について、プラスチックは KE-108 とプライマー S(信越シリ コーン)を使用し、CsI(Tl) については最適の接着剤を検討中である。PMT とシンチレータ を接着した状態での振動テストを行う必要がある。

検出器本体は回路部と一体になっており、円筒型のアルミケースに入る。太陽フレアの影響 を極力小さくするために、検出器底部には鉛とスズのシールドを付ける予定である。全体を組 み上げた状態での振動テストを行う必要がある。また、真空テスト、温度テスト、放射線テス トを行う予定である。



⊠ 6.3 GAP

6.2.2 回路部

回路部は「アナログ回路部」、「デジタル回路部」、「コマンド部」、「インターフェース部」 に分けられる。「アナログ回路部」は PMT のブリーダー、高圧電源、回路電源部、プリアン プ+シェーピングアンプ+ディスクリミネータ+サンプルホールド+ADC までの部分であ る。「デジタル回路部」はトリガー判定の FPGA やメモリーで構成されている。「コマンド部」 は地上からのコマンドを受け付ける部分である。「インターフェース部」は衛星とのインター フェースを行う部分である。回路基板は全部で 5 枚であり、配線を含めて回路全体で 650 g 程 度になる。 「基板1」: R7400-06 の CSA と高圧調整回路が入るドーナツ型の基板であり、HV ラインが 随所に走る。PMT にはソケットを使わず、ブリーダー回路と PMT は直接取り付ける。

「基板 2a」: プラスチック用 PMT のブリーダー回路が入る小さな基板である。

「基板 2b」: プラスチック用の CSA、Shaping Amp (SA)、ディスクリミネータ、サンプル ホールド (SH)、ADC が乗る基板である。また、CsI(Tl) とプラスチックのスレッシュホール ドを調整するための DAC 回路も乗る。

「基板 3」: ADC の動作を制御するための FPGA が乗る基板である。

「基板4」: FPGA、メモリ、インターフェース回路が乗る基板である。

「基板5」: 電源回路、コマンド回路、HV 関連の回路が乗る基板である。

6.3 GAP の性能

衛星からのデータ取得の問題から、全重量 3.2 kg 以下で、年間 2 個以上の GRB に対して 偏光検出が可能な性能にすることを目標とする。衛星搭載モデルで使用するシンチレータは、 直径 140 mm× 高さ 70 mm の 12 角形でテーパー加工を施したプラスチックシンチレータと、 厚さ 5 mm× 高さ 70 mm× 幅 37 mm の CsI(Tl) シンチレータ 12 枚である。

ここでは、直径 100 mm× 高さ 50 mm で高さ 25 mm にテーパー加工を施したプラスチッ クを使用した ϕ 100 mm モデルと、直径 140 mm× 高さ 70 mm で高さ 35 mm にテーパー加 工を施したプラスチックを使用した衛星搭載モデル (ϕ 140 mm モデル) について、シミュレー ションによる性能比較を行う。

6.3.1 シミュレーションによる性能比較

検出効率とモジュレーションファクター

図 6.4 にそれぞれのモデルの η 、Mを示す。高エネルギー側では ϕ 140 mm モデルの η が 高い。 ϕ 140 mm モデルは厚さが 70 mm のため、高エネルギー光子の散乱確率が高くなり、 η が大きくなっていると考えられる。

全体として、 $\phi 100 \text{ mm}$ モデルの方が M の値が高い。 $\phi 140 \text{ mm}$ モデルでは高エネルギー側 の η が高いが、M は $\phi 100 \text{ mm}$ モデルと同程度である。このことから、 $\phi 140 \text{ mm}$ モデルの 高エネルギー側の光子はプラスチック内で多重散乱を起こし、偏光情報を失っていると予想される。

 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$

3.7.3 項で示した MDP を用いて総合的に偏光検出器の性能を評価するために、 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ を導入する。図 6.5 にそれぞれのモデルのエネルギーごとの $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ を示す。 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ では、圧倒的に ϕ 140 mm モデルが有利であることが分かる。検出効率では高エネルギー側では ϕ 140 mm モデルが有利であった。モジュレーションファクターでは直径が大きくなると多重



図 6.4 ϕ 100 mm モデルと ϕ 140 mm モデル の $\eta \ge M$



図 6.5 $\phi 100 \text{ mm}$ モデルと $\phi 140 \text{ mm}$ モデル の $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$

散乱の確率が高くなることから $\phi100 \text{ mm}$ モデルが有利であった。 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ には、検出器の直径が大きく影響していることが分かる (付録 C 参照)。

M(ηS)⁵の結果から、直径が大きい効果によって φ140 mm モデルのほうが偏光検出性能が 高いと言える。しかし、直径が大きくなり、テーパー加工が高さの半分であることから、集光 効率が悪くなる可能性が考えられる。今後、衛星搭載モデルのプラスチックシンチレータを実 際に作成し、検出限界エネルギーを評価する必要がある。

6.3.2 GRB の検出可能性

衛星搭載モデルで1年間に観測が期待される GRB 数を図 6.6 に示す。黒のプロットは検出 器の見込む全視野 ($\pm 90^{\circ}$) について、赤のプロットは視野を $\pm 30^{\circ}$ に限定した場合である。実際に有意な観測を行うことができる視野は $\pm 30^{\circ}$ 程度である。6 ヶ月間では、GRB が 40% 偏 光していれば1個、70% 偏光していれば2 個の観測が期待される。

6.4 プラスチックシンチレータ用 PMT

これまで、プラスチックシンチレータを読み出す PMT として、過去に衛星に搭載された 実績のある R1840-12s を使用してきた。しかし、検出器の小型化、高性能化を行うために、 R6041 という PMT を使用したい。そこで、これまでに使用してきた R1840-12s と R6041 の 性能を比較する。図 6.7 の左が R1840-12s、右が R1840 である。

6.4.1 R1840-12sと R6041 のカタログ性能

浜松ホトニクスのカタログから、それぞれの PMT の性能を表 6.1 に示す。R1840-12s はダ イノード 10 段の R1840 を 12 段にした特注品のため、表 6.1 には R1840 のカタログ値を示し た。ダイノード段数と GAIN の括弧内の値は、10 段のカタログ値から 12 段の GAIN を計算 した値である。



図 6.6 衛星搭載モデルで 1 年間に観測が期待される GRB 数。6 ヶ月間では、GRB が 40% 偏光していれば 1 個、70% 偏光していれば 2 個の観測が期待される。



図 6.7 R1840-12s(左) と R6041(右)

表 6.1 R1840 と R6041 のカタログ性能

R1840-12s は特注品のため、ダイノード 10 段の R1840 のカタログ値を示した。括弧内の GAIN は、10 段の R1840 のカタログ値から計算した 12 段の R1840-12s の GAIN である。

	R1840	R6041
外 径 [mm]	51	51
有効光電面積 [mm]	46	45
感度波長範囲 [nm]	300 - 650	300 - 650
最高感度波長 [nm]	420	420
陰極放射感度 $[mA/W]$	65	74
窓材質	ホウケイ酸ガラス	ホウケイ酸ガラス
光電面種類	バイアルカリ	バイアルカリ
陰極ルーメン感度 $[\mu A/lm]$	60	70
陽極ルーメン感度 [A/lm]	10	200
暗電流 [nA]	5	5
上昇時間 [ns]	5	2
走行時間 [ns]	15	12.5
走行時間幅 [ns]	0.69	0.75
ダイノード段数	10(12)	12
ダイノード構造	コースメッシュ型	メタルチャンネル型
印加電圧 [V]	1250	1000
GAIN	1.7×10^5	3.0×10^6
	$(\sim 1.2 \times 10^6)$	

6.4.2 検出限界エネルギー

同じセットアップ (ϕ 100 mm テーパープラスチック、CSA、波形整形回路) で PMT だけを 入れ替え、²⁴¹Am、¹⁰⁹Cd、バックグランドの測定を行った。R1840-12s で測定したスペクト ルを図 6.8、R6041 で測定したスペクトルを図 6.9 に示す。

²⁴¹Am の 59.5 keV のピークと ¹⁰⁹Cd の 22.67 keV のピークをフィットし、チャンネル とエネルギーの一次関数を求め、検出限界エネルギーを求めた。図 6.8 と図 6.9 を比較する と、R6041 のほうが GAIN は高いが、表 6.1 に示したように、2 つの PMT の GAIN のカ タログ値はオーダーが等しいため大きな違いは見られない。検出限界エネルギーについては、 R1840-12s は 10.0 keV、R6041 は 8.52keV であり、S/N では圧倒的に R6041 のほうが良い。 表 6.1 に示すように、R1840-12s の印加電圧は 1250 V であり、R6041 の印加電圧は 1000 V であることから、電力消費の観点からも R6041 が使用しやすい。また、図 6.7 に示すように R6041 は R1840-12s よりも小型であり、検出器の小型化を行うことができる。以上の利点か ら、衛星搭載モデルとして R6041 を使用する。



6.5 信号処理

これまでは VA-TA を用いた信号処理システムを使用していたが、VA-TA では波高のピー ク値を出力することが困難であり、PMT からの信号がサンプルホールドによって低く出力さ れるという問題があった。また、VA-TA は高集積回路 (LSI) であり、宇宙空間での使用実績 がなく、衛星搭載モデルで使用するには信頼性が低い。そこで、衛星搭載モデルでは、プラ スチックと CsI(Tl) を合わせた 13 チャンネルの信号を、電荷増幅器 (CSA)、波形整形増幅器 (Shaping Amp)、ディスクリミネータをコンパクトにまとめたアナログ回路で独立に信号処 理を行う予定である。

6.5.1 信号処理システム

アナログ回路部

CsI(Tl) 用の 12 本の PMT R7400-06 の HV は 1 台の HV で印加し、プラスチック用の PMT R6041 の HV はもう 1 台の HV で印加する。CsI(Tl) 12 チャンネルの信号はそれぞれ 12 個の CSA(時定数 20 μ sec 程度) に入力され、CSA の出力は 2 つに分岐される。一方は時 定数 3 μ sec の Shaping Amp に入力され、もう一方はディスクリミネータに入力される。各 チャンネルのディスクリミネータには、LD と UD が存在している。プラスチックからの信号 も、基本的には CsI(Tl) と同じような処理がされる。

ディスクリミネータからの 13 チャンネルの信号は、デジタル回路部の FPGA に入力され、 13 チャンネルの Shaping Amp 出力は ADC に入力される。FPGA からコンバージョンス タートの信号が ADC に入力されると、ADC は 13 チャンネル分の波高値をデジタル信号に変 換する。 デジタル回路部

デジタル回路は、「待機モード」、「GRB/IPN モード」、「BGD モード」、「HK/PHA モード」、「Crab モード」の5つのモードで動作が可能である。

「待機モード」の役割は、最低限の検出器の様子をモニターすることと、GRB を待ち受けることである。GRB が起こると自動的に「GRB/IPN モード」に切り替わる。

「GRB/IPN モード」では、CsI(TI) 1 チャンネルの信号だけが LD-UD 間に入る場合に ADC でデータが取得される。ADC のデータはヒストメーカーと呼ばれる FPGA 上のモジュール に読み込まれ、衛星からの時間情報と姿勢情報を使用してカウントレート情報、ヒットパター ン情報、エネルギースペクトル情報のヒストグラムを絶えず作る。

「BGD モード」は地上からのコマンド操作によってデータの取得が開始される。取得するデー タは GRB モードと同じである。

「HK/PHA モード」は、健康診断用 PHA モードである。

「Crab モード」はカニ星雲を観測するためのモードである。ヒットパターン情報とスペクトル 情報が蓄えられる。

6.5.2 トリガーレートの見積り

回路の処理能力を検討するために、GRB のトリガーレート、CXB のトリガーレート、宇宙 線のトリガーレートを見積もる。

GRB からのフラックス

我々が観測を行う明るい GRB に対して、フラックスを計算する。明るい GRB はエネル ギー放出効率が最も高いエネルギー E_p が大きいので、E < 300 keV の光子スペクトルを、

$$N(E) = E^{-\alpha} \quad \text{[photon cm}^{-2} \text{ sec}^{-1}\text{]} \tag{6.1}$$

のようなベキ関数で記述する。このとき、平均的に $\alpha \sim 1$ である。

BATSE の 4B カタログに掲載されている、50–300 keV のピークフラックスを F_{BATSE} [photon cm⁻² sec⁻¹] とする。また、CsI(Tl)、プラスチックの検出効率を $\eta(E)$ とする (付録 D 参照)。我々の検出器で検出される $E_1 < E < E_2$ のエネルギー範囲のフラックス $F_p(E_1, E_2)$ は、

$$F_{\rm p}(E_1, E_2) = F_{\rm BATSE} \times \frac{\int_{E_1}^{E_2} N(E)\eta(E) \, dE}{\int_{50}^{300} N(E) \, dE} \qquad [\text{counts cm}^{-2} \, \text{sec}^{-1}] \tag{6.2}$$

となる。式 6.2 を用いて計算した結果を表 6.2 に示す。

表 6.2 CsI(Tl)・プラスチックで検出されるフラックス

O T	/ 	11
		11
USH	- 1	11
~~~	_	

	@厚さ 3 mm	@厚さ 5 mm	@厚さ 10 mm
$F_{p}(10,300)$	$1.08F_{BATSE}$	$1.19F_{BATSE}$	$1.26F_{BATSE}$
$F_{p}(30,300)$	$0.93 F_{BATSE}$	$1.04 F_{BATSE}$	$1.12F_{BATSE}$
$F_{p}(40,300)$	$0.84 F_{BATSE}$	$0.94 F_{BATSE}$	$1.03 F_{BATSE}$
$F_{p}(50,300)$	$0.70 F_{BATSE}$	$0.80 F_{BATSE}$	$0.89F_{\rm BATSE}$

プラスチック

	@高さ 5 cm	@高さ 6 cm	@高さ7 cm
$F_{p}(7,300)$	$0.90 F_{BATSE}$	$1.01 F_{BATSE}$	$1.03 F_{BATSE}$

GRB のトリガーレート

GRB が検出器の側面から入射する場合には、CsI(TI)のトリガーレート、検出器の正面から入射する場合にはプラスチックのトリガーレートが問題となる。検出器の側面の面積  $S_s$ と検出器の正面の面積  $S_f$  は、

$$S_{\rm s} = 7 \times 15 = 105 \ [\rm cm^2]$$
 (6.3)

$$S_{\rm f} = 7 \times 7 \times \pi = 154 \ [\rm cm^2]$$
 (6.4)

となる。表 6.2 に示したフラックスに検出器の面積をかけてトリガーレートを計算する。 10 [photon cm⁻² sec⁻¹]、30 [photon cm⁻² sec⁻¹] の非常に明るい GRB が発生した場合、 CsI(Tl) とプラスチックのトリガーレートを計算した結果を表 6.3 に示す。

#### CXB のトリガーレート

CXB の光子スペクトル N(E) [photon keV⁻¹ cm⁻² sec⁻¹ str⁻¹] は式 4.3、4.4 から、

$$N(E) = 7.877E^{-1.29} \exp\left(-\frac{E}{41.13}\right), \quad 3 - 60 \text{ keV}$$

$$= \left(\frac{0.0259}{60}\right) \left(\frac{E}{60}\right)^{-6.5} + \left(\frac{0.504}{60}\right) \left(\frac{E}{60}\right)^{-2.58} + \left(\frac{0.0288}{60}\right) \left(\frac{E}{60}\right)^{-2.05}, \quad > 60 \text{ keV}$$

$$(6.5)$$

表 6.3 GRB のトリガーレート

表中の「レート 10」は 10 [photon cm⁻² sec⁻¹] の GRB が検出器に入射した場合のトリガーレートであり、「レート 30」は 30 [photon cm⁻² sec⁻¹] の GRB に対してのトリガーレート である。

CsI(Tl)	
---------	--

厚さ	LD [keV]	UD $[keV]$	レート 10 [kHz]	レート 30 [kHz]
$3 \mathrm{mm}$	10	300	1.13	3.40
	30	300	0.977	2.93
	40	300	0.882	2.65
	50	300	0.735	2.21
5 mm	10	300	1.25	3.75
	30	300	1.09	3.28
	40	300	0.987	2.96
	50	300	0.840	2.52
10 mm	10	300	1.32	3.97
	30	300	1.18	3.53
	40	300	1.08	3.24
	50	300	0.935	2.80

プラスチック

高さ	LD [keV]	UD [keV]	レート 10 [kHz]	レート 30 [kHz]
$5 \mathrm{cm}$	7	300	1.39	4.16
$6 \mathrm{cm}$	7	300	1.55	4.66
$7 \mathrm{~cm}$	7	300	1.59	2.76

と表された。また、CXB は検出器に等方的に入射するため、検出器の見込む立体角を  $2\pi$  [str] として、CsI(Tl)、プラスチックの検出効率を  $\eta(E)$  とすると、バックグランド H は、

$$H = \pi \int_{E_1}^{E_2} N(E)\eta(E) dE \int_0^{\pi} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \quad \text{[photon cm}^{-2} \text{ sec}^{-1}\text{]} \tag{6.7}$$

となる。CsI(Tl) とプラスチックにおける CXB のトリガーレートを表 6.4 に示す。

#### 宇宙線のトリガーレート

図 6.10 に、宇宙線粒子のエネルギー分布を示す。宇宙線粒子のエネルギー分布から 500 MeV のピークに対して幅 500 MeV の範囲を考えると、粒子数は、

$$N(E) = 2 \times 10^{-4} \quad \text{[counts cm}^2 \text{ MeV}^{-1} \text{ n}^{-1}\text{]}$$
(6.8)

#### 表 6.4 CXB のトリガーレート

表中の「レート@1 枚」は CsI(Tl) 1 枚についてのトリガーレートであり、「レート@12 枚」は CsI(Tl) 12 枚についてのトリガーレートである。

CsI(Tl)

厚さ	LD [keV]	UD [keV]	レート@1 枚 [Hz]	レート@12枚 [Hz]
3 mm	10	300	111	1332
	30	300	69.0	828
	40	300	36.4	437
	50	300	32.0	384
5  mm	10	300		
	30	300	70.8	850
	40	300	48.0	576
	50	300	33.6	403
10 mm	10	300		
	30	300	71.6	859
	40	300	48.8	586
	50	300	34.6	415

プラスチック

高さ	LD [keV]	UD $[keV]$	u -  bar [Hz]	
$5 \mathrm{cm}$	7	300	521	
$6 \mathrm{cm}$	7	300	560	
$7 \mathrm{~cm}$	7	300	570	

表 6.5 宇宙線のトリガーレート

	レート [Hz]
CsI(Tl)1枚	32.5
CsI(Tl) 12 枚	391
プラスチック	193



図 6.10 宇宙線粒子のエネルギー分布

となる。宇宙線のトリガーレートを表 6.5 に示す。

#### まとめ

LD の設定にもよるが、CXB バックグランドと宇宙線バックグランドによって、CsI(Tl) と プラスチックを合わせて約2 kHz のトリガーレートとなる可能性がある。バックグランドレー トを上げている一番の要因は CsI(Tl) の低エネルギー側であり、LD=30 keV と LD=50 keV では 450 Hz 程度変わる。今後、この結果をふまえて回路の処理能力を検討する必要がある。

#### 6.5.3 VA-TA システムと NIM システムの性能比較

同じセットアップ ( $\phi$ 130 mm テーパープラスチック、R1840-12s) で VA-TA による信号処 理を行った場合と、NIM システム (CSA、Shaping Amp、ADC) による信号処理を行った場 合についての性能を比較する。

VA-TA による信号処理を行った場合のスペクトルは図 4.21 に示した。このときの検出限界 エネルギーは 10.2 keV であった。同じセットアップで NIM システムによる信号処理を行っ た場合のスペクトルを図 6.11 に示す。LD レベルは 8.95 keV で、VA-TA を使用するよりも



図 6.11 NIM システムによる ²⁴¹Am、¹⁰⁹Cd、バックグランドのスペクトル

S/N が良くなっている。これは、VA-TA でのサンプルホールドが波形のピーク値ではなく、 トリガーから一定時間後の波高値をホールドし、出力するためであると考えられる。

## 6.6 PMT とシンチレータの接着

衛星搭載のためには、打ち上げの際の振動や温度変化に耐えられる接着剤を使用して PMT とシンチレータを接着する必要がある。接着剤に求められる性能として、「打ち上げ時の振 動に耐えられる接着強度を持つこと」、「-30°C~+40°C の急激な温度変化でも剥がれないこ と」、「シンチレータに近い屈折率を持つこと」、「シンチレータの発光波長に対して透明である こと」が挙げられる。ここでは、2種類の接着剤について接着テストを行った結果を示す。

6.6.1 接着剤

KE-108 とプライマー S

KE-108 は Suzaku 衛星の HXD 検出器で GSO と BGO の接着に使用されているシリコン ゴムの接着剤で、弾性がある。KE-108 を直接ガラスに接着しようとしても、ゴム状に固まっ た KE-108 はガラスからきれいに剥がれてしまう。このため、KE-108 を使用する場合には、 接着強度を補うためにプライマー S と呼ばれる接着補助剤を付加する。 BC-600

BC-600 はアラルダイト系の接着剤で、弾性がないため温度変化に対して弱い。屈折率は 1.56 であり、プラスチックの屈折率 (1.59) に非常に近い値である。接着剤の厚さが 125 μm の場合、波長に対する透過率は表 6.6 のように保証されている。今回の接着テストでは硬化剤 の量を変化させたサンプルを作り、接着性能を比較する。

表 6.6 BC-600 厚さ 125 µm の透過率

<b>波長</b> [nm]	透過率
308-340	>90%
340 - 400	>95%
>400	>98%

#### 6.6.2 プラスチックの接着

プラスチックシンチレータと PMT の接着に使用する最適な接着剤を調べる。接着面が 20 mm×50 mm のプラスチックをガラスに接着し、接着強度と温度変化 (-30°C~ +40°C) に対する耐性を調べる。BC-600 については、硬化剤の量が定格のもの (100%)、定格の 80%、 50%、30%、10% の接着剤を使用する。それぞれの結果を表 6.7 に示す。

表 6.7 プラスチックとガラスの接着についての接着強度と温度変化後の様子

接着剤	温度変化前の接着強度	温度变化後
KE-108	剥せない	問題なし
BC-600(100%)	剥せない	ガラスが割れた (図 6.12)
BC-600(80%)	剥せない	ガラスが割れた
BC-600(50%)	剥せない	干渉縞が見える
BC-600(30%)	剥せない	干渉縞が見える
BC-600(10%)	剥せない	_

KE-108 は温度変化前後で問題は見られない。一方、BC-600 は弾性がないため、温度変化 によるプラスチックの熱応力を吸収できないことが分かった。硬化剤 100%、80% のサンプル ではガラスが割れてしまい、50% 以下ではプラスチックと BC-600 が剥がれ、空乏層による ニュートンリングができてしまった。BC-600 の硬化剤の量を減らすにつれ、硬化に時間がか かるようになる。しかし、十分に硬化させた場合には、温度変化後にニュートンリングができ てしまう。

この結果から、プラスチックシンチレータと PMT との接着には KE-108 を使用する。



図 6.12 温度変化後の BC-600(100%) のサンプル。温度変化によるプラスチックの熱応力 を吸収できず、ガラスが割れてしまった。

## 6.6.3 Csl(Tl)の接着

CsI(Tl) と PMT の接着に使用する最適な接着剤を調べる。接着面が幅 25 mm× 厚さ 3 mm の CsI(Tl) をガラスに接着し、プラスチックの場合と同様に、接着強度と温度変化 (-30°C~+40°C) に対する耐性を調べる。それぞれの結果を表 6.8 に示す。

接着剤	温度変化前の接着強度	温度变化後
KE-108	簡単に剥がれる	_
BC-600(100%)	剥せない	空乏層ができた
BC-600(80%)	剥せない	空乏層ができた
BC-600(50%)	剥せない	空乏層ができた
BC-600(30%)	剥せない	空乏層ができた
BC-600(10%)	剥せない	空乏層ができた

表 6.8 CsI(Tl) とガラスの接着についての接着強度と温度変化後の様子

KE-108 と CsI(Tl) は簡単に剥がれてしまうため、CsI(Tl) の接着剤としては使用できない。 また、BC-600 については、温度変化による CsI(Tl) の熱応力によって BC-600 と CsI(Tl) の 間に空乏層ができてしまう。

これまでは BC-600 の硬化剤の量を減らしたサンプルについて接着テストを行ったが、現 在、硬化剤の量を増やしたサンプルについて同様に接着テストを行っている。 6.6.4 まとめ

接着強度、温度変化に対する耐性から、プラスチックと PMT の接着には KE-108 とプライマー S を使用する。CsI(Tl) と PMT の接着については現在調査中である。

今後、接着強度を調べるためにシンチレータと PMT を接着し、振動テストを行う予定であ る。また、シンチレータの発光波長に対する接着剤の透過率、シンチレータと接着剤の屈折率 の違いによる全反射により、シンチレーション光の損失が起こる可能性がある。そこで、接着 剤を使用することによる GAIN 変化を調べる必要がある。

#### 6.7 高圧電源

PMT に HV を印加する高圧電源について、Suzaku 衛星の HXD 検出器で使用されている 高圧電源と同等のものを使用する予定である。HXD 検出器で使用されている高圧電源の基本 仕様を表 6.9 に示す。

レファレンス電圧  $V_{ref}$  を 0–5 V の範囲で変えることで、それに正確に比例した出力電圧が 得られる。 $V_{ref} = 5$  V のとき、出力  $V_{out}$  は最大値  $V_{max} = 1250$  V となる。高圧出力は温度 係数の揃った抵抗により分割降圧され、モニター電圧  $V_{mon}$  として外部に出力される。

項目	基本仕様	
大きさ / 重さ	$71 \text{ mm} \times 61 \text{ mm} \times 17 \text{ mm} / 70 \text{ g}$	
発振 / リップル	${\sim}140$ kHz / ${<}50$ mV	
温度環境	$-30^{\circ}\mathrm{C}{\sim}+40^{\circ}\mathrm{C}$	
出力安定度	出力電圧、負荷、環境温度のフルレンジに対して $0.1\%$	
最大電圧 / 最大電流	1250 V / 400 $\mu A$	
リファレンス電圧	$1:250 (5 V \Leftrightarrow 1250 V)$	
モニター電圧	$1:250 (5 V \Leftrightarrow 1250 V)$	

表 6.9 Suzaku 衛星 HXD 検出器用高圧電源の基本仕様
### 第7章

### まとめと今後の課題

#### 7.1 プラスチックシンチレータの改良について

昨年度作成した旧偏光検出器からの性能向上と軽量化を目標に新しく設計した偏光検出器の 改良についてまとめる。

プラスチックシンチレータを直径 100 mm の 12 角柱から、直径 130 mm でテーパー加工を 施したモデルに変更した。これによって、検出効率は 19.6% @100 keV から 11.1% @100 keV に下がったが、モジュレーションファクターは 0.375 @100 keV から 0.492 @100 keV に向上 した。さらに、有効面積が 78.54 cm² から 132.7 cm² に大きくなったことによって、検出器 全体としての偏光検出性能を向上させることができた。GRB が 50% 偏光していれば、1 年間 に 2 個の GRB の偏光観測が期待される。

プラスチックにテーパー加工を施したことによって、PMT への集光効率が良くなった。 さらに、プラスチック用の PMT をダイノード 10 段の R1840-15 からダイノード 12 段の R1840-12s に変更したことによって、散乱型検出器の性能を決める、プラスチックの検出限界 エネルギーが改善した。VA-TA システムを使用した信号処理を行った場合、以前のモデルの 12.0 keV から新しいモデルでは 10.2 keV となった。これは、77.5 keV の入射光子が 90° 散 乱した場合に落とすエネルギーであり、観測対象となるのは 77.5 keV 以上となる。

しかし、我々は検出限界エネルギー 7 keV を目標としており、入射光子にして 60 keV 程度 の光子を偏光観測に利用することが理想であるため、現在の性能では不十分である。VA-TA システムを使用した信号処理では、PMT からの出力のピーク波高値を出力することが困難で あると考えられる。衛星搭載モデルでは、VA-TA システムを使用せず、アナログ回路を使用 した信号処理を行うことでさらなる改良を行う予定である。

#### 7.2 軽量化について

衛星搭載時の重量制限を想定し、検出器全体で1500g以下となるような設計を行った。以前のモデルで使用していた既製品のPMTブリーダー回路、通常の電子部品を使用した高圧分岐回路などのPMT周辺回路を見直した。表面実装部品を使用することで小型化、高密度化、計量化を行った。これにより、回路基板と部品で126gの計量化に成功した。また、検出器を

収納するアルミボックスについて、耐久性に問題がない程度にアルミを薄くした設計によって、434gの計量化に成功した。検出器全体としては、1365gで作成することができた。

衛星搭載のためには、打ち上げの時の振動に耐えられる検出器設計が求められる。衛星搭載 モデルでは、検出器の耐震化に主眼を置いて、設計の再考を行う必要がある。

#### 7.3 Csl(TI) シンチレータのエネルギー分解能

以前のモデルでは、それぞれの CsI(Tl) でエネルギー分解能が異なり、偏光測定で得られる CsI(Tl) スペクトルからエネルギーと偏光度の関係を正しく評価することができなかった。

我々は、CsI(Tl)の底面 ( $36 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ )を R7400pの光電面  $\phi 8 \text{ mm}$  に収束させるプラ スチックのライトガイドを設計し、CsI(Tl)の集光効率が良くなることを期待した。しかし、 CsI(Tl)とプラスチックの屈折率の違いから、集光効率を良くすることができず、ライトガイ ドを使用しないほうが集光効率が良いという結果が得られた。

そこで、CsI(Tl)の PMT と接していない部分に反射率の高いテフロンテープを巻き、使用 している。しかし、CsI(Tl)の幅が 25.5 mm から 36 mm に広くなったことによって、エネル ギー分解能の平均が 49.5% @59.5 keV から 35.1% @59.5 keV に落ちてしまった。これによっ て、課題となっていたエネルギー分解能を揃えることがさらに困難になった (付録 F 参照)。

#### 7.4 斜め入射の補正

GRB は宇宙のあらゆる方向で発生するため、常に正面から入射してくるわけではない。斜 め入射の場合に得られるモジュレーションカープを補正することで正しい偏光度を見積もる必 要がある。新しい検出器ではプラスチックにテーパー加工を施したことで、光子の入射位置に よって見込むプラスチックの厚さが異なる。このため、完全なコインシデンスのみを考えた場 合には斜めの角度が大きくなるにつれて 90° 寄りの CsI(Tl) のカウントが少なくなり、270° 寄りの CsI(Tl) のカウントが多くなった。

実験では斜めに入射することによって、90°寄りの CsI(Tl) に直接入射する光子の割合が増 えるため、偽のコインシデンスイベントをカウントしてしまう可能性が高くなると考えられ る。完全なコインシデンスイベントと、偽のコインシデンスイベントがある割合で混ざり合っ ていると仮定してシミュレーションから実験結果を再現することを行った。しかし、完全に再 現することができず、斜め入射の補正を行うことができなかった。

ソーラー電力セイル実証機搭載に向けて、早急に斜め入射の補正方法を検討する必要がある。

#### 7.5 鉛シールド

X 線発生装置を使用した偏光測定では、プラスチックシンチレータ以外の検出器部分を鉛で シールドした状態で測定を行う必要がある。鉛を巻かない場合には偽のコインシデンスイベン トが支配的になり、有意な偏光測定を行うことができなかった。衛星搭載時には、IPN の観点 から検出器全体に鉛などのシールドを行わない予定である。シールドの必要性について、X 線 発生装置の強度を落として測定を行うことによって、コインシデンス処理のみでの偏光測定が 可能かどうか検証できると考えられる。

#### 7.6 ソーラー電力セイル実証機搭載に向けて

衛星搭載モデルでは打ち上げ時の振動に耐えられる検出器設計が求められる。また、衛星からのデータ取得が可能な6ヶ月間に、少なくとも1個のGRBについて偏光観測が可能な検出器性能が求められる。現在設計を行っているプリフライトモデル(PM)では、GRBが40% 偏光していれば6ヶ月間に1個、70% 偏光していれば2個の偏光観測が期待される。

今後、設計したプラスチックシンチレータを、スーパーバイアルカリの光電面を持つ R6041 で読み出し、検出限界エネルギーを評価する必要がある。また、R7400-06、R6041 のブリー ダー回路の試作と部品の最適化を行う。さらに、PMT とシンチレータを接着した状態で振動 テストによって接着強度の確認を行い、検出器全体の振動テストなども行う必要がある。打ち 上げに向けて、表 7.1 に示した開発計画を予定している。

期日	計画
2008年4月末	プリフライトモデル (PM) 完成
2008 年 8 月末	プリフライトモデルテスト終了
2009 年 8 月末	フライトモデル (FM) 完成
2009 年 2 月末	総合かみ合わせ終了
2010 年 5 月末	打ち上げ

表 7.1 今後の開発計画

# 付録 A 相対論的ビーミング

#### A.1 速度のローレンツ変換



図 A.1 速度のローレンツ変換

観測者系 (K系) に対して x 軸方向へ速度 v で動く静止系 (K'系) がある。K'系で速度u'を 持つ質点を K 系から見た場合の速度を求める。ローレンツ変換の式から、

$$dx = \gamma (dx' + vdt')$$
  

$$dy = dy'$$
  

$$dz = dz'$$
  

$$dt = \gamma \left( dt' + \frac{v}{c^2} dx' \right)$$
  
(A.1)

と書けるので、速度は以下のようになる。

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}}$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)}$$

$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)}$$
(A.2)

K 系に対する K' 系の任意の速度 v に対して式を一般化する。u の v に対する平行成分を  $u_{\parallel}$ 、 垂直成分を  $u_{\perp}$  とすると、以下のように書ける。

$$u_{\parallel} = \frac{u'_{\parallel} + v}{1 + \frac{vu'_{\parallel}}{c^2}}$$

$$u_{\perp} = \frac{u'_{\perp}}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_{\parallel}}{c^2}\right)}$$
(A.3)

この式は特殊相対論での速度合成則である。

また、K 系から観測した速度の方向  $\theta$  と K' 系から観測した速度の方向  $\theta'$  は、以下に示す光 行差の式で関係付けられている。 $u' \equiv |u'|$  として、

$$\tan \theta = \frac{u_{\perp}}{u_{\parallel}} = \frac{u' \sin \theta'}{\gamma(u' \cos \theta' + v)} \tag{A.4}$$

となる。また、 $u \equiv |u|$ として、 $\cos \theta$ は以下のようになる。

$$\cos\theta = \frac{u_{\parallel}}{u} = \frac{1}{u} \cdot \frac{u'\cos\theta' + v}{1 + \frac{vu'}{c^2}\cos\theta'} \tag{A.5}$$

### A.2 相対論的ビーミング

#### 式 A.4、式 A.5 で u = u' = c とすると、光の光行差の式を得る。

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(\cos \theta' + \frac{v}{c}\right)} \tag{A.6}$$

$$\cos\theta = \frac{\cos\theta' + \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}\cos\theta'} \tag{A.7}$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta'\right)} \tag{A.8}$$

 $K' 系で \theta' = \pi/2$  に放射された光について考えると、

$$\tan \theta = \frac{c}{\gamma v} \tag{A.9}$$

$$\cos\theta = \frac{v}{c} \tag{A.10}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\gamma} \tag{A.11}$$

のようになる。放射源が相対論的速度で運動している場合を考えると、 $\gamma \gg 1$ となり  $\theta$  は非常 に小さくなるので、式 A.11 から、

$$\theta = \frac{1}{\gamma} \tag{A.12}$$

となる。つまり、K系で等方的に放出された放射をK系で観測すると、全放射がハーフアン グル1/7の円錐内に集められ、前方に集中して放射されているように見える。これが相対論的 ビーミング効果である。



図 A.2 K'系での等方的な放射とK系での相対論的ビーミング

### 付録 B

# フェルミ加速



衝撃波面

図 B.1 フェルミ加速の概念図。衝撃波面を何度も粒子が往復することにより加速されていく。

運動量の大きさ P、エネルギー E、速度  $v = pc^2/E$ の粒子が、衝撃波面の上流と下流を往 復する過程を考える。下流から上流へ戻るためには、粒子の速度は流体の速度よりも大きくな くてはならない。流体の速度は光速に比べて小さいとし、V/cの1次の範囲で考える。

図 B.1 のように粒子が衝撃波面を角度  $\theta^+$  で上流から下流に横切るとする。粒子の物理量は

座標系によって異なるので、上流の流体と共に運動する系から見た場合には添え字 u、下流の 流体とともに運動する系から見た場合には添え字 d をつけ、衝撃波の静止系で見た場合には添 え字をつけないとする。

衝撃波の静止系と上流との間のローレンツ変換は

$$\begin{pmatrix} \frac{E^u}{c^u}\\ p^u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \frac{V}{c}\\ -\gamma \frac{V}{c} & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{E}{c}\\ P\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
(B.1)

と書け、 $\gamma \sim 1$ と近似すると

$$E^u = E - V_1 p \cos \theta^+ \tag{B.2}$$

$$E^d = E - V_2 p \cos \theta^+ \tag{B.3}$$

である。

次に、下流で散乱されて上流に戻るときに衝撃波面を角度  $\theta^-$  で横切るとする。このとき、 散乱は下流の流体の静止系でエネルギー保存が成り立つので、衝撃波の静止系で測ると p、Eが p'、E' に変化する。よって、同様に、

$$E^d = E' - V_2 p' \cos \theta^- \tag{B.4}$$

$$E'^{u} = E' - V_1 p' \cos \theta^{-} \tag{B.5}$$

の関係が成り立つ。Eに対する散乱後のエネルギーE'は、粒子の速度vを一定として、

$$\frac{E'^{u}}{E^{u}} = \frac{E'^{d}}{E^{u}} = \frac{(1 - \frac{V_{1}v}{c^{2}}\cos\theta^{-})(1 - \frac{V_{2}v}{c^{2}}\cos\theta^{+})}{(1 - \frac{V_{2}v}{c^{2}}\cos\theta^{-})(1 - \frac{V_{1}v}{c^{2}}\cos\theta^{+})}$$
(B.6)

である。ここでは、 $V \ll v$ を考えているので、粒子の角度分布は等方であると考えることができる。 $\cos \theta^+$ の期待値は

$$<\cos\theta^{+}> = \frac{\int_{0}^{\varphi}\cos^{2}\theta\sin\theta\,d\theta}{\int_{0}^{\varphi}\cos\theta\sin\theta\,d\theta} = \frac{\frac{1}{12}\int_{0}^{\varphi}\sin3\theta\,d\theta}{\frac{1}{4}\int_{0}^{\varphi}\sin2\theta\,d\theta}$$
$$= \frac{\frac{1}{12}\lim_{\varphi\to2\pi}(1-\cos3\varphi)}{\frac{1}{4}\lim_{\varphi\to2\pi}(1-\cos2\varphi)} = \frac{2}{3}$$
(B.7)

となり、 $\cos \theta^- = \cos(\pi - \theta^+) = -\cos \theta^+$ から、

$$\langle \cos \theta^{-} \rangle = -\frac{2}{3} \tag{B.8}$$

である。往復によるエネルギー変化の期待値は、

$$\frac{E'^{u}}{E} = \frac{\left(1 + \frac{V_1 v}{c^2} \frac{2}{3}\right)\left(1 - \frac{V_2 v}{c^2} \frac{2}{3}\right)}{\left(1 + \frac{V_2 v}{c^2} \frac{2}{3}\right)\left(1 - \frac{V_1 v}{c^2} \frac{2}{3}\right)}$$
(B.9)

となる。*V*/*c*の1次の範囲で考えると、

$$\frac{E'^{u}}{E} \sim \frac{1 + \frac{2}{3}(\frac{V_{1}v}{c^{2}} - \frac{V_{2}v}{c^{2}})}{1 - \frac{2}{3}(\frac{V_{1}v}{c^{2}} - \frac{V_{2}v}{c^{2}})} \sim \left\{1 + \frac{2}{3}\frac{v}{c}\left(\frac{V_{1}}{c} - \frac{V_{2}}{c}\right)\right\} \left\{1 + \frac{2}{3}\frac{v}{c}\left(\frac{V_{1}}{c} - \frac{V_{2}}{c}\right)\right\}$$
$$= 1 + \frac{4}{3}\frac{v}{c}\left(\frac{V_{1}}{c} - \frac{V_{2}}{c}\right) + \partial(2) = 1 + \frac{4}{3}\frac{(V_{1} - V_{2})v}{c^{2}}$$
(B.10)

となり、エネルギーが増加することが分かる。

 $\Delta E = E' - E = v\Delta p$ の関係を使うと運動量の大きさの増加量は  $E = c^2 p/v$ 、  $E' = c^2 p'/v$ を代入して、 $v\Delta p = c^2 (p' - p)/v$ であり、B.10 式より、

$$p' = p + \frac{4}{3} \frac{(V_1 - V_2)}{c^2} vp \tag{B.11}$$

であるから、

$$\Delta p = \frac{c^2}{v^2} \left( \frac{4}{3} \frac{(V_1 - V_2)}{c^2} v p \right) = \frac{4(V_1 - V_2)}{3v} p = \frac{4}{3} \frac{(V_1 - V_2)p}{v}$$
(B.12)

となる。粒子が相対論的なエネルギーを持つ場合は v = c、E = pcなので、運動量やエネル ギーの増加量は元の運動量やエネルギーに比例する。1回往復後の粒子の運動量は、

$$\Delta p = \frac{4}{3} \frac{(V_1 - V_2)}{c} p \tag{B.13}$$

だけ増加するので、 n 回往復を考えると、

$$p_{1} = p_{0} + \Delta p_{0} = p_{0} \left\{ 1 + \frac{4}{3} \frac{(V_{1} - V_{2})}{c} \right\}$$

$$p_{2} = p_{1} + \Delta p_{1} = p_{1} \left\{ 1 + \frac{4}{3} \frac{(V_{1} - V_{2})}{c} \right\} = p_{0} \left\{ 1 + \frac{4}{3} \frac{(V_{1} - V_{2})}{c} \right\}^{2}$$

$$\vdots$$

$$p_{n} = p_{n-1} + \Delta P_{n-1} = p_{n-1} \left\{ 1 + \frac{4}{3} \frac{(V_{1} - V_{2})}{c} \right\} = p_{0} \left\{ \frac{(V_{1} - V_{2})}{c} \right\}^{n} \quad (B.14)$$

となる。 
$$\lim_{a \to \infty} \left\{ \left( 1 + \frac{1}{a} \right)^a \right\}^{b/a} = e^{b/a}$$
 より、  $\frac{1}{a} = \frac{4(V_1 - V_2)}{3c}$  とおくと、  
 $p_n = \left\{ 1 + \frac{4(V_1 - V_2)}{3c} \right\}^n = \left[ \left\{ 1 + \left( \frac{1}{a} \right) \right\}^a \right]^{a/n}$   
 $= \exp\left( \frac{n}{a} \right) = \exp\left\{ \frac{4n(V_1 - V_2)}{3c} \right\}$  (B.15)

のように往復回数に対して指数関数的に増加する。粒子が非相対論的な場合には $E = mc^2$ 、 p = mvとなるため、運動量の増加は一定となり、以下のようになる。

$$\Delta p = \frac{4}{3} (V_1 - V_2) m = \text{const}$$
  

$$\to p_n = p_0 + nmc \left\{ \frac{4(V_1 - V_2)}{3c} \right\}$$
(B.16)

実際には途中で逃げる粒子も存在する。下流の流体は速度  $V_2$  で衝撃波面から離れていくの で、加速を受ける粒子も平均速度  $V_2$  で流れていく事になる。単位時間、単位面積あたりに上 流から下流へ横切る粒子数は、数密度を N として Vv/4 であるが、逃げていく粒子は  $NV_2$  と

なる。これは、粒子の逃げる割合が  $P_{esc} = 4V_2/v$  ということを意味する。 $1 - P_{esc}$  は再び下流から衝撃波面を横切り上流へと戻る粒子の割合であるから、粒子が相対論的な場合にn回往復する割合は、

$$P(>n) = \left(1 - \frac{4V_2}{c}\right)^n \approx \exp\left(-4n\frac{V_2}{c}\right) \tag{B.17}$$

となる。運動量がpより大きい粒子数N(> p)は式 B.15、B.17 から、

$$P(>n) \approx \exp\left(-4n\frac{V_2}{c}\right) = \exp\left\{-4nc\frac{V_2}{c} \cdot \frac{(V_1 - V_2)}{3V_2} \cdot \frac{3V_2}{(V_1 - V_2)}\right\}$$
$$= \exp\left\{-4nc\frac{(V_1 - V_2)}{3c} \cdot \frac{3V_2}{(V_1 - V_2)}\right\} = \left\{\exp\left(4n\frac{(V_1 - V_2)}{3c}\right)\right\}^{-\frac{3V_2}{(V_1 - V_2)}}$$
$$= \left(\frac{p_n}{p_0}\right)^{-\left(\frac{3V_2}{(V_1 - V_2)}\right)}$$
(B.18)

となり、

$$P(>n) \propto p^{-\frac{3V_2}{(V_1 - V_2)}} = p^{-\mu + 1}$$
 (B.19)

のようなベキ関数のスペクトルが得られる。つまり、ある一定以上の運動量を持つ粒子の分布 N(p) は  $p^{-\mu}$  に比例する。スペクトル指数は、

$$\mu = \frac{3V_2}{V_1 - V_2} + 1 = \frac{r+2}{r-1} \tag{B.20}$$

となる。これは、衝撃波の圧縮比 r のみで決まる。極限まで圧縮された衝撃波では r = 4 となるので  $\mu = 2$  となり、

$$N(>p) \propto p^{-2} \tag{B.21}$$

である。

### 付録C

### 有効面積と検出器の性能

4.4 節の結果から、プラスチックシンチレータには深くテーパー加工を施したほうが有利 であることが分かっている。プラスチックを読み出す R1840-12s の光電面の大きさである直 径 46 mm に収束するテーパー加工で、有効面積を変化させた場合の検出器の性能について調 べる。

#### C.1 シミュレーションによる検証

プラスチック有効面積の直径を 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 cm と変化させた場合について、シミュレーションから得られる  $\eta$ 、M、 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ の結果を図 C.1 に示す。

検出効率 $\eta$ 

プラスチックの有効面積が大きくなるにつれて、ηは小さくなる。これは、プラスチックが 大きくなるにつれて、入射光子に対するプラスチックの厚さが薄くなる面積が大きくなるため にプラスチックで散乱せずにそのまま抜けてしまう光子の割合が増えること、プラスチックか らの散乱光子が見込む CsI(Tl) が小さくなることによって説明できる。

モジュレーションファクタ M

*M*は、プラスチックが大きくなるにつれてほぼ一定値に収束している。プラスチックが大きくなると、90°方向に散乱した光子の検出される割合が大きくなり、*M*は大きくなると考えられる。しかし、ある程度の大きさ以上では、プラスチック内での多重散乱や自己吸収によって偏光情報が失われることによって、ほぼ一定になると考えられる。

 $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ 

プラスチックの有効面積 S を考慮し、S を含めた検出器の性能を比較するために  $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$ を計算する。 $\eta$  が小さくなる効果よりも S が大きくなる効果によって、プラスチックが大きくなるにつれて  $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$  は大きくなる。



図 C.1 プラスチックの有効面積を変化させたときの入射エネルギーに対する (a1)  $\eta$ 、 (b1) M、 (c1)  $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$  と、プラスチックの直径と 100 keV における (a2)  $\eta$ 、 (b2) M、 (c2)  $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$  の関係である。プラスチックが大きくなるにつれて、 $\eta$  は小さくなり、M は ほぼ一定値になる。有効面積 S を考慮すると、S が大きくなる効果によって  $M(\eta S)^{\frac{1}{2}}$  は大 きくなる。

### 付録 D

### 検出効率

#### D.1 質量吸収係数

光子が物質に入射すると相互作用を行う。物質に対する光子の透過率は式 D.2 のように表され、質量吸収係数  $\sigma$  [cm² g⁻¹] は以下のように書ける。

$$\sigma = \sigma$$
 (光電効果) +  $\sigma$  (コンプトン散乱) +  $\sigma$  (電子対生成) (D.1)

CsI(Tl) とプラスチックの質量吸収係数を図 D.1 に示す。図 D.1 左図が CsI(Tl)、図 D.1 右図 がプラスチックの質量吸収係数である。図中の緑が光電効果、赤がコンプトン散乱、青は電子 対生成、ピンクはその和である。



図 D.1 CsI(Tl) の質量吸収係数 (左図) とプラスチックの質量吸収係数 (右図) である。緑 は光電効果、赤はコンプトン散乱、青は電子対生成、ピンクはその和である。

#### D.2 Csl(TI) とプラスチックの検出効率

物質に対する光子の透過率は、入射放射線強度  $I_0$ 、透過放射線強度 I、物質の密度 ho  $[
m g\,cm^{-3}]$ 、 質量吸収係数  $\sigma$   $[
m cm^2~g^{-1}]$ 、厚さ l [
m cm] とすると、

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\rho\sigma l} \tag{D.2}$$

となる。物質中で相互作用を起こす割合を検出効率とすると、

$$1 - e^{-\rho\sigma l} \tag{D.3}$$

と書くことができる。CsI(Tl)の密度 4.51  $[g cm^{-3}]$ 、プラスチック (NE102A) の密度 1.03  $[g cm^{-3}]$ から、質量吸収係数を使って計算した CsI(Tl) とプラスチックの検出効率を図 D.2 に示す。左図は CsI(Tl)の厚さが 3 mm(黒)、5 mm(赤)、10 mm(緑)の場合の検出効率である。右図はプラスチックの高さが 5 cm(黒)、6 cm(赤)、7 cm(緑)の場合の検出効率である。



図 D.2 CsI(Tl)の検出効率 (左図) とプラスチックの検出効率 (右図) である。CsI(Tl)の検出効率は、厚さが3 mm(黑)、 $5 \text{ mm}(\overline{\textbf{m}})$ 、10 mm(縁)のプロットである。プラスチックは、高さが5 cm(黑)、 $6 \text{ cm}(\overline{\textbf{m}})$ 、7 cm(縁)のプロットである。

### 付録 E

### 散乱位置検出型検出器による M

ここでは、散乱体を分割して入射光子の散乱位置を検出する方法を用いた場合のモジュレー ションファクタについて示す。入射光子の散乱位置情報が得られることで入射光子の散乱角度 を正確に定義することができるため、*M* が大きくなる。

60 分割した直径 100 mm の円柱型プラスチックの周囲を 12 枚の CsI(Tl) で囲むモデルで シミュレーションを行う。プラスチックで多重散乱するイベントは、コインシデンスにより 落とすことができると考えられるため、多重散乱イベントは取り除く。シミュレーションに 用いたモデルを図 E.1 に示す。100 keV、100% 偏光の光子をプラスチックの全面に入射した とき、プラスチックを 60 分割した場合に得られるモジュレーションカーブと、プラスチック を分割しない場合のモジュレーションカーブを図 E.2 に示す。それぞれのモジュレーション ファクターは、プラスチック 60 分割モデル (黒) が  $M_{60} = 0.586$ 、分割しないモデル (赤) が  $M_1 = 0.393$  となった。この結果から明らかに散乱位置を検出できる方が偏光観測に有利で ある。

実際に散乱位置を検出するためには、分割したそれぞれの散乱体を読み出すことが必要と なるため、PMT をたくさん使用するか、H8500(浜松ホトニクス製)のようなマルチアノード PMT を使用することになる。マルチアノード PMT は1台の PMT の受光面が分割されてお り、位置検出が可能な PMT である。しかし、H8500 は耐震設計ではないため衛星搭載目的で 使用することができない。衛星搭載モデルでは、幾何学的対称性を持った単純なモデルで設計 を行っている。





図 E.2 散乱位置検出方法によるモジュレーションカーブ。プラスチックを 60 分割した場 合、コインシデンスによって多重散乱イベントを落とすことができると考えられるため、多 重散乱イベントは取り除いている。

### 付録 F

# Csl(Tl)のスペクトル補正

X 線発生装置の偏光度にはエネルギー依存性がある。したがって、偏光測定によって CsI(Tl) で得られるスペクトルをエネルギー毎に積分することによってエネルギー毎のモジュ レーションを求めることができるはずである。しかし、CsI(Tl) 12 系統のエネルギー分解能が 悪いこと、正確なエネルギー較正ができていないことによって、何らかの補正を行うことが必 要である。

旧偏光検出器モデルにおいて、プラスチックの直径4 cm に正面入射した場合の偏光測定に ついて、CsI(Tl) で得られるスペクトルを補正することによってエネルギーごとのモジュレー ションを求める方法を検討する。



#### F.1 補正しない場合

補正しない場合に、それぞれのエネルギー範囲で積分したときのモジュレーションカーブ を図 F.2 に示す。スペクトル全体を積分した 0-200 keV ではきれいなモジュレーションカー ブになっているが、エネルギー範囲を区切って 0-60 keV、60-200 keV で積分した場合にはモ ジュレーションカーブの形が崩れてしまう。しかし、強引にサインフィットを行いモジュレー ションの値を求めると、0-60 keV よりも 60-200 keV の方が大きくなり、0-200 keV ではそれ らの平均値になっていることから、傾向は正しいように思われる。



#### F.2 補正した場合

CsI(Tl) 12 系統のリニアリティを使用してチャネルからエネルギーに変換すると、変換後 のスペクトルのピークチャネルが合わないことから、リニアリティに問題があるのではないか と考えた。そこで、チャンネルレンジのスペクトルのピークをフィットし、CsI(Tl) 1 系統の ピークに合わせてからエネルギーに変換した。

基準となる CsI(Tl) 1 系統のピークチャンネルを p とする。他の CsI(Tl) のピークチャンネルを  $p_x$  として、

$$ch'_x = ch_x \times \frac{p}{p_x}$$
 (F.1)

のように、それぞれのチャンネル  $ch_x$  を  $ch'_x$  に変換し、その後、基準となる 1 系統のリニア リティを使用してエネルギーに変換するという処理を行った。

補正を行った場合に得られるそれぞれのエネルギー範囲のモジュレーションを図 F.3 に示 す。また、それぞれのエネルギー範囲で積分したときのモジュレーションカーブを図 F.4 に 示す。補正をしない場合と比較すると、モジュレーションカーブの形が整っているように見え る。0-30 keV、80-200 keV では光子統計が悪いために形が崩れていると考えられる。90keV 以下については、高エネルギー側の方がモジュレーションが大きくなっていることから、ある 程度の傾向は見えるが、今後も補正方法を検討する必要がある。





# 謝辞

修士論文作成にあたり、お世話になった先生方、友人に感謝の意を述べたいと思います。

指導教官の村上敏夫先生、物理を通して物事を理解するということを学ばせていただきました。また、物理以外のお話はとても興味深いものでした。3年間で経験したことはこれから先で役に立つと思います。ありがとうございました。

藤本龍一先生のライビキのゼミでは、理解できたときに物理がとても楽しくなりました。修 士論文作成にあたり、的確な指摘をしていただき、ありがとうございました。

米徳大輔先生には実験の基本的なことから丁寧に教えていただきました。行き詰まったと き、分からないことがあるときには適切な指導をしていただきました。また、修士論文につい ての指導をしていただき、ありがとうございました。

同期の喜田村孝くん、田辺幸子さん、横田聡くん。喜田村くんの集中力にはいつも感心して いました。私にとって、何かと頼りになる存在でした。田辺さんのおかげで、行事がたくさん あって、研究室生活を楽しく過ごすことができました。横田くんの面倒見の良さ、努力家なと ころを見習いたいと思います。生徒から頼られる先生になってください。みんなと3年間一緒 に過ごすことができて良かったです。本当にありがとう。

M1 のみなさん。江村尚美さんには実験とシミュレーションで助けてもらいました。仕事が 早くて、頼りになる存在でした。児玉芳樹くんにはたくさん実験をしてもらいました。面倒な ことも手伝ってくれて、ありがとう。児嶌佑介くん、頼まれたら断れないやさしい性格で、こ れからもがんばってください。梨本拓郎くん、新しい装置を次々と完成させてすごいと思いま す。良い先生になってください。いろいろお世話になりました。ありがとう。

4年生の藤本大史くん、実験を手伝ってくれてありがとう。その他の4年生のみなさん、短い間でしたがいろいろお世話になりました。ありがとう。

最後になりましたが、学生生活を支えてくれた家族に感謝の意を述べたいと思います。あり がとうございました。

### 参考文献

- [1] 増井宏樹「衛星搭載用ガンマ線バースト偏光検出器の開発」 金沢大学 2006 修士論文
- [2] Band, D.L. et al., 1993, ApJ 413 281
- [3] 小平裕宣「人工衛星搭載用ガンマ線バースト偏光検出器の基礎開発」 金沢大学 2007 修 士論文
- [4] Lazzati, D., 2003, astro-ph 0312331v1
- [5] Waxman, E., 2003, Nature 423 338
- [6] Lazzati, D., Rossi, E., Ghisellini, G. & Rees, M.J., 2003, astro-ph 0309038v3
- [7] Rybicki, G.B., Lightman, A.P., 1979, WILEY INTER SCIENCE, Radiative Processes in Astrophysics
- [8] KNOLL, F.C., 2001, 日刊工業新聞社, 放射線計測ハンドブック 第3版
- [9] 井上陽子「撮像型X線検出器の基礎開発実験研究」 山形大学 2000 修士論文
- [10] 宮本八太郎「ガンマ線バースト偏光計 GAPOM 計画 散乱型硬 X 線偏光計 八角形シ ンチレータの性能」 日本大学 2003 修士論文
- [11] Gruber, D.E. et al., 1999, ApJ 520, 124-129
- [12] Rees, M.J., Meszaros, P., 1992, MNRAS 258 L41
- [13] Piran, T., 1998, Phys.Rept. 314 575
- [14] 米徳大輔「ガンマ線バーストに伴う X 線残光と鉄輝線の観測」 東京工業大学 2001 修士 論文
- [15] 文部科学省 国立天文台「理科年表」
- [16] 日本アイソトープ協会「アイソト プ手帳」
- [17] 三谷夏子「RHESSI 衛星による太陽フレアの硬 X 線撮像スペクトル解析」東京大学 2005 修士論文
- [18] 佐藤文人「気球搭載用硬 X 線偏光度検出器の基礎性能」 山形大学 2003 修士論文
- [19] 浅村和美「MSGC からの多チャンネル読み出しシステムの構築」 山形大学 2000 修士 論文